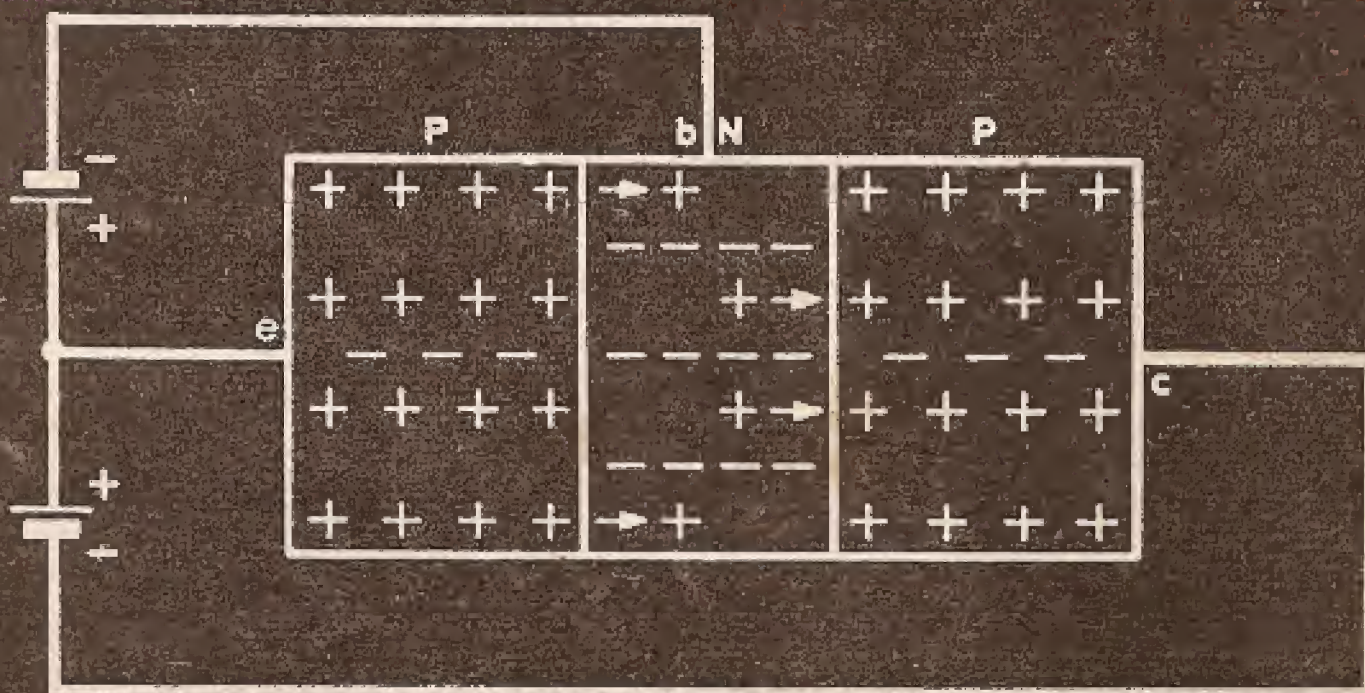




• tehnica electronică •



Colecția radio și televiziune ● 133

CLEMENT BROWN

Editura tehnică

TRANZISTOARE

Întrebări și răspunsuri

**Clement
Brown**

TRANZISTORE

Întrebări și răspunsuri

Traducere din limba engleză

ॐ



Editura tehnică
București — 1976

București — 1976

C o n t i n u t

1. Semiconductoarele 5
2. Tranzistorul 16
3. Circuite cu tranzistoare 31
4. Tranzistoarele în radioreceptoare 38
5. Alte dispozitive semiconductoare 65
6. Tranzistoarele în industrie 74
7. Alte utilizări ale dispozitivelor semiconductoare 92
8. Depanarea echipamentelor tranzistorizate 105

1

Semiconductoarele

Ce este un tranzistor?

Este un dispozitiv care poate amplifica semnale electrice și îndeplinește și alte funcții în circuitele electrice. Deși nu este un înlocuitor direct al tubului electronic, în cele mai multe cazuri tranzistorul poate să preia toate funcțiile realizate anterior cu tuburi și de asemenea face posibile noi realizări pentru care tubul electronic nu poate fi luat în considerație.

Tranzistorul este realizat dintr-un material *semiconductor*: cel mai simplu și mai obișnuit tip de tranzitor folosit constă în principal dintr-un „sandvici” de trei straturi de astfel de material. Acest ansamblu este montat într-o capsulă prevăzută cu fire de conexiune, iar dispozitivul astfel realizat este foarte mic față de tubul electronic. O comparație a dimensiunilor lor este arătată în fig. 1.

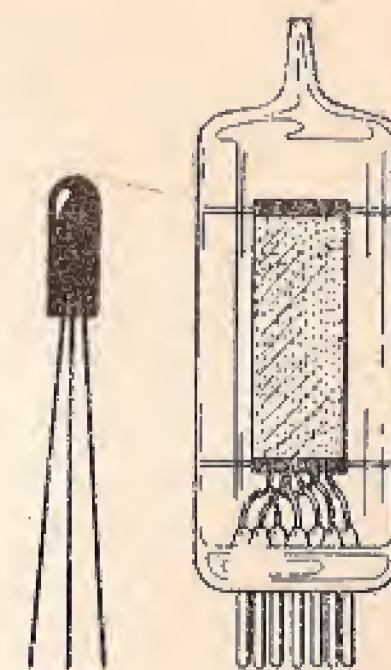


Fig. 1. Comparație între un tranzistor de semnal mic obișnuit și un tub electronic: aceste două dispozitive realizează funcții similare.

Semiconductoarele și proprietățile lor

Un număr mare de materiale, intermediare între conductoare și izolatoare, sînt reunite sub numele de semiconductoare. Cele mai multe metale conduc electricita-

tea rapid (instantaneu) și aceasta se datorește prezenței în interiorul lor a unui număr foarte mare de electroni. Aceștia (electronii liberi) sînt negativi din punct de vedere electric. Ei se mișcă sub influența unei tensiuni electrice și joacă rolul de purtători de curent. Pe de altă parte, în izolator (spre exemplu mica, sau unul din materialele plastice folosit în electrotehnică) există puțini electroni liberi care să se miște, și prin urmare nu există curent — sau foarte puțin — cînd se aplică o tensiune electrică. Existența (posibilitatea de obținere) electronilor liberi depinde de structura atomică a materialului, poziția relativă a atomilor și de temperatură. Foarte important este faptul că un număr mic de atomi „străini” pot influența proprietățile electrice a unor materiale. Aceste materiale sînt semiconductoarele, dintre care cele mai importante, în fabricarea actuală a tranzistoarelor, sînt germaniul și siliciul. În general, semiconductoarele conduc mult mai rapid cînd temperatura lor crește; reciproc este adevărat numai pentru conductoarele bune, cum este cuprul.

Cum funcționează germaniul ca un semiconductor?

Germaniul este un element metalic și la fel ca toate semiconductoarele este un cristal, cu atomii aranjați într-un fel denumit rețea cristalină. Datorită acestei structuri materialul va putea fi tăiat mai ușor după unele direcții de cît altele (întocmai ca diamantul ce se taie după anumite direcții). În fig. 2 se arată o rețea perfectă desenată în două dimensiuni.

Atomul de germaniu are 32 de electroni. Patru dintre aceștia formează un inel mai îndepărtat în jurul atomului și sînt la dispoziția legăturilor de valență sau chimice. Acești electroni, numiți *electroni de valență*, sînt

mai puțin strîns legați de atom decît ceilalți electroni ai atomului. În structura cristalină a germaniului acești electroni de valență formează *legături covalente*, așa cum se arată în fig. 2, cu electronii de valență ai atomului alăturat, fiecare atom fiind echidistant de cei patru atomi vecini și fiecare electron de valență al unui atom formînd o pereche — legătură covalentă — cu un electron de valență din atomul vecin.

Cînd un electron devine liber prin ruperea legăturii covalente și prin urmare poartă o sarcină electrică, și de asemenea cînd un atom de germaniu din rețeaua cristalină este înlocuit cu un atom din alt element (acest fapt este cunoscut sub numele de *dopare*) în rețeaua cristalină apar imperfecțiuni). Într-un cristal perfect la temperatura de zero absolut (-273°C) toate legăturile covalente sînt complete, dar cînd temperatura crește unii electroni din legăturile covalente capătă o energie suficientă pentru a părăsi legătura și a deveni liberi.

Locurile vacante rămase în legătură sînt numite *goluri*. Această situație este arătată în fig. 3. Un electron liber devine un purtător de sarcină electrică negativă, în timp ce un gol devine un purtător de sarcină pozitivă.

Germaniul pur are un număr de goluri egal cu cel al electronilor liberi, dar se pot adăuga impurități prin dopare în scopul modificării acestei situații. Prin controlul dopării se poate asigura o conductivitate mai mare în timp ce rețeaua este păstrată.

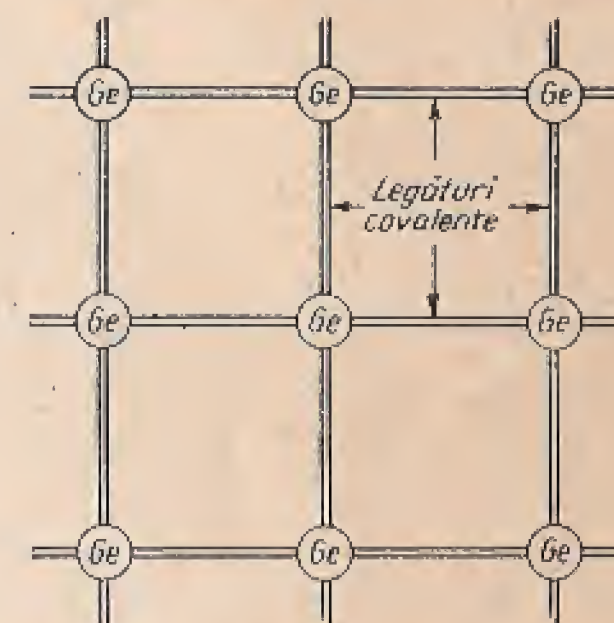


Fig. 2. Structura rețelei cristaline a germaniului, la temperatura zero absolut, în care se evidențiază legăturile covalente (prin doi electroni) formate între atomii vecini.

Dacă un atom cu cinci electroni de valență (spre exemplu antimoniu) se introduce în rețea, se obține un electron liber (vezi fig. 4). Chiar la temperatura obișnuită a camerei acest electron are suficientă energie să se deplaseze prin rețeaua de germaniu ca un purtător

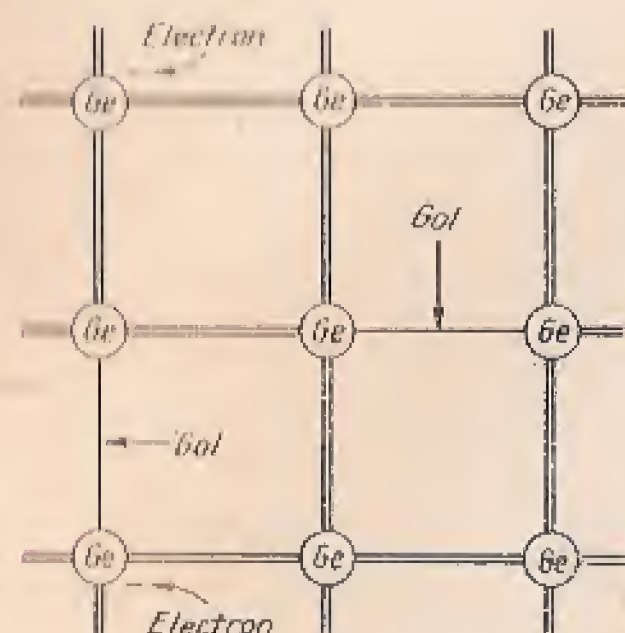


Fig. 3. Rețeaua cristalină a germaniului la temperatura camerei, în care se observă prezența electronilor liberi și a golurilor la temperaturi normale.

de sarcină negativă. Atomul de impurități este numit *donor*: el donează un electron pentru formarea curentului. Se spune că impuritatea se numește de tip *n* (*n* se folosește pentru negativ), iar germaniul dopat cu atomi donori este deci cunoscut ca germaniu de tip *n*.

În rețeaua cristalină se poate introduce un atom cu trei electroni de valență (spre exemplu indiu) și în acest caz apare un gol așa cum se arată în fig. 5.

Acest gol va captura un electron ce trece prin apropierea sa și aceasta va conduce la formarea unui alt gol

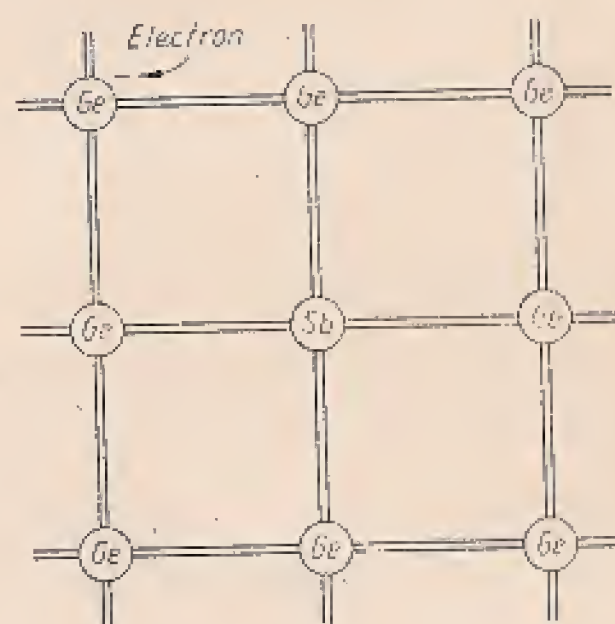


Fig. 4. Rețeaua cristalină a germaniului în care este cuprins un atom de antimoniu (Sb) cu electronul liber donat materialului de către atomul donor de antimoniu în momentul formării legăturilor covalente cu atomii de germaniu vecini.

care va fi întâlnit de către alt electron. Astfel există un proces continuu de mișcare a purtătorilor de sarcină pozitivă (a golurilor). Atomii de impurități trivalenți sunt numiți *acceptori*; ei acceptă un electron care, umple golul. Impuritatea este numită de tip *p* (*p* pentru pozitiv), și în acest caz germaniul dopat cu atomi acceptori este denumit germaniu de tip *p*.

În final, pe lângă acești purtători de sarcini obținuți prin introducerea controlată de impurități, se pot obține electroni liberi prin ionizare — spre exemplu prin efectul temperaturii sau tensiunii.

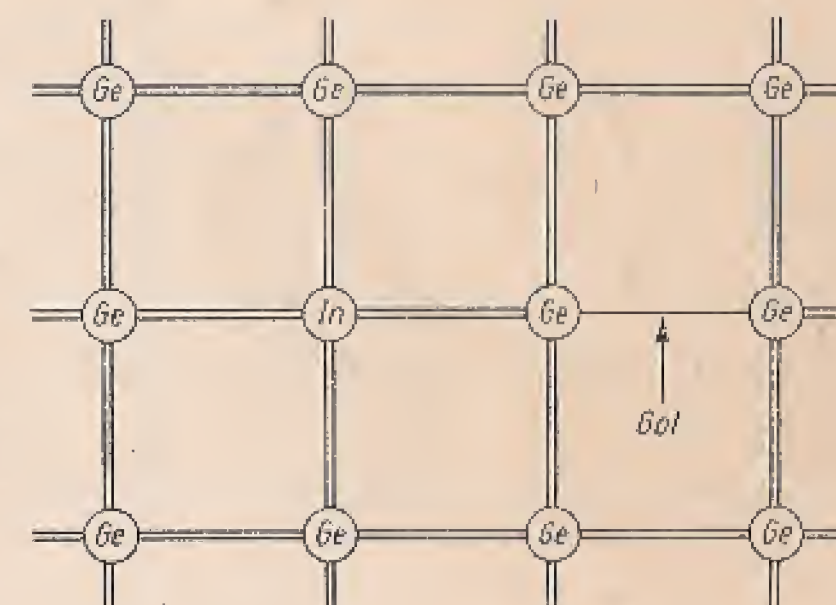


Fig. 5. Rețeaua cristalină a germaniului în care este cuprins un atom de indiu (In) cu golul creat în rețea de atomul trivalent acceptor de indiu.

Ce este o diodă redresoare?

Dacă se aplică o tensiune alternativă unei joncțiuni formată de un semiconductor de tip *n* și un semiconductor de tip *p*, bariera de tensiune prezentată de joncțiune curgerii de purtători de sarcină dintr-o parte în alta, va fi alternativ îngustă sau largită. Cu alte cuvinte, rezistența joncțiunii opusă curgerii curentului depinde de polaritatea și valoarea tensiunii ce i se aplică. Se obține astfel o acțiune de redresare, iar o diodă bazată pe această acțiune este numită diodă cu joncțiune redresoare. Notați că joncțiunea reprezintă o zonă de tranziție de la semiconductorul de tip *p* la semiconductorul de tip *n* în interiorul unei structuri cristaline continue.

În câteva cazuri este folosită de asemenea dioda semiconductoră cu contact punctiform. Purtătorii de sarcină dintr-un semiconductor tind să se concentreze la suprafață: o zonă de suprafață a electronilor și o zonă alăturată de atomi donori formează o barieră asemenea celei a joncțiunii menționate în paragraful precedent. Dacă se aplică o tensiune alternativă între suprafață și oricare alt punct are loc fenomenul de redresare. Un terminal este incorporat în cristalul de germaniu iar celălalt, ca o „mustață de pisică“, este asamblat pe suprafață.

Contactul punctiform are efectul unei concentrări a câmpului electric astfel că are loc o creștere a curentului electric.

Ce se înțelege prin polarizare directă și inversă?

Dacă se aplică o tensiune continuă de-a lungul unei joncțiuni $p-n$ (vezi fig. 6, a) cu negativul pe secțiunea p și pozitivul pe secțiunea n , se spune că joncțiunea este

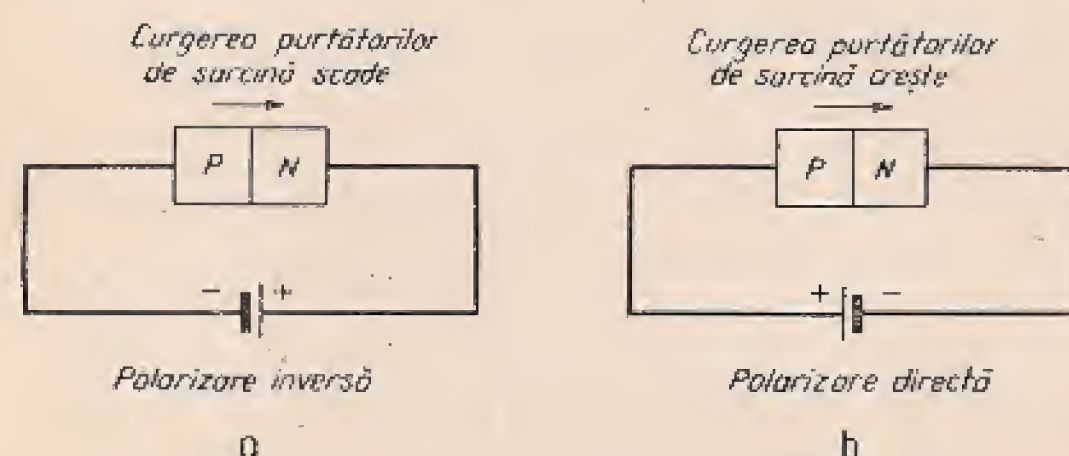


Fig. 6. Polarizarea inversă a și directă b a unei joncțiuni semiconductoră pn .

polarizată invers, trecerea purtătorilor de sarcină prin joncțiune fiind întârziată. Pe de altă parte dacă se inversează polaritățile tensiunii cu negativul pe secțiunea n și

pozitivul pe secțiunea p (vezi fig. 6, b) se spune că joncțiunea este *polarizată direct*, trecerea purtătorilor de sarcină prin joncțiune fiind crescută.

Ce înseamnă expresia „solid-state“?

Solid-state este termenul ce se aplică diodelor, tranzistoarelor și celorlalte dispozitive semiconductoră precum și tuturor echipamentelor realizate cu ele. Un dispozitiv în stare solidă — așa cum se explică în acest capitol — depinde de interacțiunea legăturilor electronice din structurile moleculare, care de asemenea sînt solide. Prin contrast tubul electronic este un dispozitiv termo-ionic în care electronii liberi se mișcă prin vid sau printr-un gaz.

Cum se obține germaniul?

Germaniul se obține pe două căi cu totul distincte. Una este obținerea din cantitatea de praf ce rezultă prin arderea cărbunelui Northumbrian, care conține 2% germaniu. Arderea cărbunelui reprezintă prima etapă a extracției, iar tirajul de praf conține cam 2 procente de germaniu. Minereurile de cupru din Congo și minereurile de zinc din Africa de sud-vest formează cealaltă sursă principală. Materialul extras astfel se trimite sub formă de bioxid de germaniu pentru fabricarea tranzistoarelor.

Se folosesc și alte materiale semiconductoră pentru fabricarea tranzistoarelor?

Siliciul capătă o importanță crescută în fabricarea diodelor semiconductoră, tranzistoarelor și altor dispozitive semiconductoră. Este unul din cele mai răspândite

elemente, dar cere o purificare mai mare decât germaniul pentru a putea fi folosit în fabricarea dispozitivelor semiconductoare. Ca și germaniul, este o substanță cristalină și are patru electroni de valență.

Care este principalul avantaj al siliciului?

Așa cum s-a menționat deja, numărul golurilor și electronilor liberi va crește, într-un material semiconductor datorită temperaturii, temperatura asigurând suficientă energie pentru a permite unor electroni să părăsească legăturile covalente și să devină liberi. Golurile și electronii liberi care iau naștere provoacă creșterea curenților nedoriti care se suprapun peste curentul dorit ce trece prin materialul semiconductor. Deoarece „groapa de energie” — energia necesară unui electron pentru a-și părăsi legătura și a deveni liber — este mai mare la siliciu decât la germaniu, rezultă că funcționarea dispozitivelor semiconductoare cu siliciu este mai puțin afectată de temperatură decât cele cu germaniu.

Un alt avantaj al siliciului îl constituie ușurința cu care se oxidează suprafața sa formînd un strat izolator de bioxid de siliciu. Acest fenomen este de o importanță majoră în fabricarea unor dispozitive semiconductoare, cuprinzînd circuitele integrate.

Germaniul are vreun avantaj particular?

Germaniul este afectat de temperatură mai mult decât siliciul datorită groapei de energie mai mică, iar această groapă de energie mai mică înseamnă că golurile au o mobilitate mai mare în germaniu. Datorită acestui fenomen dispozitivele semiconductoare cu germaniu pot

lucra la frecvențe mai mari decât cele cu siliciu. De asemenea aceasta înseamnă că ele pot fi polarizate cu tensiuni mai mici.

Ce se înțelege prin purtători „majoritari” și „minoritari”?

Așa cum am văzut, prin materialul semiconductor pot trece două tipuri de curenți. Unul cauzat de mișcarea electronilor, care transportă o sarcină electrică negativă (ei curg către borna pozitivă a bateriei) și rezultă un curent negativ și în al doilea rînd mișcarea golurilor, care reprezintă un curent pozitiv. Prin dopare, se poate crea un exces de electroni față de goluri sau invers. În cazul unui material de tip *p*, dopat cu impurități acceptoare, există un exces de goluri, cari se numesc în acest caz purtători majoritari. În cazul unui material de tip *n*, dopat cu impurități donoare, există un exces de electroni care în această situație se numesc purtători majoritari.

Cînd se polarizează direct o joncțiune *pn* purtătorii majoritari vor difuza prin joncțiune. Odată trecuți de joncțiune ei vor deveni purtători minoritari, formînd un curent de purtători minoritari. Acțiunea dispozitivelor semiconductoare se bazează în principal pe efectele polarizării joncțiunilor *pn* controlînd în acest mod curenții ce trec prin ele.

Ce se înțelege prin regiunea de sărăcire a joncțiunii?

Cînd se formează joncțiunea *pn* apare inițial o curgere a purtătorilor prin joncțiune — electronii din regiunea *n* sînt atrași prin joncțiune de sarcina pozitivă reprezentată de golurile din regiunea *p* și invers. Acest fenomen

are ca rezultat, așa cum se observă din fig. 7, apariția unei regiuni de fiecare parte a joncțiunii relativ săracă în purtători de sarcină. Această regiune se numește de sărăcire sau de golire. Odată formată, regiunea de sără-

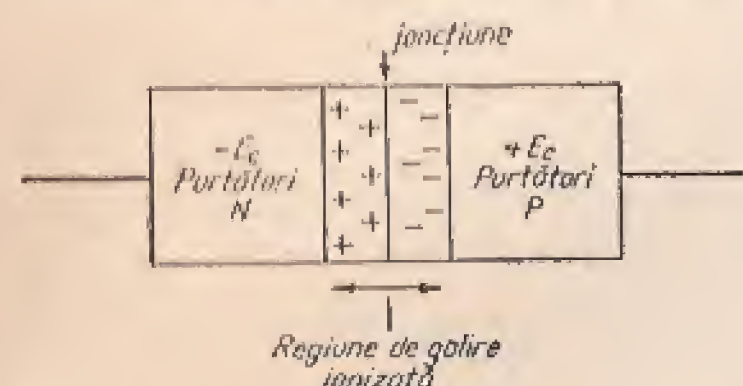


Fig. 7. Regiunea de golire a joncțiunii unui dispozitiv semiconductor pn. În regiunea de golire sînt prezenți puțini purtători de sarcină electrică.

Care este curba caracteristică a unei joncțiuni pn?

O curbă caracteristică reprezintă caracteristicile electrice ale unei joncțiuni pn. În fig. 8 se arată un exemplu. După cum se poate vedea, creșterea tensiunii directe —

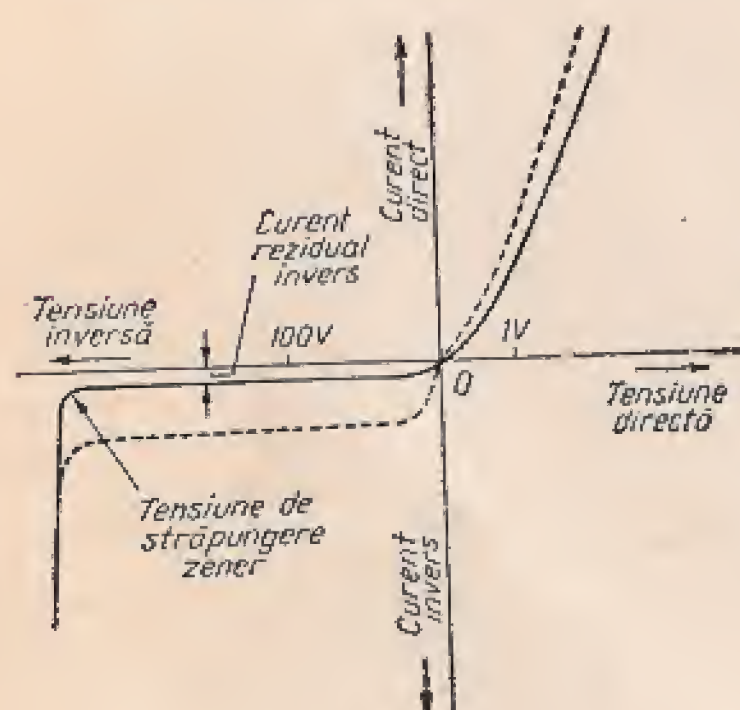


Fig. 8. Curbă caracteristică reprezentînd caracteristicile electrice ale unei joncțiuni pn. Curba punctată ilustrează efectul creșterii temperaturii asupra caracteristicilor. Curentul rezidual invers este determinat în principal de golurile și electronii liberi din regiunea de golire formați prin ionizare.

polarizare directă — are ca rezultat o creștere de curent. Polarizarea inversă nu provoacă apariția curentului pînă nu se atinge un punct critic, tensiunea de străpungere

zener, cînd apare brusc un curent de valoare ridicată care poate distruge joncțiunea. Înainte de atingerea acestui punct, prin joncțiune trece un curent invers de valoare mică numit curent rezidual invers. Acesta este determinat de ionizare — efectul temperaturii. Curba punctată indică schimbarea ce are loc în caracteristici — creșterea curentului rezidual și a curentului direct — determinată de creșterea temperaturii.

Ce se înțelege prin tranzistoare bipolare și unipolare?

Tranzistoarele a căror funcționare depinde de goluri și electroni așa cum s-a arătat mai sus, se numesc tranzistoare bipolare deoarece folosesc purtători de sarcină de două polarități. Unele tipuri de tranzistoare mai speciale — tranzistoare cu efect de câmp — funcționează folosind numai purtători majoritari și în consecință se numesc tranzistoare unipolare.

Prin ce diferă tranzistorul de diodă?

Tranzistorul este un dispozitiv mult mai complex, el presupune două joncțiuni aranjate spate în spate (vezi fig. 9). Primele tranzistoare au fost de construcție cu

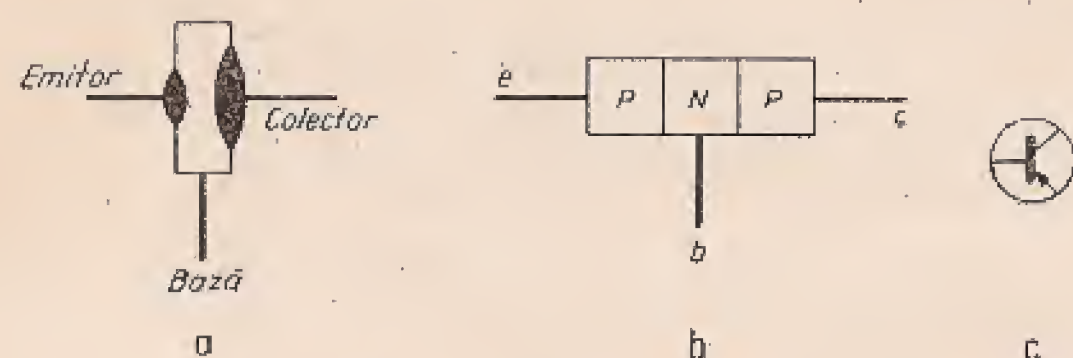


Fig. 9. O formă simplă a unui tranzistor cu joncțiune a, diagramă bloc echivalentă b și simbol de circuit c.

contact punctiform, dar acestea au fost înlocuite de către tranzistoarele cu joncțiuni, care vor fi principalul tip ce va fi descris aici.

Tranzistorul este o invenție recentă?

Detectoarele cu cristal se foloseau înainte ca tuburile electronice să fie inventate (1904), și este bine cunoscut că galena și alte cristale erau folosite de către experimenterii în primele zile ale radioului. Totuși, dezvoltările viitoare ale unor astfel de dispozitive au trebuit să aștepte mulți ani.

În ultima vreme activitatea a fost reluată, cu contribuția specialiștilor lucrând în multe domenii științifice. Printre ei erau trei cercetători științifici la Bell Telephone Laboratories din S.U.A., care în 1948 au inventat un dispozitiv de cristal cu trei electrozi, care putea să amplifice și să detecteze semnale electrice. Asemenea detectoarelor timpurii, noul dispozitiv folosea „mustățile pisicii” în rol de conexiuni — două în acest caz. Numele „tranzistor” a fost decis după studiul acțiunii sale, și derivă din două cuvinte: transfer și rezistor.

Descrieți funcționarea tranzistorului

După cum s-a arătat deja, tranzistorul cu joncțiuni constă din trei straturi de germaniu sau siliciu: acestea pot forma o structură *p-n-p* sau *n-p-n*. Există trei conexiuni — la emitor, la bază și la colector.

Regiunea bazei (tipul *n* în structura *p-n-p*) este foarte subțire și ușor dopată din care se obțin electroni ca pur-

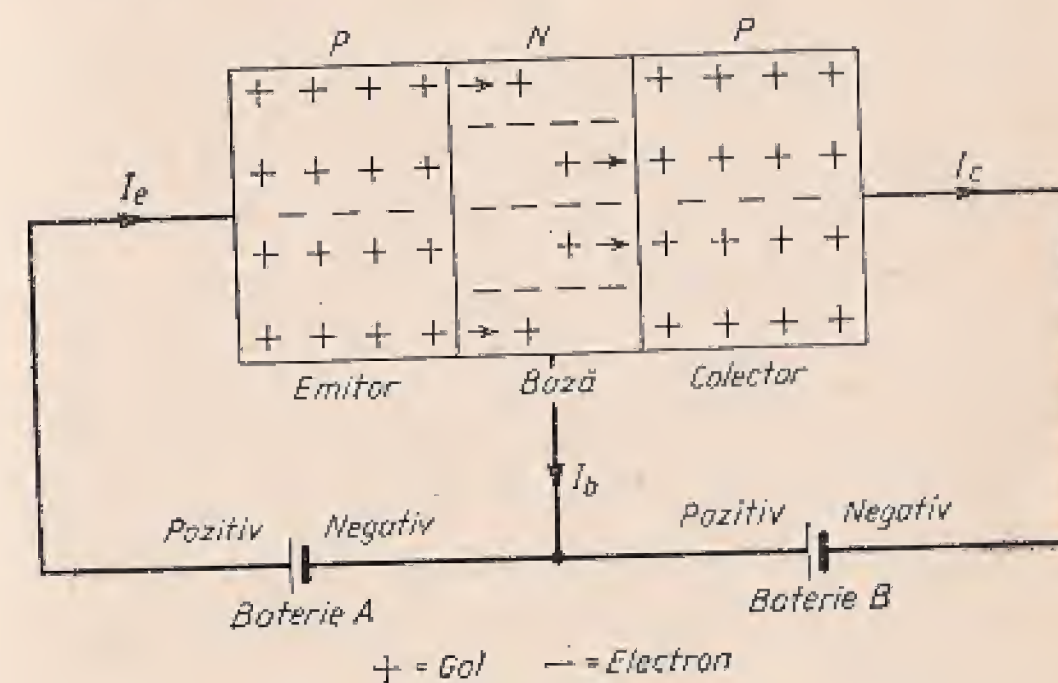


Fig. 10. Tranzistor *pnp* polarizat.

tători de sarcină. Regiunile laterale sînt puternic dopate pentru a obține goluri pozitive ca purtători de sarcină. Structura *p-n-p* este arătată în fig. 10.

Luind regiunea bazei ca punct de referință, jonctiunea $p-n$ poate fi numită jonctiunea emitorului, și jonctiunea $n-p$ jonctiunea colectorului. În fig. 10 jonctiunea emitorului este polarizată de către bateria A în sens direct (emitorul pozitiv față de bază) și jonctiunea colectorului este polarizată invers (colectorul negativ față de bază) de către bateria B . Regiunea p este mult mai puternic dopată decât regiunea n : astfel că cea mai mare parte a curentului care trece prin jonctiunea emitorului se datorează golurilor din regiunea p .

Corespunzător, există un curent de electroni ce trece prin jonctiune de la bază la emitor, dar acesta este mic din cauza puternicii dopări menționate mai sus. Polarizarea directă a jonctiunii emitorului înseamnă că golurile vor fi injectate din emitor în regiunea bazei. Dacă se aplică colectorului o polarizare negativă mare — de la bateria B — cea mai mare parte a golurilor vor fi atrase prin jonctiunea colectorului și prin regiunea colectorului către conexiunea externă a colectorului. Aici golurile vor reprezenta o sarcină pozitivă care atrage electronii din sursa de alimentare în colector. Ceea ce se întâmplă prin urmare, este faptul că golurile trec prin tranzistor într-o direcție în timp ce electronii trec în sens opus, astfel că se stabilește o trecere de curent prin tranzistor.

La trecere prin regiunea bazei, o parte dintre goluri — 2 procente reprezintă o cifră tipică — se vor recombina cu electronii liberi din regiunea bazei, reprezentând un curent al bazei (I_b). Aceasta înseamnă că trecerea electronilor în colector va fi cu 2 procente mai mic decât numărul de goluri ce trec prin jonctiunea emitorului.

Un punct important care trebuie notat totuși, este că 98 de procente de goluri traversează jonctiunea de la un

circuit cu rezistență mică (circuitul de polarizare directă emitor-bază) la un circuit de rezistență mare (circuitul de polarizare inversă colector-bază) — de aici termenul de transfer-rezistor, de la care provine cuvântul tranzistor. Astfel, că deși curentul de colector este mai mic decât cel de la emitor, amplificarea de putere a fost realizată (deoarece puterea $= I^2 \times R$).

Tranzistorul $n-p-n$ este fundamental diferit?

Diferența constă în faptul că sandviciul semiconductor este inversat așa cum se arată în fig. 11 și polaritățile tensiunilor ce se aplică sînt de asemenea inversate. Electronii, în locul golurilor, sînt injectați de emitor și colectați la colector, trecînd apoi prin circuitul extern. Caracteristicile electrice nu sînt prea diferite față de cele ale tranzistorului $p-n-p$ descris mai devreme.

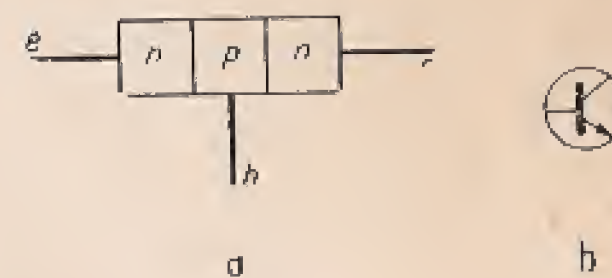


Fig. 11. Diagrama bloc a și simbolul de circuit al unui tranzistor npn .

Cum poate fi făcut un tranzistor să amplifice curent?

Structura descrisă acum — numită configurație cu baza comună deoarece baza este comună circuitului de emitor și circuitului de colector — ne procură, așa cum am văzut, o amplificare de putere. De asemenea se produce o amplificare de tensiune dacă în circuitul de ieșire se introduce o rezistență de sarcină convenabilă. Câștigul de curent, totuși, este mai mic decât unitatea.

Să presupunem că polarizarea este rearanjată așa cum se arată în fig. 12, așa că emitorul este o legătură comună.

În acest caz semnalul de intrare constă într-un curent mic ce trece în regiunea bazei. La bază se aplică un curent mic, în timp ce curentul la colector va fi relativ mare. Deoarece într-un dispozitiv electronic câștigul este

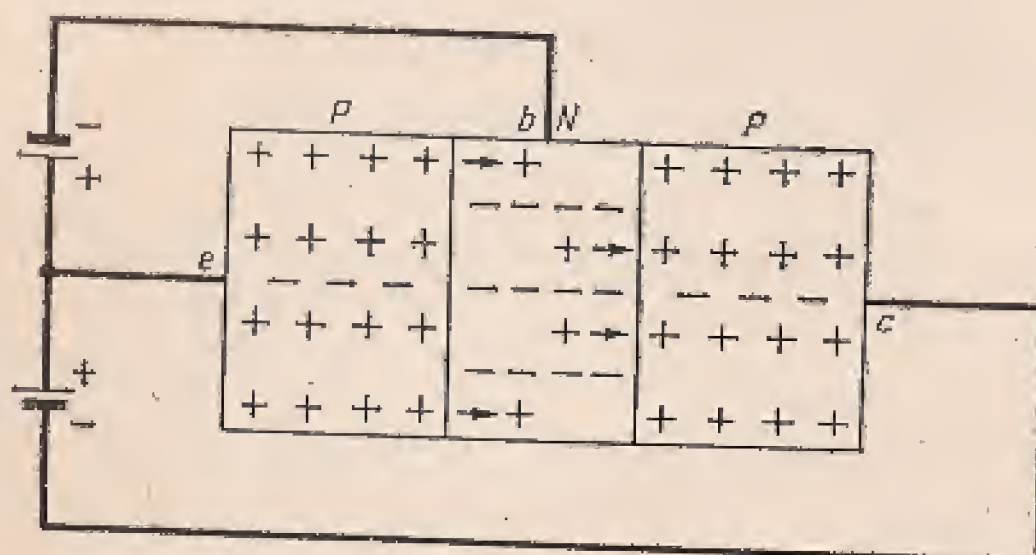


Fig. 12. Tranzistor în conexiunea cu emitorul comun.

raportul mărimii de intrare față de mărimea de ieșire prin această configurație s-a realizat un câștig de curent. Pentru a desemna câștigul de curent pentru configurația cu emitor comun se folosește simbolul β sau h_{fe} .

Care sînt tipurile principale de tranzistoare bipolare, și prin ce diferă ele?

Tipurile de tranzistoare cele mai uzuale sînt tranzistoarele aliate, difuzate și tranzistoarele planare cu siliciu. Toate constă în fapt din două joncțiuni $p-n$ aranjate într-o formație $p-n-p$ sau $n-p-n$. Diferențele dintre ele constă în diferitele tehnici de fabricare folosite și care conduc la caracteristici electrice diferite.

Tranzistorul aliat este simplu, ieftin și prin urmare larg folosit. El este folosit cu o funcționare convenabilă numai la frecvențe joase. Tranzistorul difuzat aliat a realizat performanțe bune la frecvențe înalte și este larg

folosit în radio și televiziune în etajele RF și IF. Tranzistorul planar cu siliciu este mult mai complex dar are performanțe superioare. Cu toate că acum devine utilizabil în echipamente electronice domestice, principalul său câmp de aplicații la modă este în calculatoare și electronică industrială.

Cum se prepară germaniul pentru folosire?

Așa cum s-a stabilit mai devreme, procesul de fabricație începe cu bioxidul de germaniu. El este topit pentru a forma un lingou brut. Germaniul, deși foarte pur chimic, nu este de o puritate standard extrem de înaltă cerută pentru fabricarea tranzistorului: întreaga activitate de fabricare se sprijină pe controlul strict al impurităților, pentru efectul lor asupra conductivității germaniului.

Pentru reducerea impurităților în raport de una la 10^{10} (o parte la 10 mii de milioane) se folosește o metodă numită purificare zonală. Această metodă depinde de faptul că impuritățile se concentrează cel mai rapid în germaniul topit. O zonă topită este trecută progresiv printr-o bară de germaniu, ducînd impuritățile către un capăt, care după solidificare poate fi separată și aruncată. În practică germaniul este așezat într-o cutie de grafit și trasă încet printr-o serie de bobine de încălzire în radiofrecvență într-o atmosferă inertă. Totuși, o cantitate de impurități (antimoniu de exemplu) controlată, trebuie adăugată pentru a obține proprietățile electrice cerute de tranzistor. Adaosul introdus pentru a obține o concentrație de o parte la 10^8 , este nivelat: adică, distribuția de adaos de-a lungul cristalului de germaniu este făcută uniformă.

Nivelarea este ceva similar purificării zonale, iar procesul este în mod normal combinat cu recristalizarea în scopul convertirii lingoului de germaniu într-un monocristal mare care va avea proprietățile electrice cerute. Aceasta se realizează prin asocierea unui lingou a unei semințe de cristal cu o anumită orientare a rețelei: în starea topită germaniul crește pe sămânță și ia aceleași caracteristici.

Cristalul de tip *n* ce rezultă este extrem de dur și se folosește un cuțit de diamant pentru a-l tăia în bucăți. Acestea sînt șlefuite, polizate și apoi tăiate încă odată pentru a face pastilele necesare pentru fabricarea tranzistorului. Ele pot fi tot atît de mici ca un patrat cu latura de cîțiva milimetri și de o zecime de milimetru grosime.

Cum este făcut tranzistorul aliat?

Pastilele mai sus amintite pot forma baza tranzistorului *p-n-p*. Sînt necesare apoi regiunile de colector și emitor din material de tip *p*, iar acestea pot fi obținute prin topirea unui material de tip *p* (indiu) pe fiecare parte a pastilei de bază. Indiul este mai întîi format într-o pastilă sferică, cea pentru colector fiind de cîteva ori mai mare decît cea pentru emitor. Fiecare pastilă, este unită la bază (întîi colectorul apoi emitorul) printr-un proces de aliere executat la o temperatură înaltă.

Astfel indiul pătrunde în germaniu și formează un aliaj care este tocmai germaniul de tip *p*. O secțiune simplificată a unui tranzistor cu *joncțiune aliată* se arată în figura 13.

Apoi urmează să se sudeze *conexiunile* (firele de legătură) și să se monteze ansamblul pe un suport de sticlă. Unitățile astfel formate sînt spălate în apă ne-

ionizată și suprafețele lor se oxidează într-un cuptor. Etapa finală este încapsularea: capsula este din sticlă opacă, plastic sau metal conținînd o umplutură inertă care asigură protecția împotriva umidității și ajută să se disipeze căldura.

Prin ce diferă difuzia de aliere?

În procesul de aliere impuritatea este topită la temperatură înaltă și dizolvă suprafața pastilei de bază de sub ea, astfel că la răcire

și recristalizare, a pătruns și a schimbat polarizitatea regiunii de dedesupt. În procesul de difuzie pastila de bază este crescută la o temperatură apropiată de punctul său de topire într-o atmosferă gazoasă, conținînd substanța impurificatoare cerută: în aceste condiții atomii de impurități difuzează în pastila de bază.

Descrieți tranzistorul aliat-difuzat

Pentru cerințe particulare — spre exemplu, lucrul la puteri mari sau funcționarea în două regimuri în circuite speciale — s-au inventat alte tipuri de construcție și fabricare. Un tip important este procesul de difuzie aliată, care dă posibilitatea tranzistoarelor să funcționeze la frecvențe foarte înalte. Cu alte cuvinte, este îmbunătățit răspunsul la frecvențe înalte.

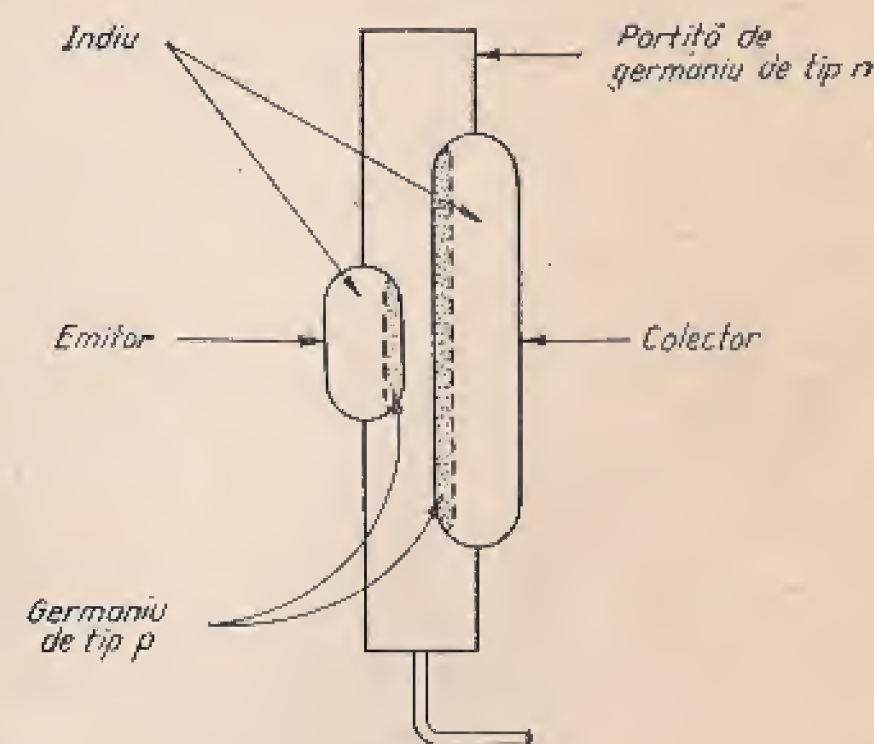


Fig. 13. Secțiune (simplificată) într-un tranzistor cu joncțiune aliat.

Performanța unui tranzistor la frecvențe înalte depinde de timpul necesar pentru ca purtătorii de curent să se miște de la emitor la colector și de grosimea regiunii de bază. Prin procesul de aliere deja descris condițiile practice de fabricare conduc la o frecvență de lucru maximă de aproximativ 15 MHz. Pentru multe scopuri este necesară o frecvență de tăiere mult mai mare și este realizată cu ajutorul tranzistorului difuzat aliat. Pe suprafața unei pastile de tip p ce se obține prin tehnicile menționate anterior, și printr-un proces de pre-difuzie se formează un strat de material de tip n , așa cum se arată în figura 14, a.

Două pastile sînt plasate pe suprafață: pastila marcată prin litera B , care formează legătura la bază, con-

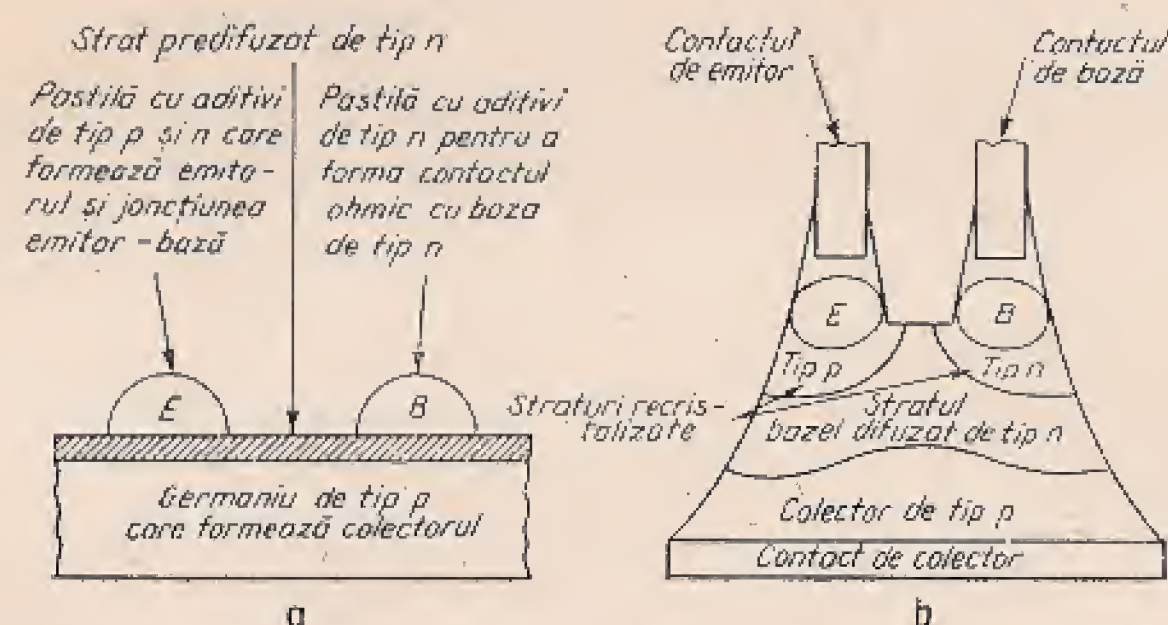


Fig. 14. Construcția unui tranzistor difuzat-aliat. Componentele principale înainte de încălzire a și secțiune transversală după difuzie-aliere și corodare b.

ține un material aditiv de tip n , în timp ce pastila E (emitorul) conține aditivi de tip p și n . Acest ansamblu este încălzit și aditivii pătrund în pastila de germaniu.

Aditivul de tip p al pastilei E difuzează încet și pătrunde foarte puțin în pastilă, dar aditivii de tip n din ambele pastile difuzează rapid, formînd straturi de tip n în pastilă.

Acest strat, care formează baza tranzistorului, poate fi de o grosime mai mică de două sutimi de milimetru.

Cînd se răcește ansamblul, din pastile se recrystalizează un strat de germaniu: stratul de sub pastila E este în special de tip p , deoarece aditivul de tip p este mai solubil în germaniul recrystalizat. Acest strat formează o joncțiune $p-n$ cu stratul de bază difuzat, care în schimb formează o joncțiune $n-p$ cu pastila colectorului. Stratul recrystalizat de sub pastila B este de tip n și formează o joncțiune neredresoare cu stratul difuzat al bazei de tip n .

Structura este apoi mascată în jurul suprafețelor celor două pastile, și suprafața rămasă este corodată pentru a obține o configurație finală așa cum se arată în fig. 14, b.

Ce este un tranzistor planar epitaxial?

În figura 15 se arată configurația unui tranzistor epitaxial planar. Ambele joncțiuni, colector-bază și emitor-bază, sînt formate prin difuzie. Regiunile emitorului și bazei sînt difuzate prin ferestre gravate într-un strat de suprafață oxidat al pastilei suport suprafețele reoxidîndu-se după fiecare proces. Suprafața oxidată — bioxidul de siliciu — protejează joncțiunile, conducînd la performanțe îmbunătățite printre care și un curent rezidual de colector foarte mic și foarte stabil.

Ca și la alte tranzistoare difuzate, stratul de bază poate fi făcută extrem de subțire, astfel că este posibilă funcționarea la frecvențe foarte mari, peste cîteva mii de MHz.

Prin formarea tranzistorului, așa cum s-a arătat, pe o pastilă compusă avînd o rezistență scăzută a substra-

tului, rezistența internă a regiunii de colector și deci căderea de tensiune pe ea este mult redusă.

Epitaxia se referă la modul cum se formează colectorul pe un substrat de rezistență scăzută. Aceasta constă în creșterea unei pelicule subțiri de semiconductor

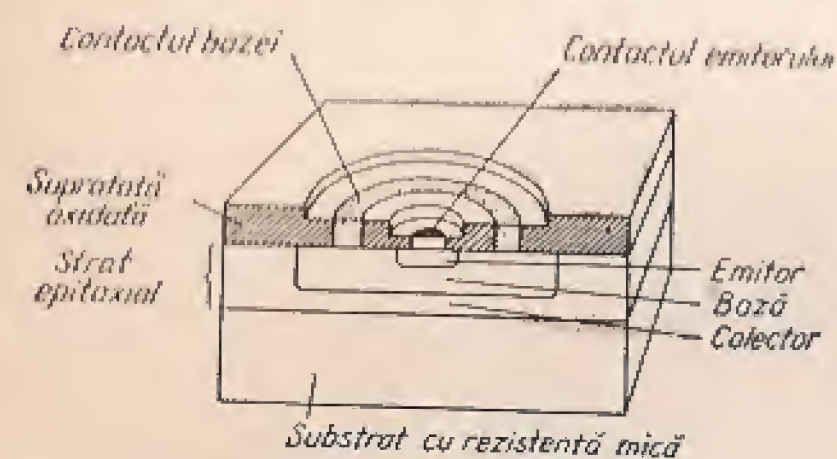


Fig. 15. Trăsăturile esențiale ale unui tranzistor cu siliciu planar epitaxial în timpul fabricației. Diferitele regiuni sînt difuzate prin „ferestre” corodate în suprafața oxidului, suprafața fiind reoxidată după fiecare proces. Tipul prezentat este un tranzistor de audio frecvență de semnal mic.

simple de tranzistoare dar se obține un tranzistor cu caracteristice extrem de bune. Performanțele excepționale la frecvențe înalte le face convenabile în folosirea pentru circuite de impulsuri, de exemplu în calculatoare, sau alte aplicații de prelucrare a datelor.

Procesul planar este baza dezvoltării multor circuite monolitice.

Diferă tranzistorul de putere de cele descrise anterior?

În afară de faptul că este mult mai mare, tranzistorul de putere este identic în aspectele esențiale cu celelalte tipuri descrise pînă acum. Totuși acesta este închis într-o capsulă metalică, iar în timpul utilizării, este ast-

fel montat încît să fie în contact (printr-o șaibă izolatoare de mică) cu sașul ajutînd astfel la disiparea temperaturii considerabile produsă de colector. Dacă nu se ia în considerație această precorecție tranzistorul se va deteriora în mod ireparabil. În fig. 16 se reprezintă o sec-

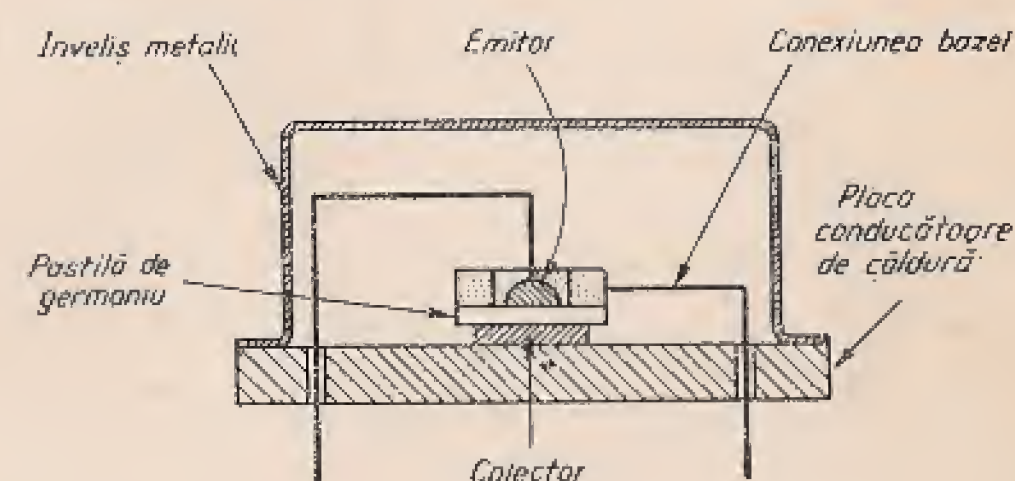


Fig. 16. Secțiune simplificată printr-un tranzistor de putere.

țiune simplificată printr-un tranzistor de putere. Acesta este un tip de tranzistor ce se folosește în etajul de ieșire al unui radioreceptor.

Ce este un tranzistor cu efect de câmp?

Acesta este un tranzistor unipolar, funcționarea sa depinzînd numai de purtători majoritari. Există două tipuri principale, tranzistorul cu efect de câmp cu poartă joncțiune și tranzistor cu efect de câmp cu poartă izolată. În fig. 17, a se reprezintă construcția unui tranzistor cu efect de câmp cu joncțiune ce are la bază un substrat de siliciu de tip *n*. Dacă se conectează o sursă externă de tensiune între sursă și drenă, prin tranzistor trece curent de la sursă la drenă prin canal. Dacă între sursă și poartă se aplică o tensiune va rezulta în canal un câmp electric care va împiedica trecerea curentului

(de aici numele de tranzistor cu efect de câmp). Curentul ce trece prin tranzistor este controlat deci de variația tensiunii aplicate pe poartă. Tranzistorul din figură este un tranzistor cu efect de câmp cu canal p : versiunea cu canal n poate fi realizată în mod identic prin difuzia sursei, drenă și canalului de tip n în substratul de tip p .

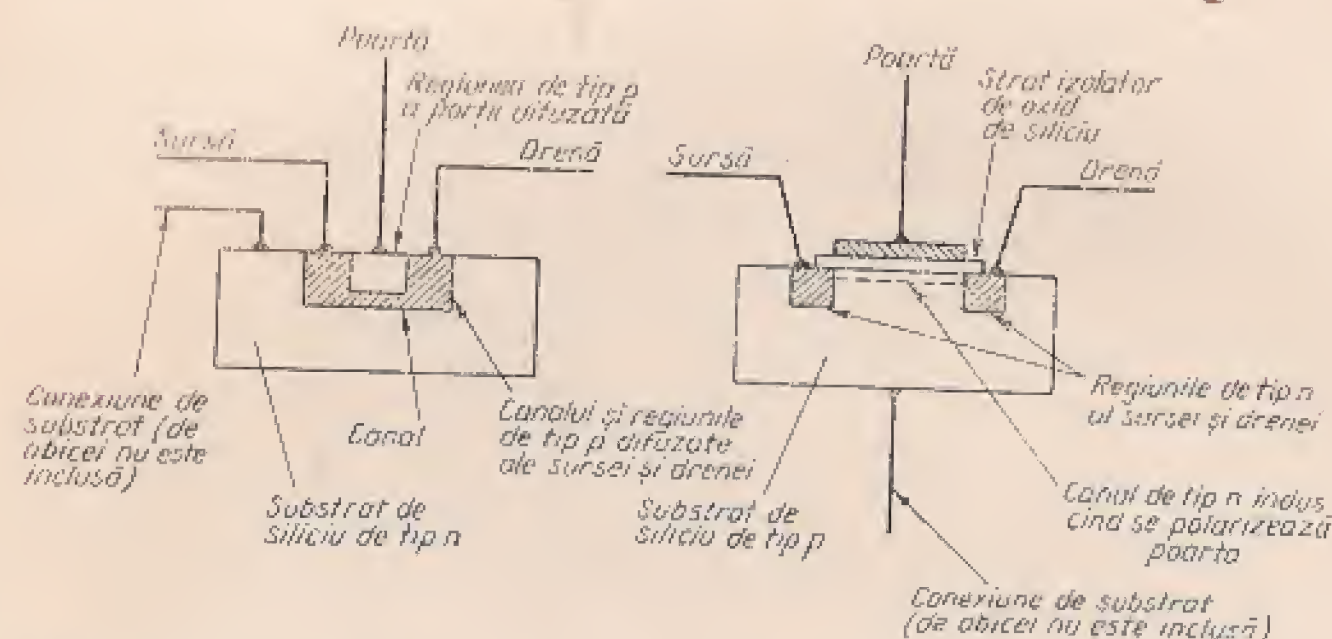


Fig. 17. Două forme ale tranzistorului cu efect de câmp:

- a — tranzistor cu efect de câmp cu funcțiune cu canal n ;
b — tranzistor cu efect de câmp cu poartă izolată și cu canal n .

Dacă poarta este separată de canal printr-un strat izolator, funcționarea dispozitivului se desfășoară similar cu a unui capacitor, capacitatea fiind formată de stratul izolator ca dielectric iar poarta și canalul ca „armături”. Se obține astfel tranzistorul cu efect de câmp cu poartă izolată, la care controlul trecerii curentului prin canal este realizat de tensiunea aplicată porții. În figura 17, b se arată o structură de tranzistor cu efect de câmp cu poartă izolată mult mai elaborată. După cum se poate vedea, aici există două joncțiuni pn , regiunile sursei și drenă, fiind separate*. Astfel, prin dispozitiv

* Uneori între drenă și sursă se formează un canal foarte puțin dopat, numit „canal inițial” astfel că la aplicarea unei tensiuni între drenă și sursă va lua naștere un curent de valoare mică.

nu va trece curent la conectarea unei tensiuni între sursă și drenă deoarece joncțiunile sînt spate în spate. Să vedem ce se întîmplă cînd, la configurația din figura 17, b cu substratul de tip p și regiunile sursei și drenă de tip n , se aplică o tensiune pozitivă pe poartă. Electronii liberi, deoarece sarcinile de semn contrar se atrag, se vor aduna chiar sub stratul izolator. În acest mod sub stratul izolator apare o regiune cu sarcină negativă iar acest canal de tip n indus permite curentului să curgă de la sursă la drenă. Variind tensiunea dintre poartă și sursă se va realiza controlul asupra curentului ce trece prin dispozitiv. În figura 17, b se arată un tranzistor cu canal n indus dar este posibilă și versiunea cu canal p . Acest tip de tranzistor cu efect de câmp se mai numește tranzistor metal oxid semiconductor datorită porții metalice, stratului de oxid izolator și a substratului semiconductor.

Cînd curentul ce trece prin tranzistorul cu efect de câmp crește odată cu creșterea tensiunii porții, ca în structura descrisă mai sus, acest mod de lucru se numește funcționare cu îmbogățire de purtători. Cînd micșorarea tensiunii porții provoacă micșorarea curentului ce trece prin dispozitiv ca în tranzistorul cu efect de câmp cu joncțiune sau tipul mai simplu cu poartă izolată, acest mod se numește funcționare cu sărăcire de purtători.

Diferența importantă dintre tranzistorul cu efect de câmp și tipurile de tranzistoare bipolare este că electrodul de comandă al tranzistorului cu efect de câmp — poarta — nu absoarbe curent, dispozitivul fiind controlat prin tensiunea aplicată electrodului. Aceasta înseamnă că impedanța de intrare a tranzistoarelor cu efect de câmp este mult mai mare decît a tranzistoarelor

bipolare, ceea ce reprezintă un avantaj considerabil în unele aplicații.

Întrucît stratul izolator al unui tranzistor cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor poate fi ușor deteriorat datorită supratensiunilor acesta este alimentat printr-un colier ce scurtcircuitază electrozii poartă și sursă și acesta ar putea fi lăsat în această poziție ori de cîte ori dispozitivul nu se află în circuit.

3

r.tv. r.tv. r.tv. r.tv. r.tv. r.tv.

Circuite cu tranzistoare

Cum se conectează tranzistorul într-un circuit?

Deoarece tranzistorul este un dispozitiv cu trei electrozi, el poate fi conectat în trei moduri, sau conexiuni cum se mai numesc. Acestea sînt conexiunile cu bază comună, cu emitor comun și cu colector comun și sînt

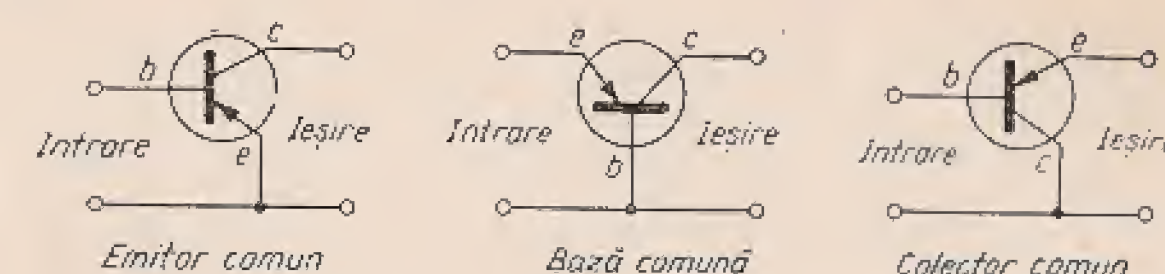


Fig. 18. Cele trei conexiuni principale ale tranzistorului.

reprezentate în figura 18. Uneori în loc de „comun“ se folosește termenul „masă“ întrucît terminalul comun va fi conectat la masă sau la șasiu.

Caracteristicile principale ale acestor conexiuni sînt prezentate în tabelul 1. Valorile exacte depind de tipul de tranzistor și de natura sarcinii aplicate.

Conexiunea cu emitorul comun este cea mai frecvent folosită în amplificatoare. În această conexiune se poate obține o amplificare de 70 cu un tranzistor cu joncțiuni. Conexiunea cu colectorul comun este interesantă prin aceea că, datorită impedanței de intrare mare și impedanței de ieșire mică, acest montaj corespunde repetorului pe catod folosit în amplificatoarele cu tuburi.

Tabelul 1

Caracteristicile conexiunilor tranzistoarelor

Caracteristici	Emitorul comun	Baza comună	Colectorul comun
Impedanță de intrare	medie	mică	mare
Impedanță de ieșire	medie	mare	mică
Amplificarea de curent	mare	mai mică decât 1	mare
Amplificarea de tensiune	mare	mare	mai mică decât 1
Defazaj	inversare cu 180°	nu	nu

Această conexiune se folosește ca etaj de cuplare între tranzistoarele montate în conexiunea cu emitorul comun. Conexiunea cu baza comună își are cele mai multe aplicații în radiofrecvență.

Ce este defazajul?

S-a arătat în tabelul 1 că, în conexiunile cu baza comună și colectorul comun, nu există defazaje. Cu alte cuvinte, semnalele de la intrare și ieșire sînt în același

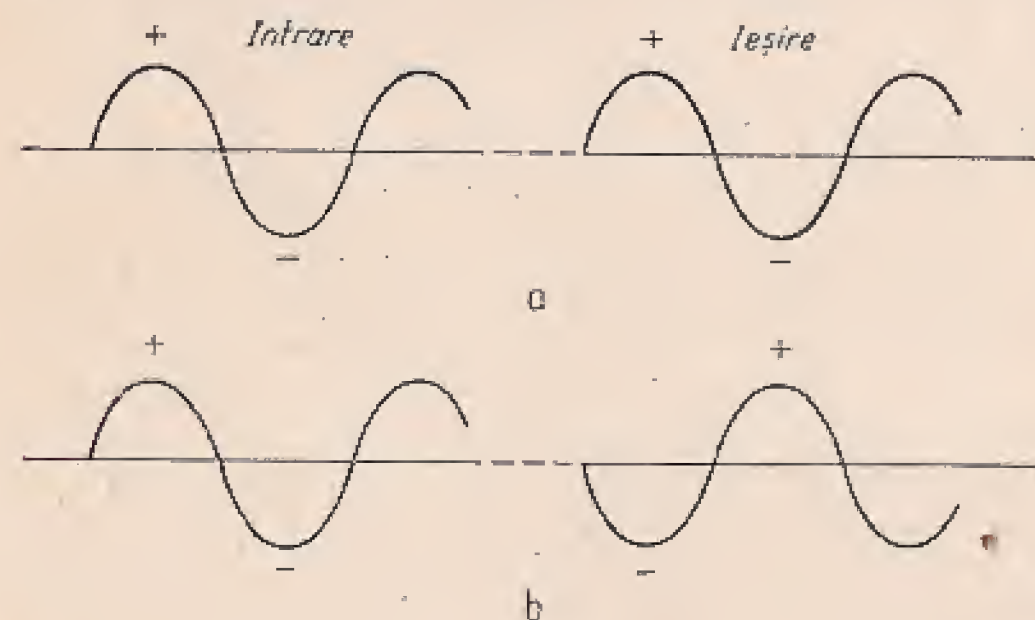


Fig. 19. Semnale de intrare și ieșire în fază a și inverse în fază b: semnalul de ieșire este defazat cu 180° față de semnalul de intrare.

pas: ele devin ambele pozitive sau negative în același moment (vezi fig. 19). În conexiunea cu emitorul comun, semnalul de ieșire devine pozitiv în timp ce semnalul de intrare devine negativ. Apare astfel o inversare a fazei, iar cele două semnale sînt defazate cu 180° . Aceasta este ca și cum ai da înapoi semnalul cu o jumătate de ciclu (180°). De notat că în această figură nu s-a ținut seama de amplitudinea semnalelor: unul ar putea fi mai mare decât celălalt. Inversarea fazei are o importanță deosebită în circuitele de impulsuri.

Cum se polarizează un tranzistor?

Am observat din figurile 10 și 12 că pentru polarizarea tranzistoarelor în conexiunile cu baza comună și emitorul comun se folosesc două baterii. Folosirea celor două baterii nu este practică. În figura 20, a se arată o metodă simplă de polarizare a etajului cu emitorul comun folosind o singură baterie. În acest montaj va

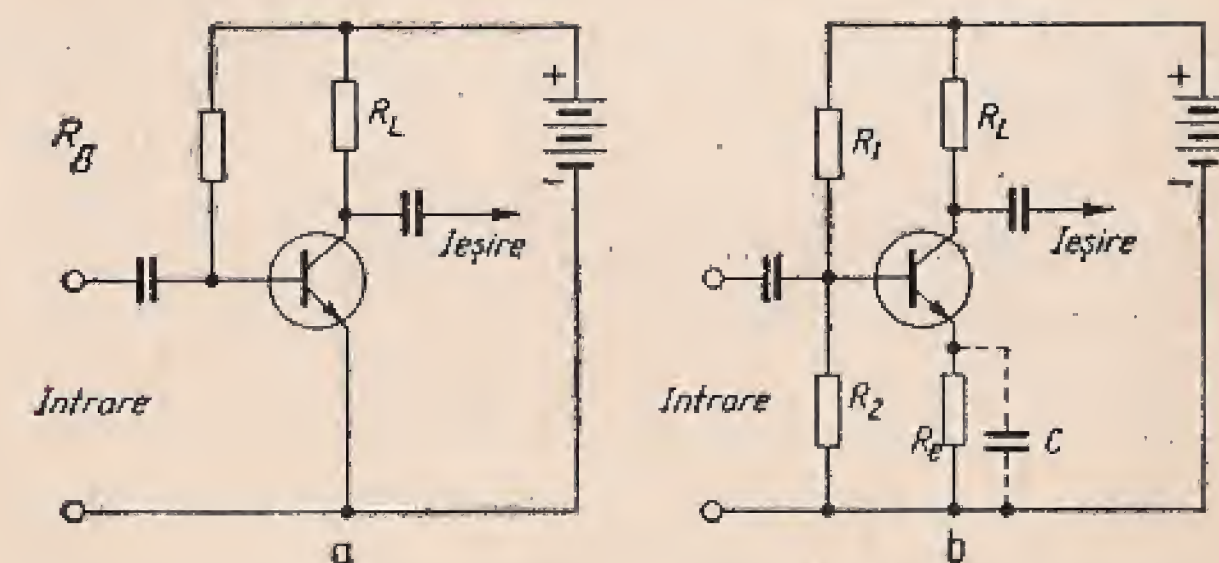


Fig. 20. Metode de polarizare a tranzistoarelor. În aceste exemple sînt prezentate tranzistoare npn.

curge un curent mic de la baterie în circuitul bazei ca rezultat al conectării rezistorului de polarizare R_B între bază și borna pozitivă a bateriei.

Acest curent va pozitiva baza în raport cu emitorul, situație pe care o dorim, într-o configurație *pnp*, pentru a polariza direct joncțiunea emitorului.

În practică se folosesc în general montaje mult mai complicate în scopul eliminării creșterii curentului datorită efectelor de temperatură ce apar în materialul semiconductor. Dacă un tranzistor se încălzește în timpul funcționării, curentul ce trece prin el va crește, un curent mai mare înseamnă o creștere suplimentară a temperaturii și așa mai departe, astfel ca poate apărea condiția numită ambalare termică dacă nu se iau precauții speciale.

În figura 20, b se arată căile uzuale de prevenire a acestei situații. Pentru a realiza o polarizare stabilă a bazei se folosește un divizor de tensiune (R_1 și R_2), iar în emitor se introduce rezistorul R_e de valoare mică. Efectul lui R_e este acela că la creșterea curentului de emitor datorită temperaturii, tensiunea bazei față de emitor (pentru o structură *nnp*) scade, prin urmare micșorînd curentul bazei și al colectorului. Așa cum se arată, pentru prevenirea reacției negative se introduce un capacitor C de decuplare pe R_e .

Descrierea unui circuit amplificator cu două etaje

În fig. 21 se reprezintă un amplificator cu două etaje simplu care folosește două tranzistoare *pnp*. În acest exemplu se folosește o altă metodă de stabilizare a polarizării deși mai puțin eficace decît cea prezentată în fig. 20, b. Această metodă constă în conectarea rezistoarelor de polarizare (R_1 și R_3) direct la colectoarele tranzistorului și nu la sursa de tensiune. Principiul de funcționare este similar: cînd curentul colectorului crește,

datorită creșterii temperaturii, tensiunea de colector va scădea. Acest fapt va modifica polarizarea bazei, tensiunea pe bază scade, și deci curentul de colector va scădea și el. Pentru cuplarea celor două etaje se folosește un grup rezistență-capacitate,

tensiunea de ieșire a primului tranzistor se găsește pe rezistorul R_2 și se aplică pe baza celui de al doilea tranzistor prin intermediul capacitorului C . Datorită valorilor relativ mari, ale capacitoarelor de cuplare folosite în circuitele cu tranzistoare, adesea se utilizează capacitoare electrolitice, așa cum s-a arătat în figură. Este important să se conecteze cu polaritatea corect.

Uneori se folosesc montaje complementare. Un amplificator în cascadă cu două

etaje poate folosi caracteristicile complementare ale tranzistoarelor *pnp* și *nnp* în scopul realizării unei cuplări directe dintre cele două etaje. În exemplul prezentat în fig. 22, polarizarea primului etaj este realizată prin divi-

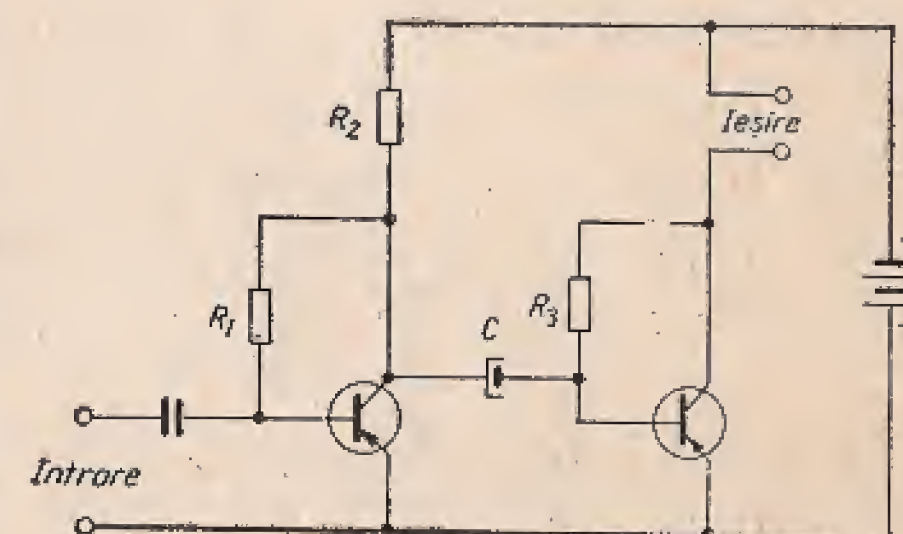


Fig. 21. Amplificator tranzistorizat simplu cu două etaje. În circuitele cu tranzistoare este foarte important să se respecte polaritatea capacitoarelor electrolitice. În general la tranzistoarele *pnp* montate în cascadă colectorul primului tranzistor va fi mai negativ decît baza celui de al doilea, astfel încît capacitorul electrolitic se conectează cum se arată aici.

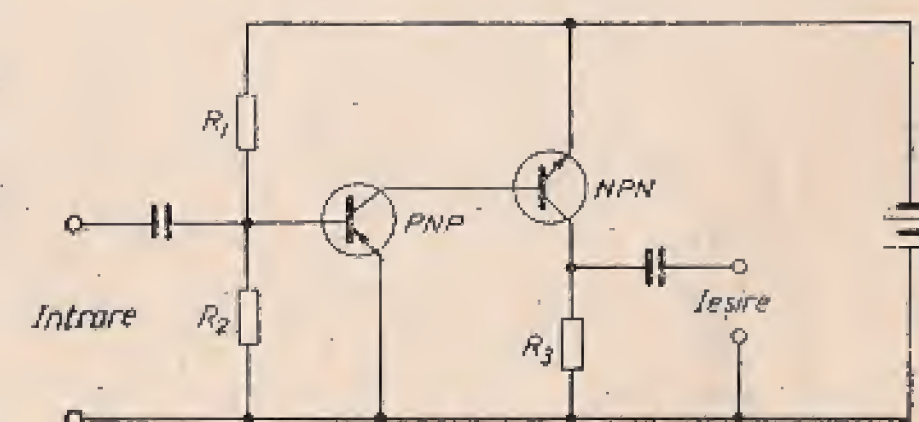


Fig. 22. Circuit complementar folosind tranzistoare *pnp* și *nnp* cu cuplaj direct între etaje.

zorul de tensiune R_1 și R_2 . Circuitul emitor-bază al celui de al doilea etaj acționează ca o sarcină pentru primul etaj, iar curentul de colector al primului tranzistor devine curent de polarizare a bazei pentru al doilea tranzistor. R_3 reprezintă sarcina celui de al doilea etaj. Un astfel de montaj, folosind foarte puține componente, are un câștig mare și un răspuns la frecvențe joase bun (nu există capacitor de cuplare prin care semnalul trebuie să treacă). Semnalele de intrare și ieșire sînt în fază.

Cum se folosește tranzistorul în circuitele oscilatoare?

În fig. 23 se arată un oscilator RF simplu. Baza tranzistorului este polarizată prin divizorul de tensiune R_1 , R_2 încît curentul circulează prin tranzistorul a cărui sar-

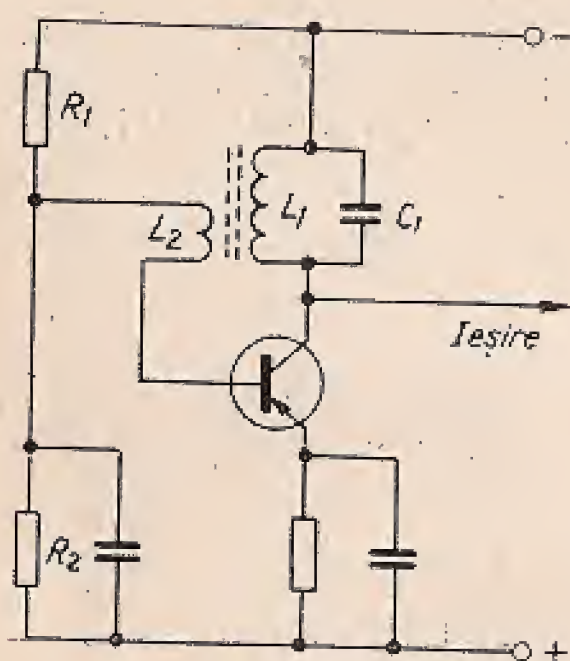


Fig. 23. Oscilator rf cu tranzistor avînd ca sarcină un circuit acordat (L_1 , C_1). Remarcăm că semnalul de intrare (la bornele lui R_2) este aici în serie cu curentul de polarizare (via R_1) din R_2 care este decuplat.

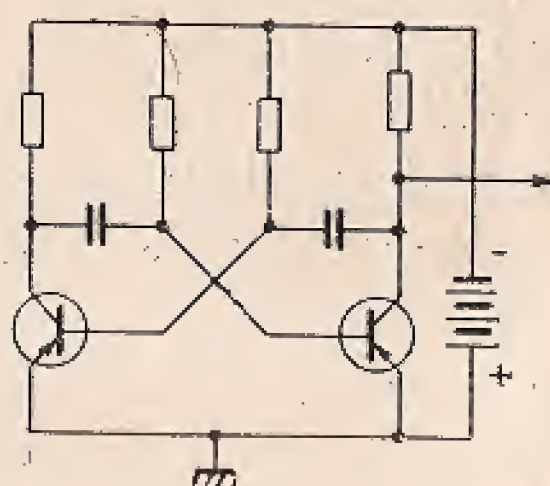


Fig. 24. Circuit multivibrator cu tranzistoare. Cele două tranzistoare sînt cuplate în cruciș prin grupul capacitate rezistență.

cină este circuitul acordat L_1 , C_1 . O parte din semnalul de ieșire este aplicat înapoi pe bază prin înfășurarea de cuplaj L_2 , rezultînd oscilații întreținute dacă înfășurarea este corect montată pentru a asigura o reacție pozitivă.

În fig. 24, se reprezintă una din alte cîteva posibilități de realizare a circuitelor oscilatoare. Dacă cele două etaje cu emitorul comun sînt conectate așa cum se arată în figură între semnalele de intrare și ieșire apare un defazaj de 360° , adică cele două semnale sînt în fază. Circuitul va oscila dacă semnalul de ieșire este aplicat la intrare. Un astfel de oscilator va produce la ieșire un semnal complex, depinzînd de caracteristicile rețelelor rezistență-capacitate folosite, iar forma de undă este bogată în armonice. Pentru acest montaj se folosește adesea numele de multivibrator. El are aplicații în circuitele bază de timp, calculatoare, echipamente de comunicații și instrumente.

Cît de mult sînt folosite tranzistoarele în radio?

În largul domeniu al radiocomunicațiilor există un număr de echipamente, care încă nu pot fi realizate în întregime cu tranzistoare sau îmbunătățite prin folosirea lor. În alte echipamente tranzistoarele, de obicei folosite pe cablaje imprimate și miniaturizate, aduc beneficii și avantaje pe care tuburile nu le-ar putea oferi. Dispozitivele semiconductoare sînt folosite în televiziune, magnetofone și o varietate largă de echipamente audio.

Receptoarele tranzistorizate portabile, alimentate la baterii și adesea suficient de mici pentru a intra într-un buzunar, sînt în momentul de față ceva foarte obișnuit. În momentul de față tranzistoarele sînt folosite în toate tipurile de receptoare radio, inclusiv picupurile, alimentate la rețea și cu puteri de ieșiri relativ ridicate. Tranzistoarele sînt folosite în toate etajele: amplificatoarele de frecvență intermediară, detectoare, mixere și etajele de ieșire. Tranzistoarele sînt folosite atît în receptoarele MA cît și MF dar în această lucrare ne vom referi numai la receptoarele MA.

Descrierea funcției de amplificare a unui tranzistor într-un receptor radio

Condițiile de bază pentru amplificare au fost deja descrise. În continuare se va considera amplificatorul din

receptoarele radio și apoi, echipamentele de reproducere a sunetului mult mai specializate.

În etajele finale ale receptorului se pune problema obținerii unei puteri maxime cu minimum de distorsiuni ale semnalului, sau pentru orice eventualitate cu un nivel de distorsiuni care va fi acceptabil pentru ascultător. Pentru aceasta sînt posibile cîteva moduri sau clase de funcționare ale etajelor amplificatoare.

Care sînt aceste clase de funcționare?

Pentru etajele de ieșire ale receptoarelor sau echipamentelor audio mai specializate sînt importante trei clase de funcționare; sau, pentru a fi mai preciși, două clase principale, clasa A și clasa B, și o clasă intermediară numită clasă AB. Această clasificare este determinată de polarizarea tranzistorului.

În fig. 25 se reprezintă un etaj de ieșire cu tranzistor în clasă A. Pentru a obține cel mai bun randament semnalul din sarcină și de la intrare trebuie să fie astfel aranjate ca tensiunea pe colector și curentul să varieze între zero și dublul valorii în absența semnalului. Valoarea medie a curentului de colector este aceeași indiferent dacă se aplică sau nu semnal: astfel puterea absorbită de la sursa de alimentare rămîne constantă. Aceasta înseamnă că puterea disipată în tranzistor se reduce cînd se aplică semnal. Randamentul teoretic al etajului clasă A este de 50% (adică, sub condițiile ideale); în practică este ceva mai mic.

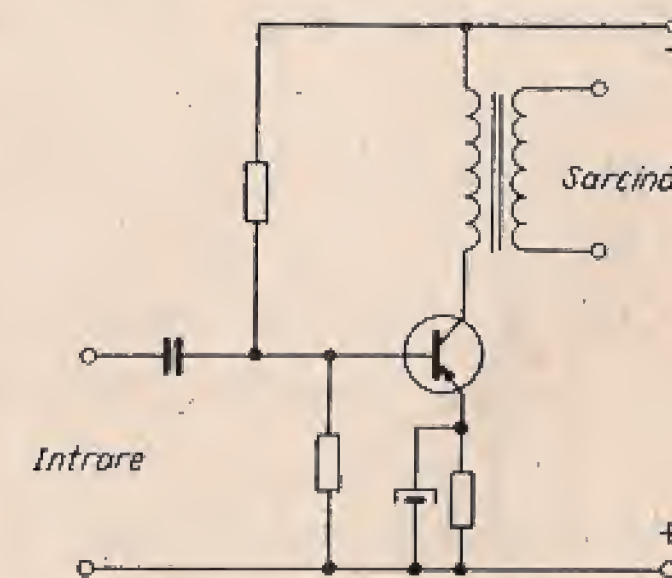


Fig. 25. Etaj de ieșire clasă A cu tranzistoare.

În funcționarea în clasă B curentul de repaus — existent în absența semnalului — este foarte mic, dar curentul crește pe măsură ce crește amplitudinea semnalului aplicat. Deoarece consumul de la sursa de alimentare

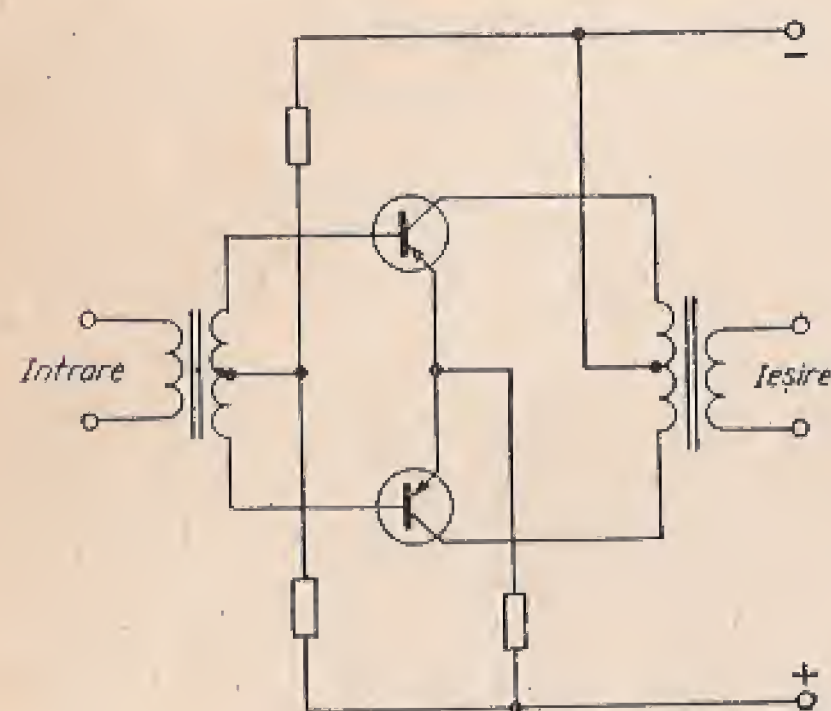


Fig. 26. Etaj de ieșire push-pull clasă B.

tare depinde de semnal sînt posibile realizarea unor economii. Randa-mentul teoretic este de 78,5%. Forma de undă a semnalului de ieșire a unui etaj clasă B reprezintă o serie de semialternanțe ale semnalului de intrare și deci este necesară utilizarea a două tranzistoare în

montaj push-pull în scopul obținerii unei

forme de undă utilizabile (fig. 26). Acest montaj oferă o putere de ieșire relativ ridicată, dar necesită o grijă deosebită în proiectare pentru a elimina distorsiunile.

Clasa AB de funcționare este intermediară între clasă A și clasă B. În absența semnalului de intrare prin etaj curge un curent oarecare dar acesta este mai mic decît în etajul clasă A. În general etajele clasă AB sau clasă B, precum și variante ale acestora, sînt folosite acolo unde se folosesc semnale de intrare mari, în-deosebi în etajele de putere.

Etajele clasă A sînt folosite în multe moduri acolo unde se folosesc semnale mici dar este necesar un cîștig considerabil.

Cît este de mare puterea ce se obține din etajele finale cu tranzistoare?

Deși etajele de ieșire în push-pull din radioreceptoarele portabile și picupuri au o putere de un watt sau mai mică, în radioreceptoarele mai scumpe realizarea unor puteri de 10 W a devenit ceva obișnuit. În amplificatoarele audio relativ mai costisitoare cu ajutorul unor circuite speciale se ating puteri pînă la 50 W: această putere este realizabilă pe fiecare canal al unui sistem stereofonic. Succesele în această direcție depind de depășirea dificultăților de fabricație și realizarea unor tranzistoare de putere mare suficient de ieftine.

Ce tipuri de oscilatoare se folosesc?

S-a vorbit deja despre un oscilator de radiofrecvență și despre un multivibrator simplu. În toate oscilatoarele există două părți principale: una este formată de componentele ce determină frecvența de oscilație iar cealaltă asigură amplificarea, cu ajutorul unui tranzistor, pentru a menține oscilațiile. În cele mai simple oscilatoare, numite în general oscilatoare de relaxare, tranzistorul ce asigură amplificarea este în fapt un comutator, deoarece tranzistorul trece din stările de conducție în cele de ne-conducție (adică, de tăiere). Frecvența de lucru este determinată de rețele simple, să zicem din rezistențe și capacități.

Alte tipuri de oscilatoare includ circuitele Hartley și Colpitts, care produc la ieșire un semnal sinusoidal. Ele vor fi familiare acelor care au avut ocazia să studieze radioreceptoarele cu tuburi electronice. Într-adevăr, circuitele cu tranzistoare sînt principal similare celor cu

tuburi. Un exemplu care să illustreze acest fapt este prezentat în fig. 27. În astfel de circuite frecvența de rezonanță de obicei este determinată de inductanța L și

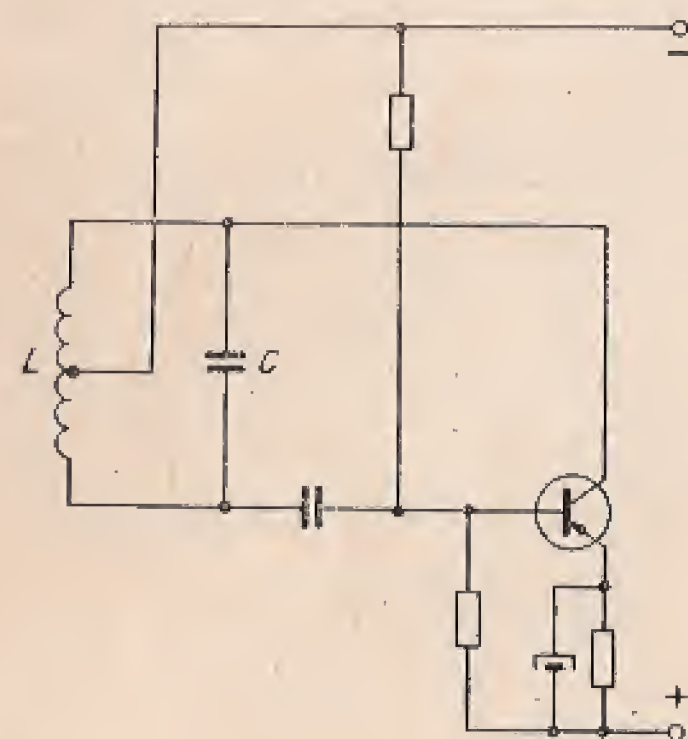


Fig. 27. Oscilator Hartley cu tranzistoare.

capacitatea C din circuitul de reacție conectat, în fig. 27, între colectorul și baza tranzistorului.

O oscilație generată în acest circuit se va amortiza, urmînd o lege exponențială, datorită efectului rezistenței. Această pierdere de putere trebuie compensată dacă dorim menținerea oscilațiilor, iar sursa de putere în acest caz este etajul amplificator cu tranzistor.

Cum se folosește tranzistorul într-un etaj detector?

În cazurile cele mai simple în etajul detector se folosește o diodă, mai degrabă decît un tranzistor. El are o sarcină rezistivă posibil potențiometrul de volum al receptorului, și deci semnalul detectat este aplicat etajelor amplificatoare de audiofrecvență. Adesea, totuși, pentru detecție se folosește tranzistorul: aceasta se realizează polarizînd astfel tranzistorul încît să se poată folosi porțiunea neliniară a caracteristicii de colector care asigură deci acțiunea de redresare.

Ce este C.A.A. și cum se realizează?

Controlul automat al amplificării reprezintă o tehnică de reglare. Scopul său este să prevină supraîncărcarea

ultimelor etaje ale receptorului ce ar putea să se producă la recepția semnalelor puternice. Pe de altă parte, cînd apare fenomenul de fading al semnalelor (de obicei în receptoarele MA) CAA ajută la minimizarea efectului asupra condițiilor de audiție.

În acest scop, din detector se culege o tensiune de control care se aplică unui etaj FI, adesea în serie cu tensiunea de polarizare bază-emitor a primului tranzistor FI. Tensiune de control este proporțională cu amplitudinea purtătoarei de la detector și controlează amplificarea etajelor cărora se aplică. Circuitul este astfel aranjat încît semnalele mici (să zicem cele de fading) permit o amplificare ridicată în etajul FI, în timp ce semnalele puternice reduc din amplificare. Pentru eliminarea semnalelor de frecvență radio sau audio din linia CAA este necesară includerea unor componente de filtrare.

Descrieți etajul amplificator de frecvență intermediară

Așa cum se arată în fig. 28, etajul de frecvență intermediară este foarte asemănător cu etajele amplificatoare simple de care ne-am ocupat, doar că acestea au la intrare și ieșire transformatoare, care sînt acordate pe frecvența intermediară, în mod obișnuit 460 KHz la receptoarele MA. Aceste transformatoare determină banda de frecvență în care etajul asigură amplificarea admițînd trecerea numai pentru semnalele cu frecvența cuprinsă în interiorul acestei benzi.

La frecvențe radio trebuie luată în considerație reacția internă proprie a tranzistorului, deoarece aceasta determină amplificarea ce poate fi obținută fără distorsiune sau instabilități. Printr-o proiectare adecvată se adaugă componente externe care introduc o reacție opusă

ca fază, care echilibrează reacția proprie tranzistorului. Această metodă, numită unilateralizare, implică utilizarea de rezistențe și capacități. Un sistem mai simplu,

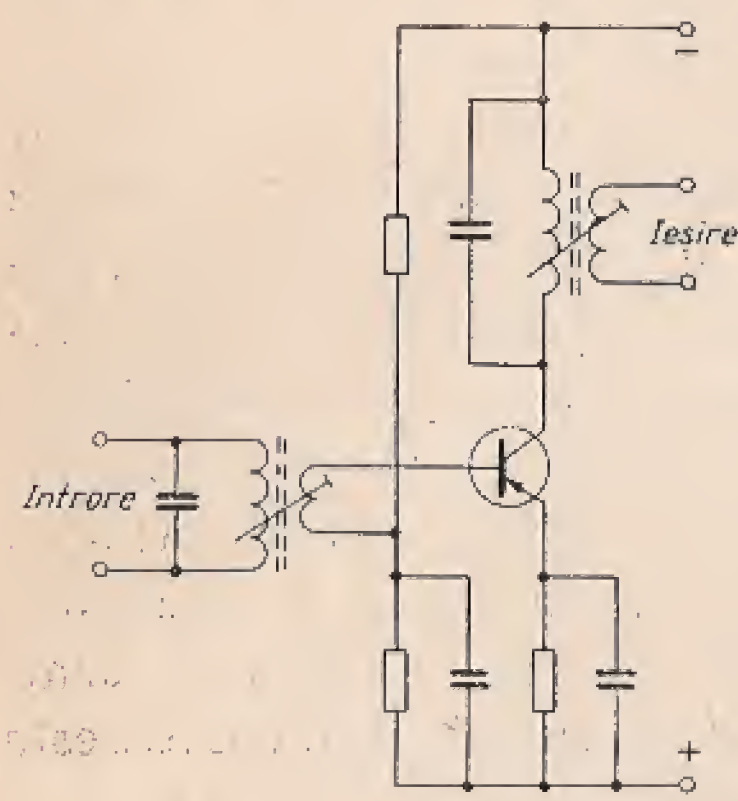


Fig. 28. Etaj amplificator pentru frecvențe intermediare.

care utilizează numai capacități, se numește neutrodinare. La tipurile de tranzistoare ce se folosesc în acest moment în amplificatoarele FI și RF reacția internă este neglijabilă.

În fig. 29 se reprezintă un etaj complet al unui amplificator de frecvență intermediară echipat cu un tranzistor OC 45. Componentele de neutralizare sînt R_f și C_f . Ar fi de re-

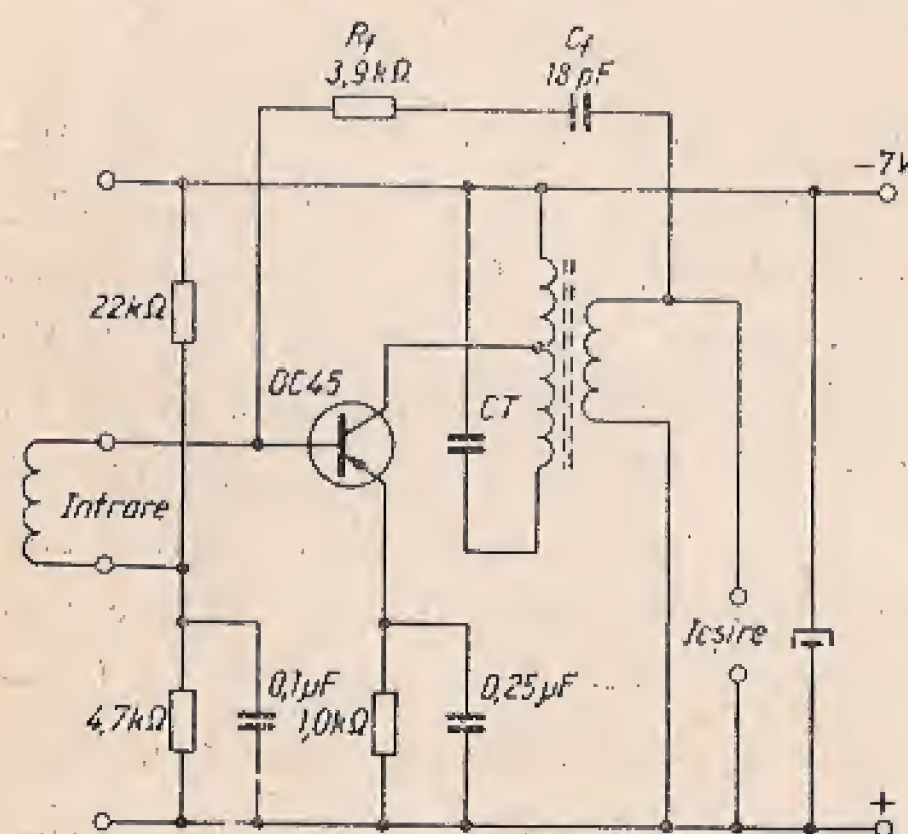


Fig. 29. Amplificator de FI cu un etaj. CT reprezintă capacitorul de acord; R_f și C_f sînt componentele de reacție, asigurînd unilateralizarea. Unilateralizarea este rareori necesară dacă se folosesc tranzistoare de frecvență înaltă cum sînt cele difuzate aliate.

marcat că lărgimea de bandă și selectivitatea unui amplificator FI pot fi îmbunătățite dacă cele două înfășurări ale transformatoarelor sînt acordate.

Explicați cum se folosește tranzistorul în etajul mixer

Rolul schimbătorului de frecvență sau al etajului mixer este evident același ca și în receptoarele cu tuburi. Cu ajutorul unui proces de heterodinare diferitele frecvențe ale semnalelor recepționate sînt convertite într-o singură frecvență fixă, de obicei 460 kHz, ce se aplică la intrarea amplificatorului FI. Informația audio este transportată de semnalul de radiofrecvență ca o modulație de amplitudine în recepția MA (sau a frecvenței în recepția MF) și aceasta este transferată purtătoarei FI. Frecvența intermediară este situată deasupra benzii audio și prin urmare poate fi numită frecvență supersonică: aceasta combinată cu cuvîntul heterodină, cu mulți ani în urmă a format noul cuvînt „superheterodină”, care se aplică azi receptoarelor. Receptorul „acordat pe frecvența radio” este astăzi demodat.

Funcțiile de mixare și oscilație trebuie combinate într-un mod oarecare într-un singur etaj în receptor. Deși se pot folosi două tranzistoare cu componentele asociate, este absolut normal ca un singur tranzistor să facă tot ceea ce este necesar.

O proiectare atentă înlătură diferența dintre performanțe și desigur se reduce prețul, factor de mare importanță în producția radioreceptoarelor în serie de masă.

Un astfel de etaj se numește mixer auto-oscilant iar în fig. 30, sînt reprezentate trăsăturile sale esențiale. Circuitul din bază este acordat pentru a recepționa semnalul de radiofrecvență de la intrare în timp ce circuitul de ieșire este acordat pe frecvența intermediară a semnalului de ieșire. Circuitul de reacție LC dintre colector și emitor realizează oscilația iar frecvența intermediară

reprezintă diferența dintre frecvența radio de la intrare și frecvența etajului auto-oscilant.

În fig. 31, se reprezintă un etaj mixer auto-oscilant cu tranzistor OC 44.

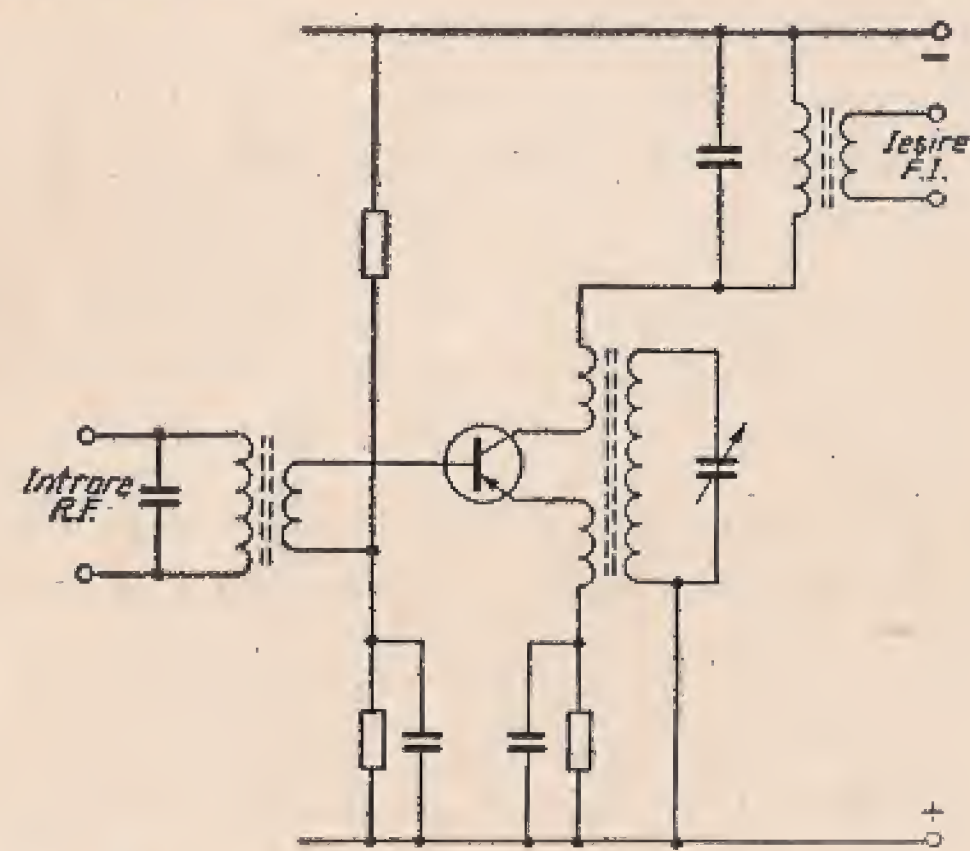


Fig. 30. Etaj mixer-oscilator. Acest circuit este un mixer aditiv.

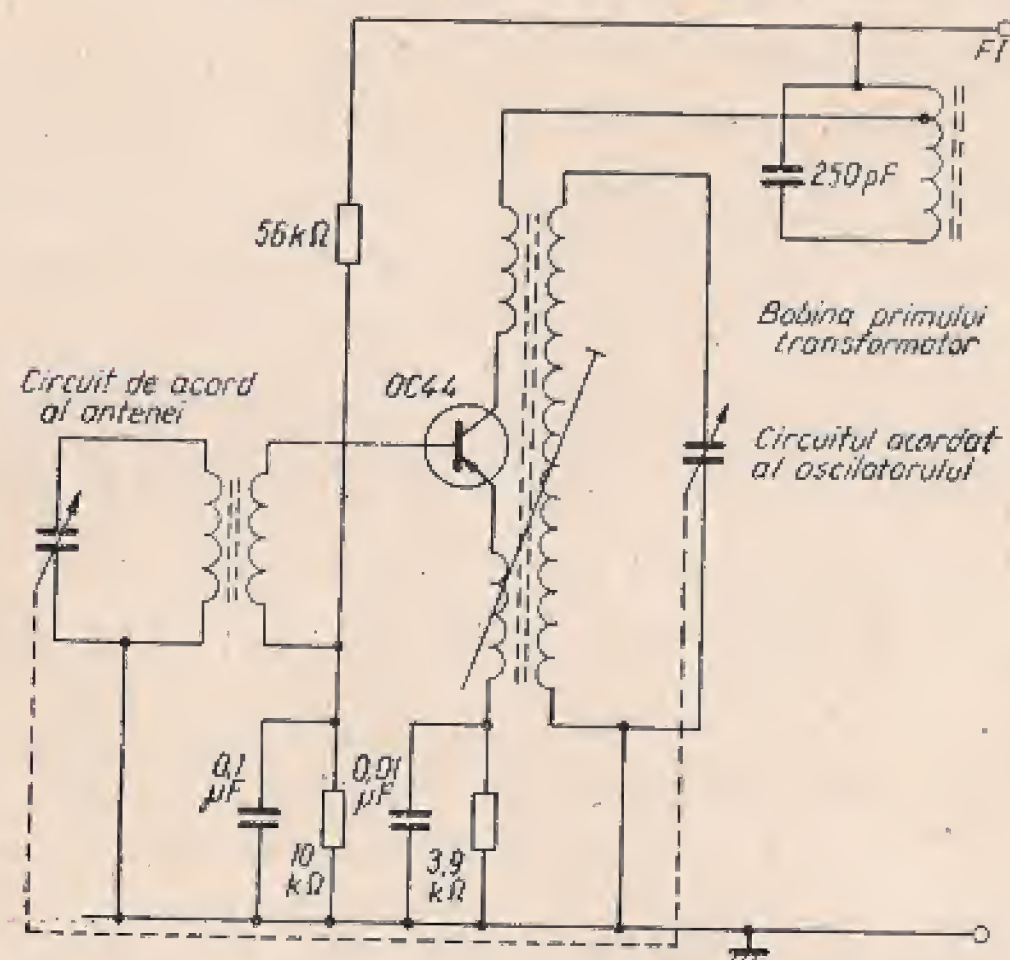


Fig. 31. Etaj mixer-oscilator folosind tranzistorul OC 44.

Sînt reprezentate componentele numai pentru o singură bandă, pentru alte benzi în circuit se introduc alte inductoare și alte capacitoe. Pentru a asigura pornirea ușoară a oscilatorului tranzistorul este polarizat inițial în clasa A de funcționare cu ajutorul a două rezistoare ce lucrează ca un divizor de tensiune. (56 KΩ și 10 KΩ). Pe măsură ce oscilațiile cresc dioda bază-emitor redresează semnalul generat; aceasta determină o tensiune continuă negativă pe rezistorul din emitor și pe capacitorul său de decuplare, provocînd intrarea tranzistorului în clasa B de funcționare. Amplitudinea oscilației este stabilizată de schimbarea de tensiune de la emitor.

Cum se combină toate aceste etaje într-un receptor?

În fig. 32, este reprezentat circuitul unui receptor portabil cu șase tranzistoare care ilustrează modul de îmbinare a caracteristicilor fiecărui etaj. În acest receptor se folosesc trei tranzistoare de frecvențe înalte, un OC 44 și două OC 45 pentru mixer și etajele FI. Detectorul este realizat cu o diodă cu germaniu de tip OA 70. În etajele de audio se găsesc trei tranzistoare — un OC 71 ce comandă două OC 72 împerechiate care formează etajul push-pull simetric în clasă B. Se remarcă eliminarea transformatorului de ieșire: în acest montaj impedanța de ieșire este astfel redusă încît etajul poate fi adoptat la impedanța ridicată a difuzorului (75 Ω). (Difuzoarele convenționale au impedanțe de 3 Ω și 15 Ω).

Radioreceptorul folosește o antenă magnetică (situată în interiorul receptorului). Bobinele de impedanță mică cuplează circuitul acordat din antenă la baza tranzistorului OC 44, care este folosit ca mixer auto-oscilant. Frecvența intermediară se extrage din tranzistorul OC 44

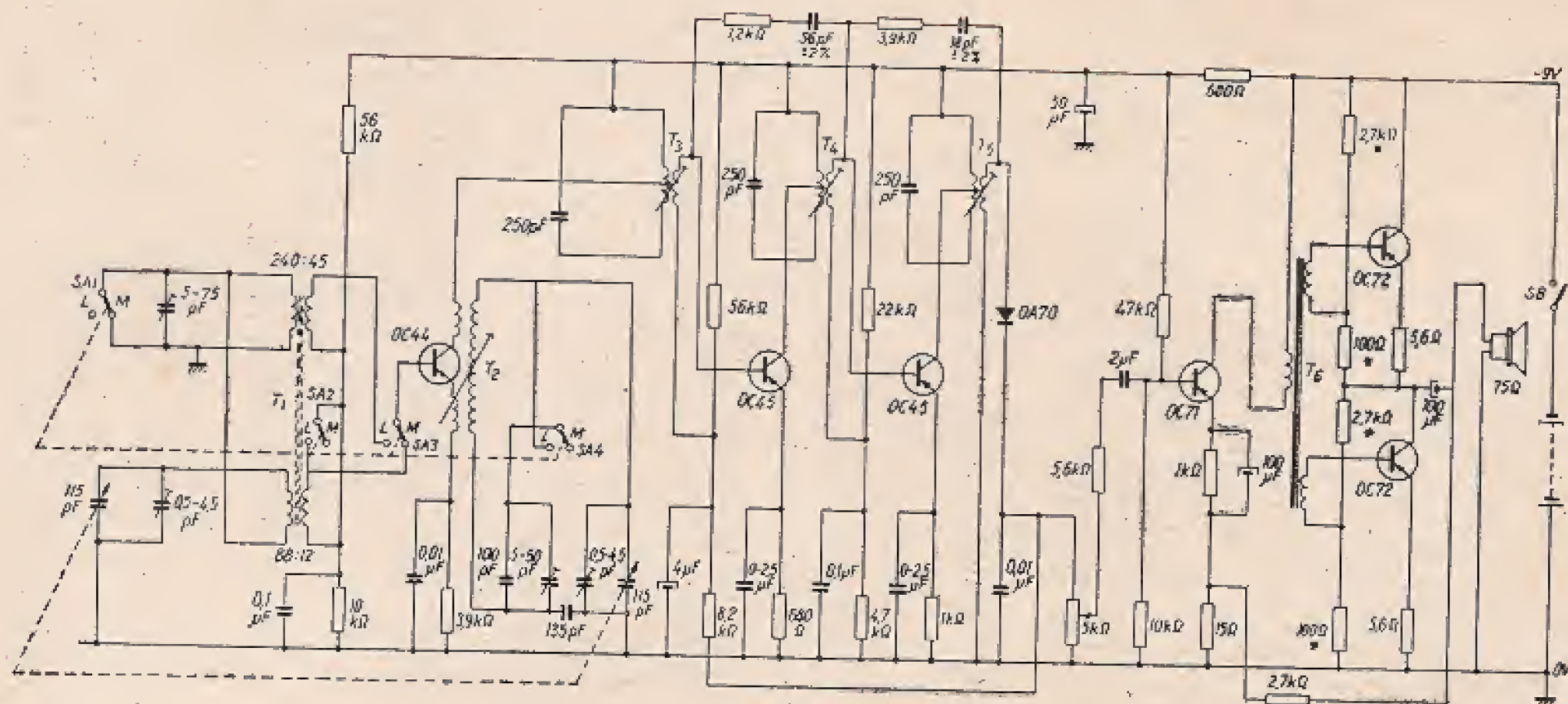


Fig. 32. Receptor superheterodină folosind șase tranzistoare aliate.

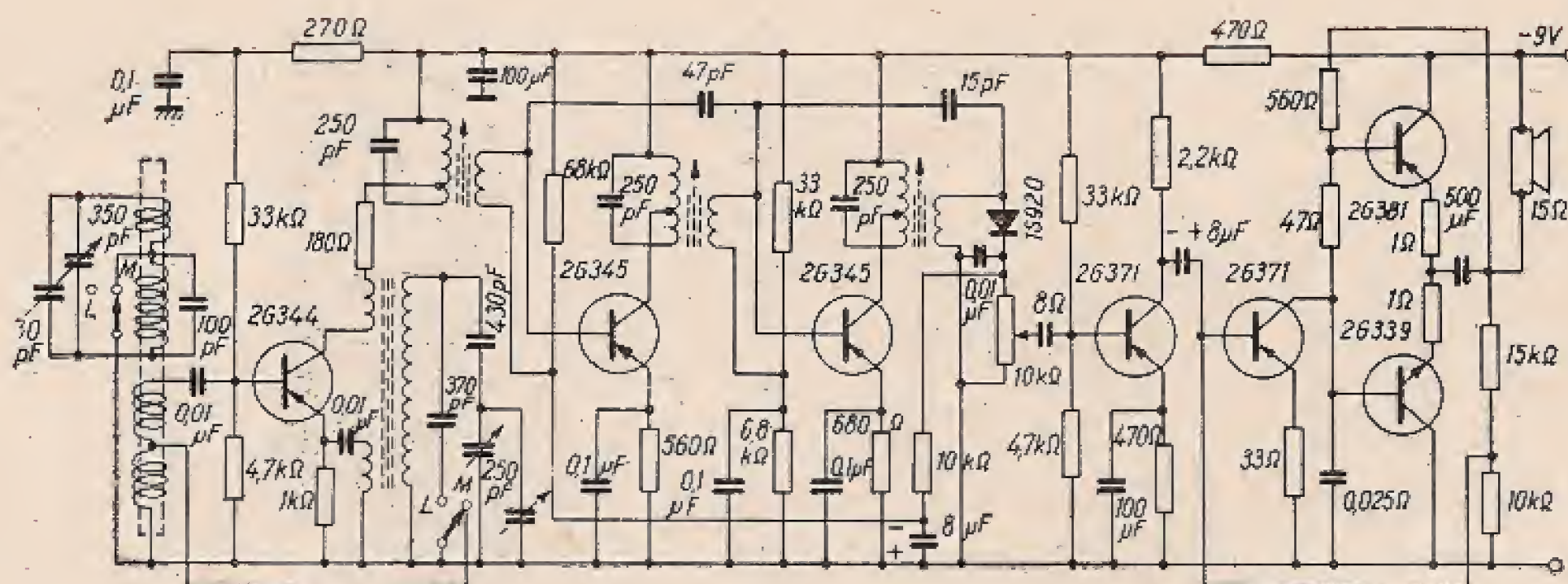


Fig. 33. Receptor superheterodină cu șapte tranzistoare aliate și două lungimi de undă. Bobinele de intrare sînt înfășurate pe o antenă de ferită. Capacitoarele de reacție (47 pF și 15 pF) se folosesc pentru a asigura neutralizarea celor două etaje amplificatoare de frecvență intermediară, frecvența intermediară fiind de 465 kHz. Etajul de ieșire clasă B cu o pereche complementară de tranzistoare se conectează la difuzorul de 15 Ω . Puterea maximă de ieșire este de 0,5 W. Consumul în absența semnalului este de 10 mA și 40 mA pentru puterea de 50 mW.

cu ajutorul primului transformator de frecvență intermediară $T3$ iar cele două tranzistoare OC 45 formează primul și al doilea etaj amplificator FI. Pentru a asigura o bună stabilitate se folosește metoda unilateralizării despre care s-a vorbit anterior. Semnalul audio este cules de la detector prin potențiometrul de volum ($5\text{ k}\Omega$) și aplicat tranzistorului OC 71, și un semnal continuu de la detector și întors la primul etaj FI pentru a asigura CAA.

În fig. 33 se reprezintă un receptor cu șapte tranzistoare ce realizează o putere de ieșire de $0,5\text{ W}$. Circuitul diferă de primul în principal prin existența a două etaje de amplificare audio urmate de un etaj de ieșire format dintr-o pereche complementară de tranzistoare conectate clasă B acest etaj fiind cuplat cu un difuzor de $15\ \Omega$.

Ce este un cablaj imprimat și cât de mult se folosește?

Cablajele imprimate sînt larg folosite nu numai în radiourile cu tranzistoare ci de asemenea în calculatoare și o varietate de echipamente electronice industriale și mi-



Fig. 34. Exemplu de cablaj imprimat. Canalele negre de material conductor formează „cablajul”. Terminalele componentelor se introduc în găurile arătate și sudate.

litare. El are forma unor fișii metalice subțiri (cablajul) fixate pe o placă izolatoare, pe care pot fi montate componentele-rezistoare miniatură, capacitore, etc. care completează circuitul.

Uneori componentele înșile, precum și firele de legătură, sînt realitate prin metoda imprimării, iar apoi placa completă este pe drept cuvînt numită circuit imprimat. În figura 34 se reprezintă un exemplu tipic de cablaj imprimat.

Cum se realizează cablajul imprimat?

Pe scurt, în metodele curenț folosite forma cablajului, adesea foarte complex, este desenat (pictat) pe suprafața foliei de cupru ce acoperă banda subțire de material izolant, iar suprafețele de cupru nepictat sînt îndepărtate prin corodare. Ca metode de desenare se folosesc fotografierea, procesul silk-screen sau litografic. Pentru corodare se folosește clorura ferică.

Placa este prevăzută apoi cu găuri prin care trec terminalele componentelor. În general, componentele sînt situate de o parte a plăcii iar terminalele de cealaltă. Terminalele trebuie să fie sudate apoi la punctele corespunzătoare de pe cablajul imprimat.

Toate sudurile pot fi realizate într-o singură operație prin scufundarea părții cu conexiuni pentru cîteva secunde într-o baie de sudură. Aceasta se face economic prin folosirea sudurii selective. Se aplică un strat de aliaj pe suprafețele unde nu urmează să se realizeze conexiuni, iar părților rămase se aplică un flux. În final scufundarea în aliajul de lipit completează operația de sudură.

Care sînt avantajele cablajului imprimat?

Dezvoltarea cablajelor imprimate a avut loc în paralel cu miniaturizarea componentelor, astfel încît a fost posibilă realizarea unor ansamble mai compacte și mai ușoare. Despre rapiditatea sudurii s-a menționat deja iar

un alt factor este reducerea diferitelor capse și cose care sînt folosite în număr mare în cablajele convenționale.

Prin urmare este posibilă realizarea unor ansamble mai simple și mai rapide: crescînd viteza de realizare prețurile scad. De asemenea, se consideră că se reduc substanțial legăturile electrice greșite (numite de obicei legături uscate sau seci).

Sînt posibile dezvoltări viitoare ale cablajelor imprimate?

Etapa următoare este deja pornită: folosirea circuitelor integrate în echipamentele electronice. În circuitele integrate cele cîteva tranzistoare împreună cu rezistoarele, capacitorele și interconexiunile asociate lor sînt formate pe un singur cip de siliciu, cu fire ce merg spre exterior pentru conectarea la sursa de polarizare, alte componente necesare sau pentru semnalul de intrare și ieșire. Un prim model de circuit integrat folosit în radioreceptoare folosesc trei tranzistoare în etajele push-pull și driver iar toate operațiile cu semnale mici sînt realizate de un circuit integrat care cuprinde douăsprezece tranzistoare și unsprezece rezistoare. Circuitul integrat realizează funcțiile, de schimbător de frecvență, amplificare FI, detectare, control automat al amplificării și preamplificării audio. Antena și circuitele acordate din oscilator sînt convenționale iar în circuitele FI acordate se folosește un filtru ceramic. Toate circuitele acordate sînt exterioare circuitului integrat.

Cît de mult se folosesc tranzistoarele în televiziune?

Folosirea tranzistoarelor în receptoarele de televiziune este suficient de extinsă. Tuburile sînt totuși predominante. Tranzistoarele folosite în TV trebuie să satisfacă

cerințe tehnice deosebite, care adesea sînt diferite de cele dintr-un radioreceptor. Problema se referă parțial și la preț, un receptor TV este complex avînd un număr mare de etaje amplificatoare sau alt tip.

S-au realizat deja receptoare TV portabile cu tranzistoare. Avantajele folosirii tranzistoarelor în astfel de receptoare sînt foarte evidente: sursa de alimentare a aparatului este suficient de ușoară ea nefiind o problemă practică, în cazul folosirii tuburilor.

Receptoarele portabile sînt suficient de compacte — potrivite folosirii în automobil — deși dimensiunile reale depind de mărimea tubului cinescop. O reducere substanțială a ecranului nu poate fi acceptabilă, în ciuda avantajului portabilității. Pe de altă parte, o problemă cu totul diferită este aceea că un cinescop mare înseamnă în mod corespunzător creșterea sursei de alimentare pentru circuitele asociate. În receptoarele TV, ca și în alte tipuri de echipamente electronice alimentate de la baterie, tensiune de alimentare scade pe măsură ce bateria se descarcă, iar aceasta pune problema asigurării acelor parametri care nu variază în limite prea largi. Efectele variațiilor de tensiune în receptoarele de televiziune vor fi mult mai serioase decît în receptoarele radio. Dar utilizatorul unui aparat portabil va fi uneori în apropierea unei rețele de alimentare și prin urmare în aparat se introduce un bloc de alimentare de la rețea precum și o baterie. În general în receptoarele de televiziune complet tranzistorizate se introduce un circuit de stabilizare a tensiunii pentru rezolvarea acestei probleme.

Tranzistoarele sînt din plin folosite în receptoarele alimentate de la rețea, îndeosebi în acele secțiuni ale circuitului unde se obțin anumite beneficii cum ar fi în secțiunile de radiofrecvență și frecvență intermediară. De asemenea tranzistoarele se folosesc în camerele de tele-

viziune, inclusiv cele folosite în sistemele cu circuit închis din industrie. Tranzistoarele se folosesc în preamplificatorul de antenă, care se înserează la cablul antenei: această aplicație s-a răspândit odată cu extinderea transmisiilor UHF din benzile IV și V.

Tranzistoarele de frecvență înaltă ce lucrează în configurația bază-comună au performanțe superioare față de tuburile electronice existente și prin urmare au fost adoptate pe scară largă în unitățile acordate din UHF. În mod frecvent se folosește un rezistor dependent de tensiune pentru a regla linia de alimentare.

Folosirea tranzistoarelor în amplificatoarele Hi-Fi oferă avantaje?

Cele mai multe dintre avantajele folosirii tranzistoarelor în echipamentele radio în general sînt de asemenea importante într-un grad oarecare și în amplificatoarele de înaltă fidelitate (Hi-Fi) specializate; trebuie reținută, absența problemei ventilației, datorită temperaturilor de lucru joase, de asemenea posibilitatea reducerii dimensiunilor deși în prezent miniaturizarea arareori reprezintă un scop al proiectantului în echipamente de înaltă fidelitate. Tranzistoarele se folosesc cel mai mult acolo unde se cere reunirea tuturor circuitelor de intrare, dispozitivelor de control și a etajelor de ieșire pe un singur șasiu de dimensiuni moderate.

Tranzistoarele sînt mai eficiente și prin urmare sursa de alimentare a amplificatorului poate fi redusă ca volum și va determina un zgomot redus (considerînd că se folosește o sursă de curent continuu). Posibilitatea de a renunța la transformatorul de ieșire este foarte atractivă astfel încît în mod practic toate amplificatoarele stereo au etajele de ieșire fără transformator. Circuitele fără

transformatoare folosind tuburi electronice au fost proiectate anterior și s-a constatat că, printr-o proiectare foarte atentă, se pot obține performanțe excepționale în ce privește semnalele tranzitorii. Totuși, în mod normal nu se puteau obține impedanțe de ieșire mai mici de cîteva sute de ohmi, iar bobinele difuzoarelor trebuie să fie de o construcție specială pentru a asigura o adaptare corectă. Prin folosirea tranzistoarelor nu apare problema reducerii impedanței de ieșire astfel că se pot conecta la ieșire direct difuzoare convenționale de 15Ω (sau mai mici).

În general apare problema acută a asigurării performanțelor în standarde cerute la un preț acceptabil. Cele mai dezvoltate amplificatoare, de standarde profesionale, sînt relativ complexe, și pentru acest motiv recent s-au proiectat cîteva modele noi cu tuburi și nu cu tranzistoare. Această situație se va schimba pe măsură ce tranzistoarele, tipurile de putere mare, vor fi disponibile la un preț acceptabil. Este foarte probabil că tranzistoarele cu siliciu vor fi cel mai mult folosite.

Despre tipurile de etaje de ieșire folosite

Pînă acum au fost folosite cîteva tipuri ale etajului de ieșire clasa B. Tipul cel mai simplu a fost prezentat în figura 26, dar acesta cuprinde un transformator de ieșire. Calea cea mai simplă pentru a elimina transformatorul este folosirea unui montaj push-pull simetric serie, așa cum se arată în fig. 35. Aici tranzistoarele de ieșire sînt în serie cu sursa de alimentare, dar ele sînt în paralel cînd se conectează difuzorul. Impedanța sarcinii necesare este un sfert din cea a montajului push-pull convențional, de fapt fiind conectat un difuzor de 15Ω dacă se folosesc tranzistoare adecvate.

Totuși, acesta rămâne un etaj în clasă B și este expus distorsiunii de suprapunere care apare când un tranzistor din pereche se suprapune peste celălalt.

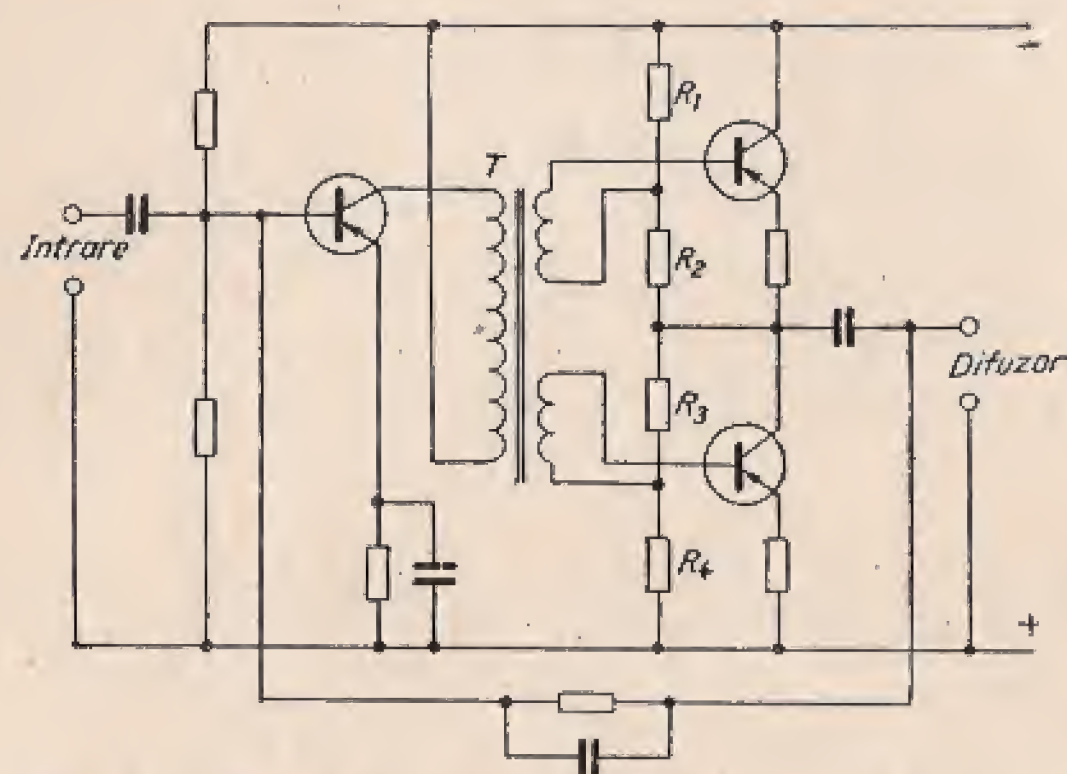


Fig. 35. Etaj de ieșire push-pull clasă B simetric.

Acest fapt ar milita împotriva performanței de înaltă calitate dar poate fi redus printr-o polarizare ajustabilă astfel încât în absența semnalului curentul emitor este mic.

În schema prezentată rezistorul R_1 , R_2 , R_3 și R_4 , lucrează ca un divizor de tensiune, asigurând polarizarea. Pentru a rezolva compensarea efectelor schimbării temperaturii în rețeaua de polarizare se interconectează uneori termistoare: alteori se poate folosi o diodă stabilizatoare pentru polarizare, care de asemenea asigură stabilitatea împotriva schimbărilor de tensiune.

În amplificatorul de înaltă fidelitate, în locul transformatorului defazor T se folosește un defazor cu tranzistoare, care este o altă cauză probabilă de distorsiune.

O altă metodă practică este înlocuirea transformatorului T cu un etaj de comandă simetric-complementar așa cum se arată în figura 36.

Primul etaj cu tranzistor *pnp* alimentează în paralel perechea simetrică complementară. Dacă acest etaj lucrează în clasă B, fiecare amplifică o semialternanță: tranzistorul *pnp* va amplifica semialternanța negativă în timp ce tranzistorul *nnp* semialternanța pozitivă. Acest etaj va comanda etajul de ieșire clasă B push-pull.

În fig. 36 se arată de asemenea o metodă de stabilizare prin dioda D de polarizare. Caracteristica neliniară tensiune-curent a diodei arată că tensiunea la bornele ei scade cu mult mai încet decât curentul ce trece prin ea (curentul depinde de tensiunea bateriei). De asemenea, tensiunea scade cu creșterea temperaturii. Această caracteristică compensează etajul driver împotriva variațiilor temperaturii și tensiunii de alimentare.

Sînt importante aplicarea cu grijă a reacției negative și împerecherea tranzistoarelor de ieșire.

Tranzistoarele din etajele de ieșire ale unui amplificator stereo lucrează în așa-numitul mod — π al clasei AB. În acest caz, condițiile de polarizare se schimbă în acord cu nivelul semnalului de intrare și scopul este de a asigura un semnal de ieșire cît mai mare posibil (aproximativ de 10 W pe canal) cu distorsiune minimă. Circuitul (un canal) este reprezentat în figura 37.

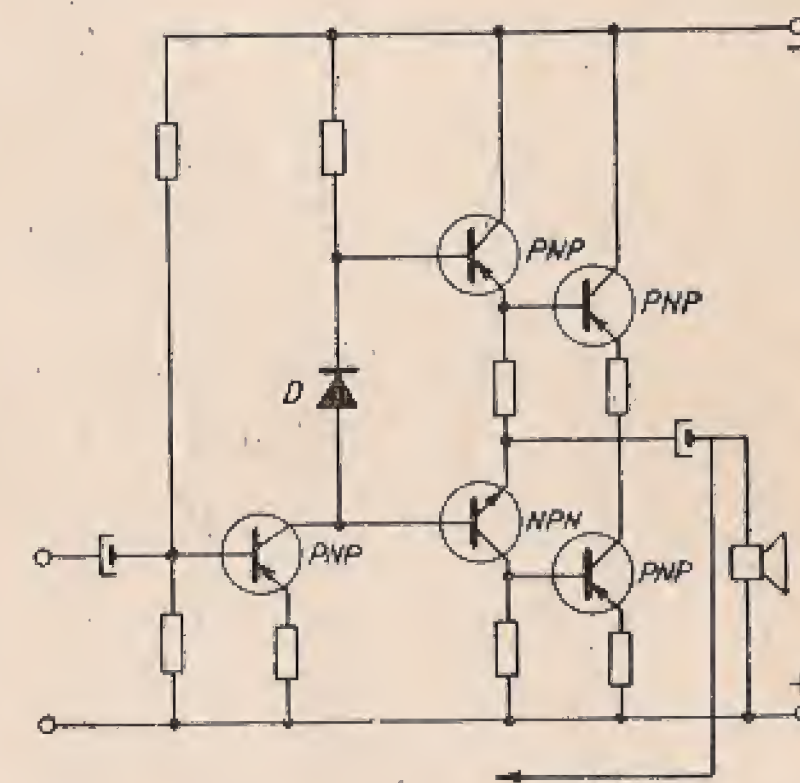


Fig. 36. Amplificator de putere. Un etaj de comandă (driver) cu o pereche de tranzistoare complementare este conectat la etajul de ieșire push-pull simetric. Toate etajele sînt cuplate direct.

În acest mod de funcționare curentul total este constant, iar pînă cînd ajunge la 40% etajul de ieșire lucrează în clasă A. După aceasta, există un domeniu în

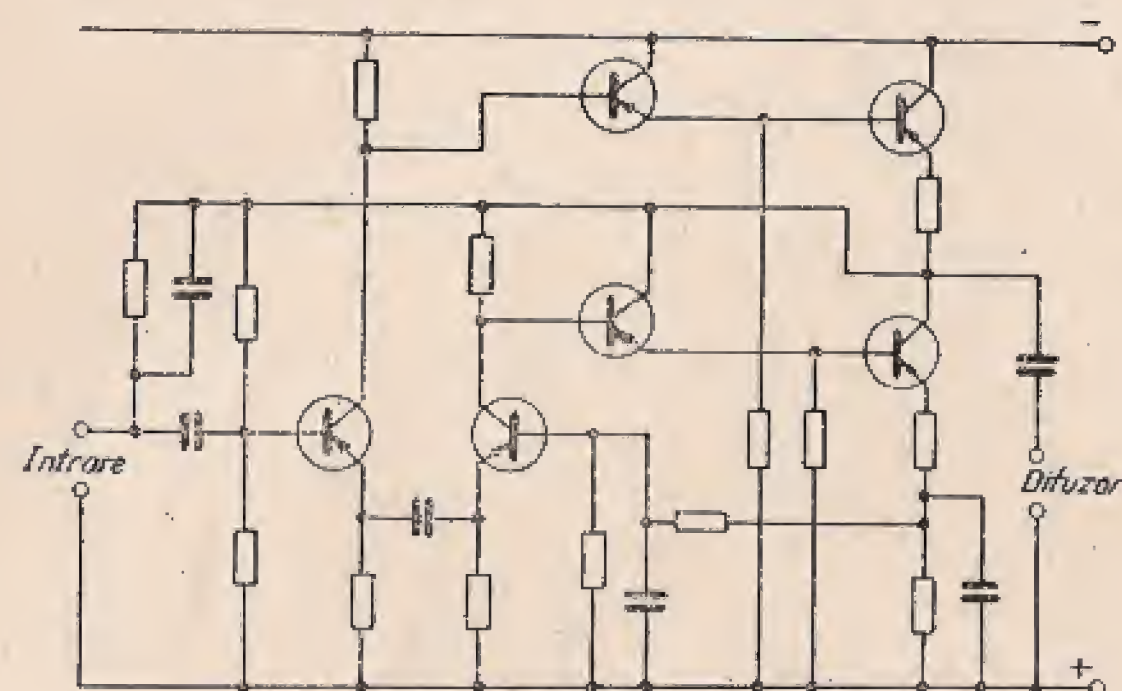


Fig. 37. Circuit clasă AB în mod π .

care tranzistoarele lucrează în clasă AB; dar la întreaga capacitate ele lucrează în clasă B. Acest montaj inedit reduce distorsiunea de suprapunere precum și alte feluri de distorsiuni.

La bornele de intrare ale unui amplificator, cerințele unui utilizator sînt aceleași ca și la amplificatoarele cu tuburi. În fig. 38 se arată cum se realizează aceste cerințe într-un amplificator modern. Acesta este un amplificator stereo integrat. Pentru claritate s-a prezentat numai un canal. Din această secțiune care cuprinde selectorul de intrare și egalizorul caracteristicii de înregistrare, semnalul este trecut în filtru și circuitul de control al tonului și apoi în etajul de ieșire.

Acum se comercializează amplificatoare cu tranzistoare de înaltă fidelitate în clasă A. Funcționarea în clasă A se realizează prin polarizarea tranzistoarelor montate în push-pull la mijlocul caracteristicii de funcționare, curentul mediu de colector rămînînd același dacă sem-

nalul este sau nu prezent. Deoarece tranzistoarele lucrează permanent la disipație maximă puterea de ieșire obținută este mai mică decît în clasă B. Întrucît tranzis-

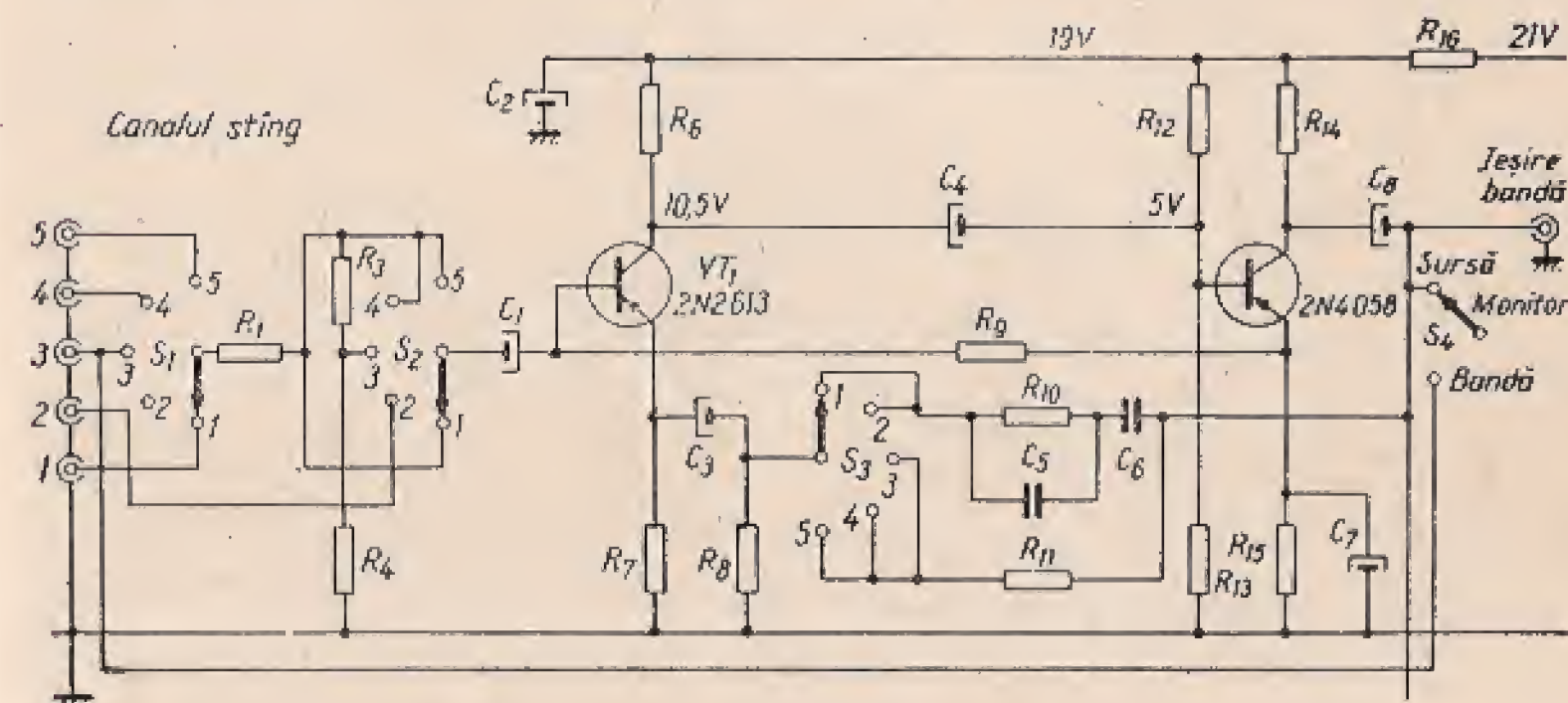


Fig. 38. Circuit de intrare al unui amplificator stereo Truvox TS A200. Canalul de stînga.

toarele se încălzesc, existența radiatorul devine esențială: tranzistoarele moderne cu siliciu lucrează satisfăcător în aceste condiții.

Cît de mult se folosesc tranzistoarele în magnetofon?

Tranzistoarele se folosesc pe scară largă în magnetofonele portabile și desigur dezvoltarea componentelor miniaturizate și a cablajelor imprimate au avut o influență importantă asupra mărimii și greutății acestor echipamente, exact cum s-a întîmplat în cazul radioului și a picupului. În ultimii ani a apărut o varietate largă de magnetofone alimentate de la baterie.

Avantajele folosirii tranzistoarelor sînt evidente, deși mai puțin spectaculoase, față de magnetofonele alimentate la rețea. Spre exemplu, există problema ventilației

la magnetofonele care, deși folosind un număr mare de tuburi, sînt proiectate să fie compacte și transportabile.

Tranzistoarele înlătură această problemă a ventilației. Un alt avantaj este cel al eliminării timpului de încălzire: este avantajos ca pornirea și redarea să poată avea loc în orice moment.

Toate circuitele oscilatoare și amplificatoare din magnetofon pot folosi tranzistoare: în fig. 39 se arată un oscilator polarizat. Acest oscilator proiectat pentru o frecvență de 40 KHz, este alimentat de o baterie de 9 V și asigură la ieșire o putere de 50 mW pe o sarcină de 180 Ω . Circuitul este alcătuit dintr-un tranzistor cu circuit acordat în colector și emitorul la masă, ieșirea fiind luată din circuitul acordat din colector.

Potențiometrul R_3 controlează reacția negativă datorită rezistenței de stabilizare din emitor parțial nedecuplată și care se ajustează pentru a realiza distorsiune minimă.

Fig. 39. Oscilator pentru magnetofon.

Q_1 NKT 274 R_1 820 Ω
 D_1 25 μF R_2 680 Ω
 C_2 2 μF R_3 25 Ω
 C_3 0,002 μF R_4 150 Ω
 R_L aproximativ 180 Ω R_1 R_2 și R_4 cu o toleranță de 10%. N_S 9 μH , N_P 900 μH .

Oferă tranzistoarele avantaje în serviciile publice?

În acest domeniu există avantaje notabile. La un moment dat, în ciuda cerinței echipamentului portabil ușor, a fost necesar să se folosească amplificatoare grele și destul de complexe, cum ar fi unele unități speciale ce absorbau curenți din bateriile de alimentare și amplificatoarele de curent alternativ alimentate de la baterie prin convertoare. Dezvoltarea echipamentelor tranzisto-

rizate a fost binevenită, permițînd apariția echipamentelor portabile care sînt relativ eficiente și simple.

Un alt avantaj este că echipamentul este suficient de robust pentru condițiile de lucru obișnuite. Puterile de

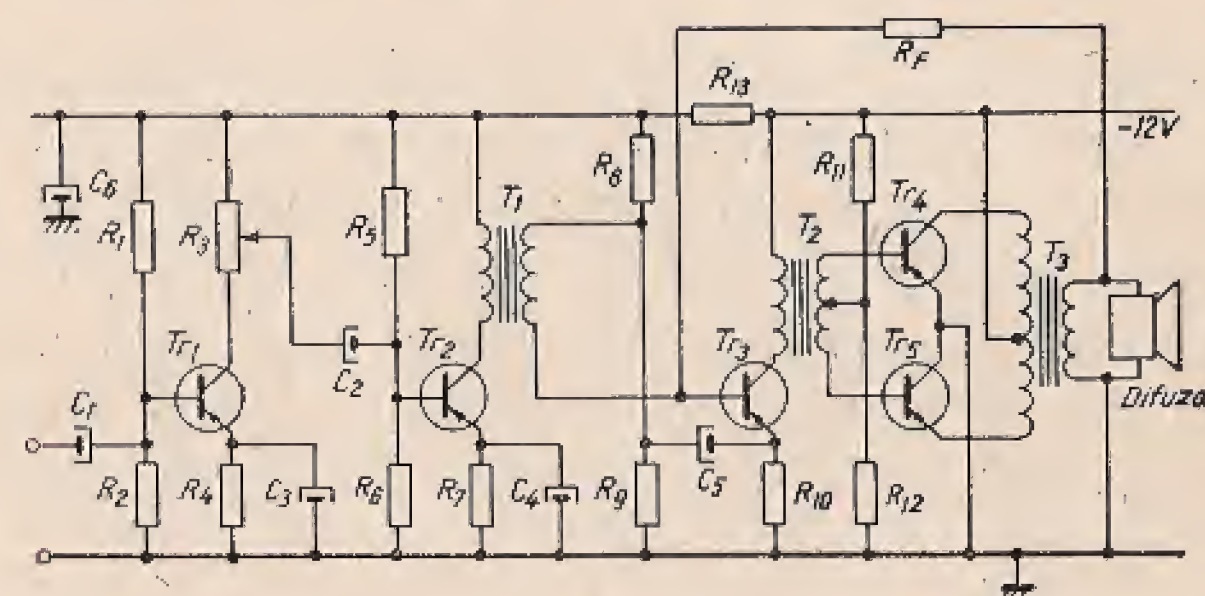


Fig. 40. Amplificator audio de putere, 20 W la 12 V:

Q_1 NKT 275	C_1 10 μF	R_1 220 Ω	R_8 180 Ω
Q_2 NKT 272	C_2 10 μF	R_2 47 K Ω	R_9 10 Ω
Q_3 NKT 453	C_3 10 μF	R_3 15 K Ω	R_{10} 1 Ω
Q_4 NKT 453	C_4 10 μF	R_4 5,6 K Ω	R_{11} 330 Ω
Q_5 NKT 453 } x	C_5 2000 μF	R_5 4,7 K Ω	R_{12} 3 Ω
	C_6 100 μF	R_6 4,7 K Ω	R_{13} 47 Ω
x pereche		R_7 560 Ω	R_F 33 K Ω

ieșire ce se pot realiza sînt suficient de mari pentru a fi utile în cele mai multe aplicații unde problema portabilității este de asemenea importantă. Aceasta este valabil îndeosebi pentru instalațiile mobile.

În fig. 40 se arată circuitul unui amplificator reprezentativ. Alimentat de la o baterie de 12 V, acest amplificator va realiza o putere de 20 W pe o sarcină de 15 Ω . Întrucît sensibilitatea este de 10 mV ar fi posibil să fie folosit cu un picup cu reluctanță variabilă, dar o ușoară modificare va permite unui picup cu cristal să fie conectat la acest amplificator.

Acest circuit este alcătuit dintr-un preamplificator clasă A cu cuplaj RC cu emitorul cuplat la masă urmat de un etaj amplificator clasă A cuplat prin transformator

și emitorul la masă; semnalul se aplică unui etaj de comandă în clasă A și de aici etajului ieșire clasă B push-pull de emitorul la masă.

Tranzistoarele se pot defecta?

Tranzistoarele sînt mult mai robuste decît tuburile electronice și au o viață de funcționare lungă. Pe bună dreptate s-a spus că un tranzistor folosit în orice mod în limitele caracteristicilor sale va dura aproape la nesfîrșit. Totuși, fiecare tranzistor are un set particular de condiții de lucru care sînt specificate de fabricant, iar folosirea incorectă poate să-l deterioreze sau chiar distruge joncțiunile sau alte părți.

Spre exemplu, o tensiune excesivă poate determina defecte serioase. Deși tranzistorul este un dispozitiv rece comparativ cu tubul electronic, în mod normal există o pierdere de putere și prin urmare apare o ușoară creștere a temperaturii. Dar anumite condiții (cum ar fi unele circuite defecte) pot permite trecerea unui curent excesiv ce va determina supraîncălzirea și chiar topirea electrozilor.

Sursele de căldură exterioară, aplicate în mod accidental, pot determina defecte. Printr-o întîmplare se poate folosi pentru sudură un ciocan incorect. Alte surse externe includ camerele de depozitare supraîncălzite, cutiile de împachetare ermetic închise care provoacă încălzirea.

Precauții necesare

Așa cum s-a arătat mai sus, este esențial să ne asigurăm împotriva condițiilor de lucru incorecte din punct de vedere electric și să eliminăm sursele de căldură ce vor ridica temperatura peste limitele de siguranță.

Temperaturile de lucru ale tranzistoarelor cu siliciu pot fi mai mari decît a celor cu germaniu.

Pentru tranzistoarele de putere, precum cele folosite în etajele audio de ieșire, este necesar să se prevadă radiatoare. Acesta poate avea forma unui colier care va disipa căldura prin radiație. În multe cazuri colierul este unit cu șasiul amplificatorului, care conduce și disipă o cantitate considerabilă de căldură. Uneori tranzistoarele se localizează direct pe șasiu, realizînd contactul termic cu metalul. În alte cazuri se folosesc aripioare mari pentru a obține cea mai mare arie de radiație posibilă.

Fără un radiator tranzistorul se poate *ambala termic*. Disipația de căldură în joncțiunea tranzistorului ridică temperatura locală; aceasta crește curentul rezidual, care în schimb crește disipația și mai mult. Acest proces se oprește numai după ce tranzistorul s-a distrus.

Astfel de probleme desigur se au în vedere în etapa de proiectare a echipamentului, dar unele precauții, care în principiu sînt similare cu acestea, sînt necesare în timpul reparației echipamentului.

În particular este important să se țină terminalele unui tranzistor cu cleștele cînd se sudează sau înlocuiește. Aceste clește, așezat între tranzistor și ciocanul de sudură acționează ca o aripioară de răcire. Este important să se folosească un ciocan legat la pămînt: între pămînt și vîrfurile ciocanului poate exista o diferență de potențial de cîteva volți, potențial ce poate determina trecerea prin tranzistor a unui curent ce-l poate distruge.

De asemenea, instrumentele de măsură trebuie să aibă o tensiune de ieșire foarte mică (fabricanții anunță o tensiune maximă de 1,5 V) iar pentru anumite încercări este mai înțelept să se scoată tranzistorul din circuit. Echipamentul aflat la testat ar trebui scos din alimentare înainte de a se schimba componentele, eliminînd posibilitatea

aparitiei curenților tranzistorii ce ar afecta tranzistoarele. O joncțiune scurtcircuitată reprezintă tipul de greșeală determinat de neatenția față de cele spuse mai sus. O joncțiune în gol este de obicei determinată de o supraîncărcare posibilă datorită unei greșeli oriunde în echipament.

Cu o anumită grijă deteriorarea mecanică se poate evita. Totuși, conductoarele terminale nu trebuie să fie tensionate sau prea aproape de șasiu.

5

r.tv. r.fv. r.tv. r.fv. r.tv. r.fv.

Alte dispozitive semiconductoare

Ce alte dispozitive se mai cunosc?

De o importanță deosebită sînt diodele zener și vari-cap apoi tranzistoarele unijoncțiune, diodele tunel și foto-tranzistoarele. De asemenea mai există dispozitivele cu patru straturi ($pnpn$) cum sînt redresoarele cu siliciu comandate.

Dioda tunel

Acest dispozitiv, o invenție japoneză, are o caracteristică cu „rezistență negativă”. Este util să se compare această caracteristică cu cea a unui rezistor obișnuit — dispozitiv liniar în care curentul este direct proporțional cu tensiunea aplicată — și cea a unui dispozitiv neliniar simplu, în care curentul crește într-un mod neliniar cu tensiunea aplicată. Această comparație este ilustrată în fig. 41.

Se remarcă comportarea ceva mai deosebită a diodei tunel. La început curentului crește odată cu creșterea tensiunii pînă se atinge o anumită valoare, în continuare creșterea tensiunii deter-

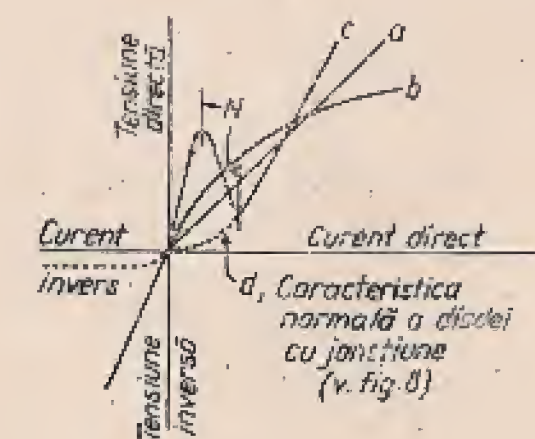


Fig. 41. Caracteristica diodei tunel c comparată cu caracteristicile liniară a și neliniară b . N reprezintă regiunea de rezistență negativă iar d reprezintă caracteristica unei diode cu joncțiune normală.

mină o micșorare a curentului iar după ce se atinge un minim curentul începe să crească din nou. Astfel apare o regiune cu „rezistență negativă”, notată cu N pe diagramă, unde se reprezintă de asemenea caracteristica diodei cu joncțiune.

Caracteristicile diodei tunel se datoresc dopării puternice a regiunilor p și n . Ca rezultat al acestei dopări apare o creștere constantă a curentului invers când crește tensiunea inversă în timp ce în sens direct există o creștere puternică a curentului pentru tensiuni mici directe. Acest curent inițial se numește curent de tunelare iar după aproximativ 0,15 V va scade gradat până la aproximativ 0,3 V după care va urma o scurgere normală a curentului direct. Caracteristica cu rezistență negativă se datorează schimbării între aceste două mecanisme de curgere a curentului în sens direct.

Dioda inversă este similară cu dioda tunel prin faptul că are regiunile p și n puternic dopate, dar nu are o caracteristică cu rezistență negativă. Utilitatea acestei diode constă în caracteristica inversă aproape liniară care o face un redresor eficient pentru tensiuni mici.

Ce este o diodă zener?

Diodele semiconductoare au o tensiune de străpungere — tensiunea de străpungere inversă — la care joncțiunile slăbesc permițând creșterea bruscă și importantă a curentului pentru o creștere foarte mică a tensiunii. Tensiunea la care se produce străpungerea se numește tensiune zener (vezi fig. 8). Dioda zener este concepută să lucreze într-un punct în spatele tensiunii de străpungere. Întrucât variații importante ale curentului vor produce variații foarte mici ale tensiunii la bornele diodei

dioda zener aceasta se folosește în circuite reglatoare de tensiune, ca dispozitiv de referință, dispozitiv de protecție în instrumentele de măsură.

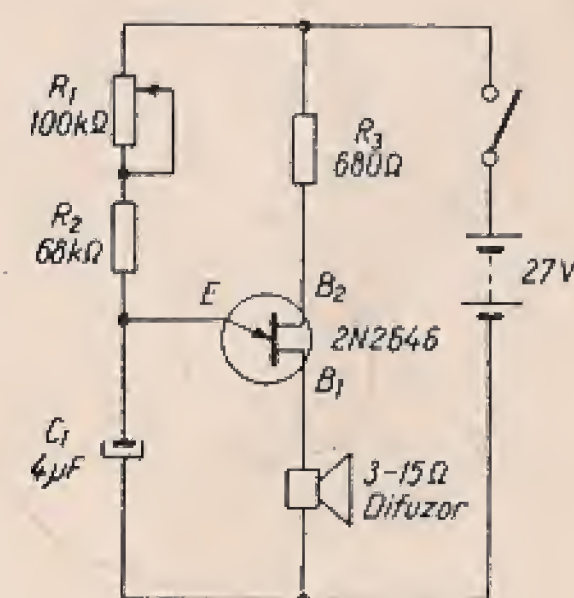
Ce este o diodă varicap?

O joncțiune pn polarizată invers are o anumită capacitate întrucât ea este formată din două straturi, regiunile p și n , separate de stratul izolator, regiunea de golire dintre cele două regiuni. Această proprietate este exploatabilă în dioda varicap sau varactor care este concepută cu o suprafață mare pentru joncțiune. Capacitatea variază cu variațiile tensiunii inverse aplicate, această proprietate fiind folosită în controlul automat al frecvenței și acordul automat.

Tranzistorul unijoncțiune

Tranzistorul unijoncțiune, sau dioda cu bază dublă, este un dispozitiv cu trei terminale care în anumite condiții prezintă o regiune cu rezistență negativă stabilă. El

Fig. 42. Metronom cu tranzistor unijoncțiune cu 90—220 bătăi, pe minut. Pentru reducerea frecvenței de oscilație se crește valoarea lui R_1 , R_2 și C_1 ; pentru a crește frecvența de oscilație se reduc valorile lui R_1 , R_2 și C_1 . C_1 se încarcă prin R_1 și R_2 când tranzistorul este blocat. Când tensiunea pe capacitor atinge o anumită valoare tranzistorul comută, C_1 se descarcă prin el. În felul acesta pe bază apare un impuls iar la ieșire, pe emitor, un impuls din te de fierăstrău.



este format dintr-o bază de siliciu de tip n care are două contacte de bază, unul la fiecare capăt al barei și o regiune a emitorului de tip p cu contact pe una din laturi. Tre-

cerea curentului între contactele de bază este controlată de curentul din emitor.

Numele acestui dispozitiv provine din faptul că este un tranzistor cu o singură joncțiune pn . În polarizarea directă joncțiunea prezintă o caracteristică cu rezistență negativă între emitor și unul din contactele bază. Dispozitivul este folosit ca oscilator (vezi fig. 42).

Redresor comandat

Așa cum se arată în fig. 43, acest dispozitiv are patru straturi de material semiconductor, formînd trei joncțiuni pn . El diferă de cealaltă diodă în principal datorită unei conexiuni externe, numită electrod de poartă.

Redresorul comandat prezintă o rezistență mare la trecerea curentului în orice direcție, dar rezistența scade brusc la o valoare mică dacă se aplică o tensiune directă care depășește o anumită valoare. După aplicarea tensiunii dispozitivul acționează ca un redresor, în care curentul curge numai în sens direct.

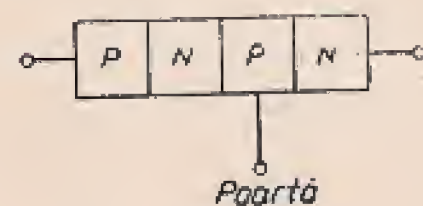


Fig. 43. Redresorul comandat are patru straturi de material semiconductor și o conexiune pentru poartă. Acest redresor se mai numește tiristor.

Poarta introduce un alt factor. Tensiunea de valoare mică aplicată porții comută redresorul comandat în starea cu rezistență de valoare coborită: adică impulsul de poartă „comandă” dispozitivul, care apoi acționează ca redresor. Redresorul comandat rămîne în această stare după ce impulsul a fost aplicat numai dacă curentul direct nu este întrerupt. Dacă se întrerupe curentul, dispozitivul revine la starea inițială pînă ce se aplică un nou impuls de comandă.

Comanda redresorului este posibilă prin varierea tensiunii aplicate în sens direct, prin varierea tensiunii aplicate pe poartă sau prin combinarea lor.

Siliciul este materialul cel mai mult folosit pentru astfel de dispozitive, de aceea se folosește frecvent denumirea de *redresor cu siliciu comandat* și adesea se folosește abrevierea RSC. Redresorul cu siliciu comandat are aplicații în comutație, tehnica reglării și în comanda motoarelor. Acest dispozitiv se mai numește și tiristor. Folosit în echipamentele industriale permite obținerea dintr-un semnal de intrare alternativ constant a unui semnal de ieșire continuu variabil.

Ce este un termistor?

Acest dispozitiv permite transformarea energiei termice în energie electrică. El este un rezistor sensibil cu temperatura construit din material semiconductor și în general are un coeficient de temperatură negativ: rezistența sa scade cînd temperatura crește. Întrucît această schimbare poate fi detectată și folosită, termistorul poate fi incorporat, să zicem, într-un circuit de măsurare pentru a corecta comportarea circuitului cînd temperatura variază. El poate fi folosit de asemenea în stabilizare pentru a reduce efectul schimbării de temperatură, și este larg folosit în lanțul filamentelor din receptoarele de televiziune pentru a evita salturile de curent în timpul alimentării. De asemenea există și termistoare ce au coeficient pozitiv de temperatură.

Dioda „trigger“

Dioda trigger este un dispozitiv $pnpn$ cu două terminale cu tensiune de declanșare. Pentru o tensiune inversă are caracteristica unei diode normale; în sens direct este

în stare de blocare pînă se atinge o valoare critică. În acest punct comută, printr-o regiune cu rezistență negativă, într-o stare de conducție, comportîndu-se apoi ca o diodă obișnuită. Dispozitivul are aplicații în circuitele de comutație. De asemenea în echipamentele de control industriale de putere se folosesc astfel de diode de putere.

Prin ce diferă fototranzistorul de un tranzistor obișnuit?

Fototranzistorul este în esență un tranzistor cu joncțiune avînd baza sensibilă la lumină. El se folosește ca amplificator și poate fi deci făcut să acționeze, printr-un releu, diferite echipamente. Posibilitățile dispozitivului sînt numeroase și folosite din plin. Spre exemplu, poate fi folosit în sistemele de alarmă antifurt, de deschidere a ușilor, control și altele.

Dispozitivele de alarmă pot cuprinde un fototranzistor și o sursă de raze infraroșii, sursa avînd forma unui far așezat sub automobil prevăzut cu un filtru pentru raze infraroșii.

Ce material se folosește în celulele solare?

Acest tip de celule în mod obișnuit folosește cristalele de siliciu, iar montajul este astfel realizat încît energia se obține datorită unui efect foto-voltaic. Joncțiunea este realizată între straturi de siliciu de tip n și de tip p , iar unul dintre straturi este suficient de subțire pentru a permite radiației solare să pătrundă prin ea și să iradieze joncțiunea. Rezultatul este că purtătorii de sarcină trec prin joncțiune eliberînd deci energie.

Pentru construirea unei baterii de celule solare este necesar foarte mult material și prin urmare este greoaie

și scumpă: de aceea se fac investigații pentru alte surse. Cercetările momentane sînt totuși legate de semiconductoare: ca și în alte dispozitive, folosirea peliculelor obținute prin evaporare, în locul cristalelor, este capabilă să asigure cel mai satisfăcător rezultat în raport cu prețul, greutatea și posibilitățile de fabricație.

Pot fi utilizate semiconductoarele pentru a produce lumină?

În această direcție s-au obținut unele rezultate. Cu aproape patruzeci de ani în urmă un savant sovietic a constatat că la trecerea curentului prin cristalele de carbură de siliciu, acestea emit lumină. Acest fenomen nu a fost luat în seamă pentru aspectele practice, dar mai tîrziu s-a observat că de fapt o varietate largă de semiconductoare ar putea prezenta fenomenul de electroluminiscență. Nu toate cristalele emit lumină vizibilă: unele dintre ele emit lumină infraroșie.

Unul din cele mai primitoare materiale, fosfura de galiu a fost folosită de cercetătorii britanici pentru construirea unei lămpi cu cristal. O sursă de lumină de acest fel poate fi foarte mică și are un consum de putere foarte mic. De asemenea în acest moment se folosește lampa cu arsenură de galiu care produce o radiație infraroșie.

Se folosesc și alte materiale semiconductoare pentru tranzistoare?

În prezent se folosesc puține alte materiale, dar cu siguranță există mulți compuși și substanțe care prezintă interes în electronică. Acestea sînt indiul, antimoniul, arsenura de galiu, sulfura de cadmiu, sulfura de plumb, oxidul de cupru și fosfura de galiu.

Ce este un circuit integrat?

Un circuit în care toate componentele și interconexiunile sînt formate pe o singură pastilă de material semiconductor reprezintă un circuit integrat. Acesta reprezintă în mare parte o dezvoltare a tehnologiei planare a siliciului: în afara difuziei prin care se formează diferite secțiuni ale tranzistoarelor, într-un circuit integrat alte părți ale circuitului, cum ar fi diodele și rezistoarele, sînt realizate prin difuzie multiplă. Completările următoare se fac prin depunere superficială pe plachetă. În acest mod se pot produce circuite complete, cum ar fi multivibratoarele, amplificatoarele mici etc. ca o singură unitate, tehnologia permițînd realizarea unei mari cantități de circuite simultan în formă microminiaturizată. Întrucît componentele active cum ar fi diodele și tranzistoarele ocupă în circuitul integrat mult mai puțin spațiu decît componentele pasive cum sînt rezistoarele sau capacitatoarele, în circuitele integrate se folosesc mult mai multe componente active decît în circuitele convenționale în care se assemblează împreună componente separate.

Ce este un circuit cu peliculă subțire?

În această metodă, circuitele complete se formează prin depunere în vid a unor straturi foarte subțiri de metale, semiconductoare și dielectrice pe un substrat izolator de susținere. Această metodă se limitează în prezent numai la componente pasive.

Ce este un circuit integrat de structură atomică?

Un circuit integrat de structură atomică reprezintă un dispozitiv format pe un monocristal semiconductor cu o lungime de cîteva sutimi de centimetru care în realizarea

operațiilor de prelucrare a semnalelor nu se bazează pe joncțiunile pn ci pe fenomene mult mai complexe ce apar în anumite condiții în structura atomică a materialului semiconductor. În particular se poate folosi doparea variabilă de-a lungul căii de conducție.

Poate realiza operații electronice complexe cum ar fi formarea semnalelor și conversia analog-digitală.

Ce dispozitive semiconductoare de microunde se folosesc în prezent?

Deși tuburile electronice pentru microunde se folosesc pe scară largă recent au început să apară un număr de dispozitive semiconductoare destinate funcționării în microunde. Un exemplu îl constituie dioda Gunn care folosește arseniura de galiu de tip n . Cînd se aplică o tensiune de polarizare suficient de mare dispozitivul lucrează ca oscilator de microunde.

Care sînt cele mai importante utilizări ale dispozitivelor semiconductoare în industrie?

Aceste dispozitive se folosesc cu miile în calculatoarele angrenate într-o varietate de sarcini industriale, comerț și cercetare. De asemenea, tranzistoarele oferă avantaje în instrumentele de măsură și sistemele de control ale motoarelor electrice, generatoare și procese de fabricație. Acolo unde sînt necesare un număr mare de circuite, cele mai căutate atribute sînt dimensiunile și tensiunile de alimentare mici. În această privință tranzistoarele sînt superioare tuburilor. Printre multe tipuri de dispozitive folosite, de o importanță deosebită sînt tiristoarele, tranzistoarele sensibile la lumină, redresoarele cu siliciu și tranzistoarele.

Exemple de circuite fundamentale

În afara amplificatoarelor și oscilatoarelor, menționate anterior, circuitele cu tranzistoare pentru comutație și numărare sînt printre cele mai importante în echipamentele industriale și calculatoare. Un comutator electronic poate lucra foarte repede și nu are părți mobile. Un tranzistor care este în stare ON, adică conduce, este echivalent cu un comutator închis, în timp ce unul care este în stare OFF, adică nu conduce, este echivalent cu un comutator

deschis. Exemplele ce urmează vor servi drept introduce în acest subiect.

Deși inițial s-au folosit tuburi electronice pentru comutatoare electronice, sau porți cum se mai numesc adesea, tranzistorul datorită vitezei sale de lucru mai mare este mult mai adecvat unor astfel de sarcini și a făcut de fapt posibilă dezvoltarea unor tipuri de echipamente avansate (cum ar fi calculatoarele) care au devenit atît de familiare astăzi.

Tranzistorul se folosește în circuitele de impulsuri cu rol de comutator de tensiune sau curent. Funcționarea sa depinde de valoarea altor componente (rezistoare și capacitatoare spre exemplu) iar frecvența de repetiție a impulsurilor este determinată de viteza cu care tranzistorul va comuta dintr-o stare în alta.

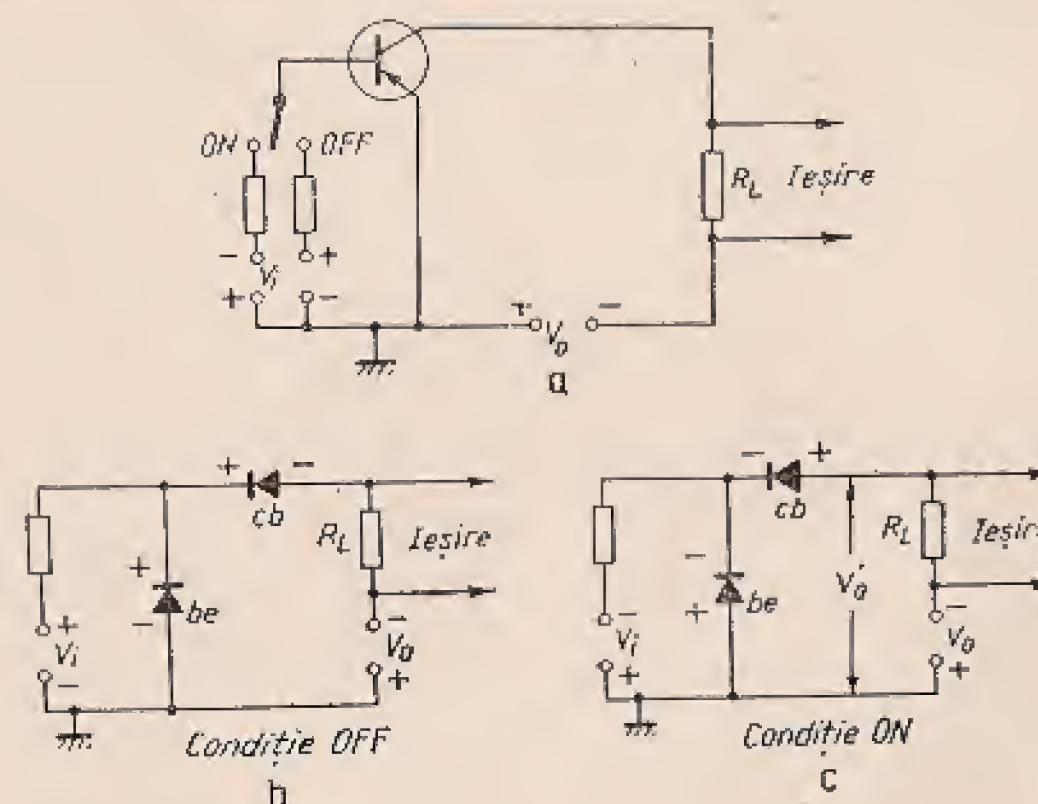


Fig. 44. Comutator în conexiunea cu emitorul comun a. Circuite echivalente cu diode pentru stările ON și OFF, b și c.

Pentru simplitate cele două joncțiuni ale tranzistorului pot fi socotite ca fiind două redresoare cu diodă separate. În fig. 44, a se reprezintă un circuit de comutație cu emi-

torul comun iar în fig. 44, b și c circuitele cu diode echivalente pentru stările OFF și ON ale tranzistorului. În starea OFF ambele diode sînt invers polarizate și nu vor conduce. Prin sarcina R_L nu va trece curent. Cînd tensiunea dintre bază și emitor se inversează, ambele diode sînt polarizate direct și conduc. Astfel circuitul comută în starea ON iar prin sarcina R_L trece curent. În acest exemplu simplu inversarea polarității este făcută mecanic, dar în practică se folosește un impuls de tensiune.

De asemenea folosind dioda într-un exemplu simplu este posibilă analizarea funcționării porților AND* și OR*, care se numără printre elementele esențiale ale circuitelor logice din calculatoare. Referindu-ne la figura 45, poarta AND produce un semnal la ieșire numai dacă se aplică simultan semnale la fiecare intrare. Poarta OR produce un semnal la ieșire dacă se aplică un semnal la ambele sau una din intrările porții. Cînd semnalele sînt pozitive, circuitul din a acționează ca o poartă AND iar cel din b ca o poartă OR; cînd semnalele sînt negative totul se inversează. În cazurile practice există mai multe intrări, nu numai două cum s-a arătat mai sus. Un alt circuit îl reprezintă poarta NOT**, care produce semnal la ieșire cînd nu se aplică semnal pe niciuna din intrări.

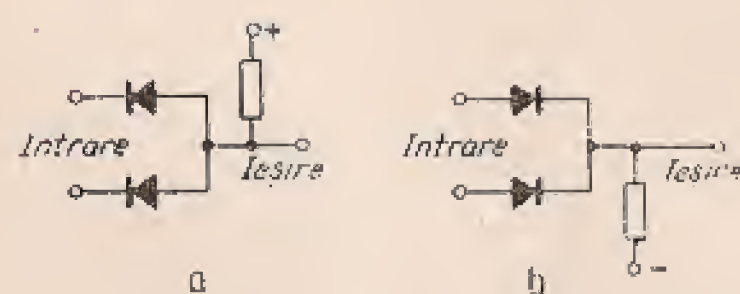


Fig. 45. Circuite OR și AND cu două diode de intrare.

Circuitele logice din cele mai recente calculatoare pot fi relativ complicate — deși de dimensiuni mici — și folosesc diferite tipuri de componente și lucrează la viteze de ordinul nanosecundelor.

* porți ȘI, SAU.

** poartă NU.

Alte circuite de impulsuri

Un circuit foarte răspîdit este cel care comută între două stări de funcționare, ON și OFF. Oricare sau ambele stări pot fi instabile, adică circuitul nu va rămîne în starea numită „instabilă” și se reîntoarce automat la cealaltă stare. Dacă nici una din stări nu este stabilă circuitul se află într-o stare de funcționare continuă; adică trece dintr-o stare în cealaltă în mod continuu.

Multivibratorul a fost inițial inventat pentru a satisface necesitatea unui generator de unde patrurate care sînt bogate în armonici. Montajul de bază din figura 24 are două stări instabile. Cînd circuitul este adus în stare de funcționare, ușorul dezechilibru ce există între componente determină trecerea tranzistorului în una din stările instabile: în consecință apare o basculare între cele două stări instabile.

Circuitul bistabil (fig. 46), are o stare stabilă și una instabilă.

Montajul bistabil Eccles-Jordan din fig. 47 are o importanță deosebită datorită largii folosiri în numărătoare.

Un impuls aplicat la intrare împinge circuitul într-o stare stabilă, unde rămîne pînă cînd un al doilea impuls îl aduce în starea inițială. Pentru fiecare două impulsuri aplicate la intrare apare la ieșire un impuls: astfel că acest circuit realizează diviziunea prin doi.

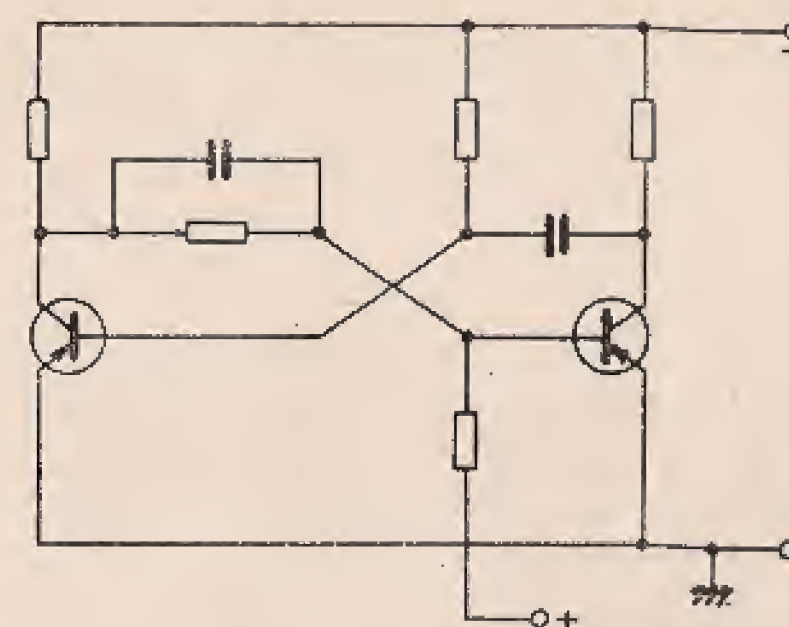


Fig. 46. Circuit bistabil. În comparație cu multivibratorul astabil din fig. 24, acest circuit are o stare stabilă și una astabilă, și se numește multivibrator monostabil.

În exemplul precedent circuitul bistabil este comandat în stările ON sau OFF prin impulsuri de aceeași polaritate. Dacă impulsurile s-ar aplica în același moment ambelor tranzistoare ar apărea o întârziere în comutare și

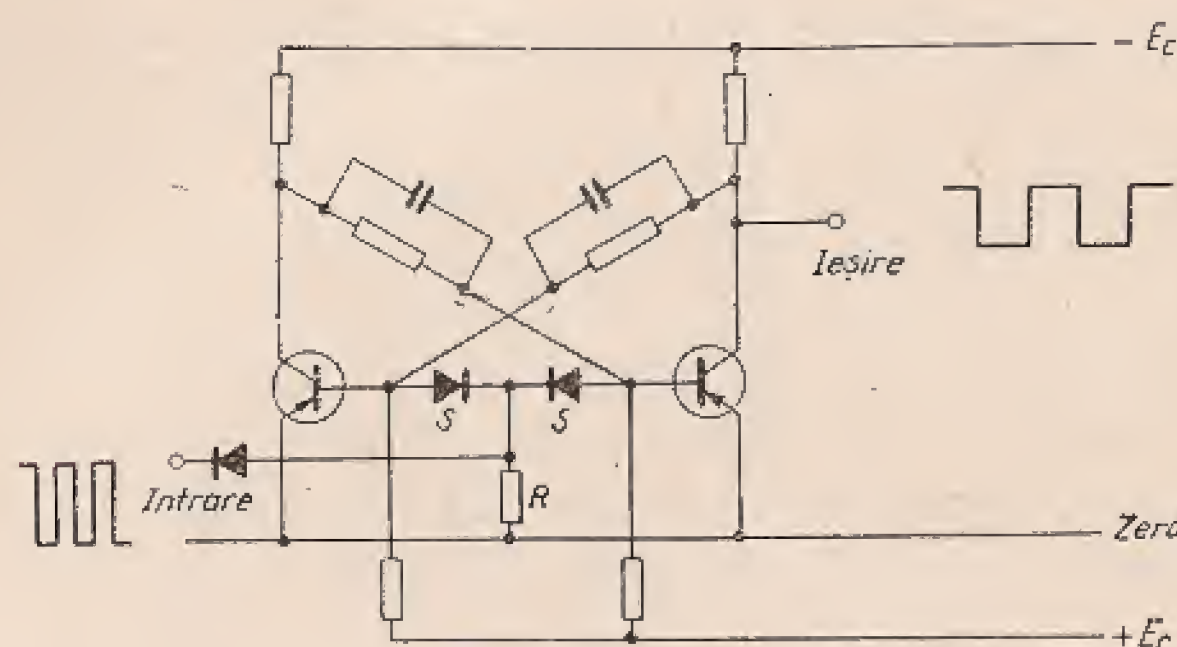


Fig. 47. Circuit bistabil Eccles-Jordan. Acest circuit are două stări stabile și este folosit în numărătoare rezultând la ieșire un impuls pentru două impulsuri de intrare.

prin urmare se introduc diodele de „direcționare” care vor evita această întârziere. Montajul se face astfel încât dacă vine un impuls de intrare negativ el este totdeauna condus spre tranzistorul în stare OFF (deși inversarea conexiunilor diodelor face ca circuitul să fie sensibil la impulsul pozitiv).

În practică o serie de astfel de circuite se vor asambla astfel încât ieșirea unuia acționează intrarea următorului. În acest mod se poate realiza un numărător binar (sau, cu unele modificări un numărător decadic). Informațiile sînt extrase din bistabil printr-un circuit poartă spre exemplu poarta AND menționată deja. În general se folosesc tranzistoarele cu siliciu în scopul minimizării efectelor temperaturii.

Ce este un amplificator de curent continuu?

În instrumentele de măsură, calculatoare și sistemele de control automate se cere adesea amplificarea unor semnale continui aplicate la intrare. Amplificatoarele de curent alternativ normale, ce cuprind capacitoare sau transformatoare de cuplaj între etaje, nu sînt adecvate pentru amplificarea semnalelor continui: capacitorul, avînd o constantă de timp specifică va bloca semnalul continuu. Prin urmare etajele trebuie să fie cuplate direct.

În amplificatoarele de curent continuu folosite pentru măsurări apar probleme legate de variațiile cîștigului și a alinierilor punctului de zero. Prima poate fi depășită prin aplicarea unei reacții negative. Devierea poate fi minimizată prin folosirea tranzistoarelor cu siliciu. În exemplul din fig. 48 tranzistoarele complementare (pnp și npn) sînt cuplate direct.

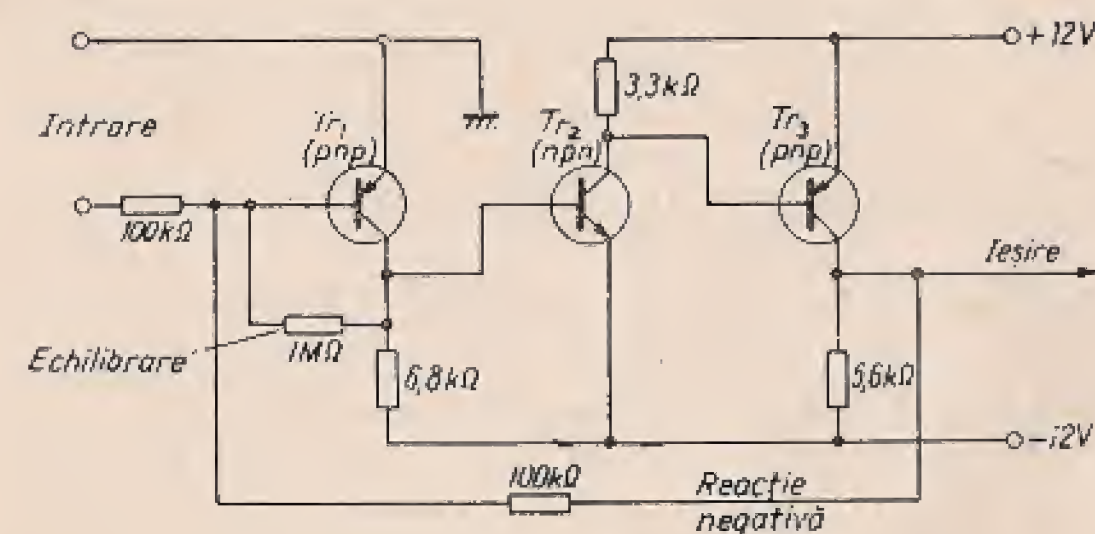


Fig. 48. Amplificator de curent continuu cu reacție, folosind două tranzistoare pnp și un tranzistor npn.

Proiectanții de circuit sînt ajutați în prezent de existența tranzistoarelor duble — adică, o pereche de tranzistoare aflate în aceeași capsulă. Aceasta asigură avantajul

important al unei diferențe de temperatură minimă între tranzistoarele ce formează perechea și în general suportă dezvoltările circuitelor cu devieri reduse.

O utilizare importantă a amplificatoarelor de curent continuu se află în „amplificatoarele operaționale” din calculatoarele analogice. Așa cum sugerează și numele, amplificatorul operațional este folosit pentru efectuarea operațiilor matematice cum sînt adunarea, integrarea și diferențierea. Aceasta se realizează cu ajutorul reacției. Montajul fundamental este format dintr-un amplificator ce are o impedanță de intrare Z_1 și o impedanță de reacție în paralel Z_2 . Considerînd că amplificarea este suficient de mare, tensiunile de intrare e_1 și ieșire e_0 sînt legate prin relația: $e_0/e_1 = -Z_2/Z_1$. Prin schimbarea impedanțelor serie și de reacție, care pot fi rezistive, reactive sau neliniare, se pot realiza diferite funcții operaționale. Faptul că un astfel de amplificator necesită amplificare mare, stabilitate în diferite condiții de reacție, impedanță de intrare mare și deviere mică înseamnă că aceasta este potrivit și pentru instrumente sau alte aplicații.

Ce este „stabilizarea față de ambianță”?

În scopul realizării unei fiabilități complete (sau cît mai perfectă posibil) echipamentele realizate cu tranzistoare și alte dispozitive sensibile cu temperatura pot fi închise într-o incintă în care condițiile de lucru sînt strict controlate. Spre exemplu, echipamentele tranzistorizate din aviație pot fi protejate în acest mod. Toate componentele închise sînt menținute la o temperatură ce poate fi controlată pînă la o fracțiune de grad, umiditatea este controlată și există o izolație termică de un înalt grad. Se poate introduce și o instalație de răcire.

În acest mod se realizează stabilizarea echipamentelor față de mediul în care lucrează. Introducerea materialelor suplimentare se adaugă prețului inițial, și s-ar crede că mărirea volumului ar fi un dezavantaj. Dar de fapt acest control strict al funcționării conduce la reducerea consumului de putere, unele simplificări de circuit și alte posibilități de reducere a dimensiunilor fizice. Ba mai mult, o fiabilitate foarte bună conduce la o economie de activități, cum ar fi lucrul în aviație care este deja costisitor. Prin urmare este de așteptat că astfel de metode vor fi folosite tot mai mult în viitor.

O metodă de protecție a echipamentelor tranzistorizate mai puțin avansată este simpla aero-condiționare. Spre exemplu, mijloacele de navigație aeriană au fost construite sub formă de module etanșe umplute cu gaz inert la o presiune puțin mai mare decît presiunea atmosferică pentru a le proteja împotriva prafului și altor impurități din aer. Metodele descrise aici pot fi aplicate la calculatoare.

Ce fel de redresoare se folosesc în electrotehnică?

Dispozitivele semiconductoare cu germaniu și siliciu sînt larg folosite. În unele domenii, datorită avantajelor specifice cum ar fi eficiența ridicată, ele înlocuiesc redresoarele metalice familiare, care în mod obișnuit folosesc bariera construcției în straturi ale seleniului sau oxidului de cupru. Redresoarele cu joncțiune cu siliciu au caracteristicile dorite de rezistență directă mică și rezistență inversă foarte mare, iar exemplele recente de redresoare industriale sînt calculate pînă la 0,25 MW. Ele sînt mai robuste și mai mici decît vechile tipuri de redresoare pe care le înlocuiesc.

Pentru comanda în tensiune, cum ar fi comanda vitezei unui motor de curent continuu, redresoarele cu siliciu comandate sînt folosite în mod curent. Alte aplicații ale dispozitivelor semiconductoare, în particular cele cu siliciu, sînt sistemele de comandă asociate mașinilor unelte și alternatoarelor.

Redresorul cu siliciu comandat (tiristor) a fost descris în capitolul 5. Comparat cu tiratronul, pe care tinde să-l înlocuiască în echipamentele industriale, redresorul cu siliciu comandat (RSC) are o cădere de tensiune directă foarte mică în starea de conducție și prin urmare este foarte eficient. El are timp de comandă și revenire de ordinul microsecundelor și poate lucra la o temperatură ridicată. De asemenea, în comparație cu tubul electronic, el nu are filament — deci nu este necesară o perioadă de încălzire — și este mult mai robust și mai compact.

Un impuls de poartă comandă dispozitivul să conducă în sens direct, altfel fiind blocat pînă la sosirea impulsului. Dispozitivul rămîne în starea de conducție pînă cînd se întrerupe curentul prin el. El poate fi amorsat în orice punct al semisinusoidei, permițînd astfel obținerea unui semnal de ieșire variabil continuu dintr-un semnal de intrare alternativ constant.

O aplicație tipică a tiristorului

În multe tipuri de echipamente, cum ar fi mașinile textile și de imprimat, pompele, ventilatoarele mari sau mașinile unelte, sînt necesare comenzi cu viteze variabile. Cu ajutorul tiristoarelor se poate proiecta un sistem de comandă suficient de simplu.

În fig. 49, se reprezintă schema generală a unui sistem de comandă pentru un motor de curent continuu mic. Excitația motorului este alimentată cu o tensiune constantă

obținută de la un redresor. Viteza motorului se modifică variînd tensiunea indusului folosind o punte cu tiristoare, care este comutată din starea de blocare în cea de con-

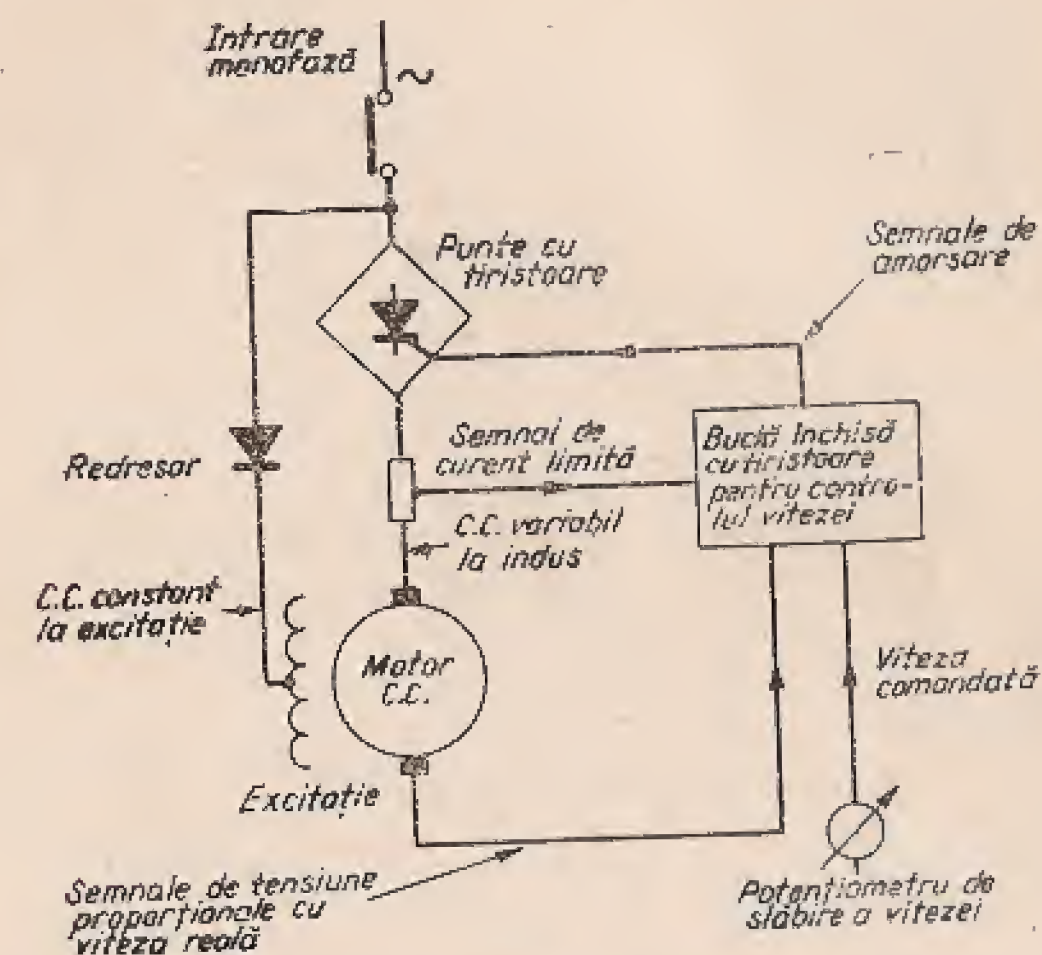


Fig. 49. Comanda vitezei unui motor de curent continuu.

ducție cu ajutorul impulsurilor de amorsare de putere mică. Prin reglarea impulsurilor se comandă momentul în care tiristorul începe să conducă și se comandă astfel nivelul mediu al tensiunii de ieșire.

Reglarea impulsurilor de amorsare cu potențiometrul de stabilire a vitezei se realizează cu un circuit simplu de comandă. De asemenea el previne supraîncărcările și compensează creșterile de sarcină.

În fig. 50 se reprezintă o aplicație tipică a RSC pentru puteri mari. Acesta este un motor-generator Ward-Leonard, în care excitația generatorului este alimentată de la un RSC. Montajul permite o frînare regenerativă cînd echipamentul funcționează la o viteză mai mică. Circuitul

de aprindere al RSC cuprinde un reactor saturabil care solicită curentul de ieșire al unui amplificator de comandă tranzistorizat (T_1 — T_4 în acest circuit).

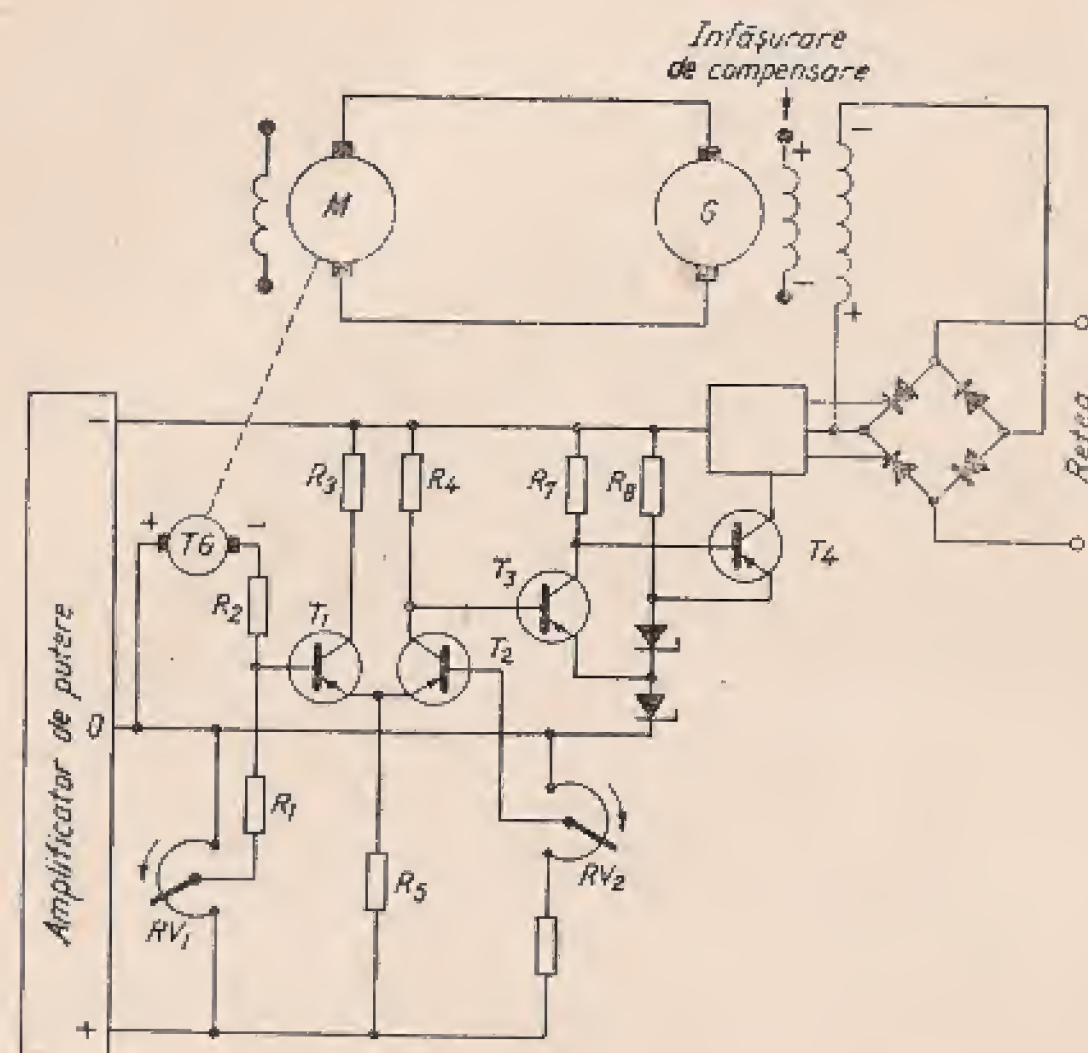


Fig. 50. Sistem de control Leonard-Ward tranzistorizat.

Utilizarea radiatoarelor în echipamentul industrial

S-a prezentat deja (pag. 62) importanța eliminării căldurii din tranzistoarele folosite chiar în instalații mici (cum ar fi amplificatoarele audio). În echipamentele industriale unde se folosesc redresoare cu siliciu mari și tiristoare sînt foarte necesare radiatoare cu o suprafață de răcire mare.

La folosirea radiatoarelor proiectanții de echipamente trebuie să țină seama de mulți factor cum ar fi toleran-

țele componentelor, posibilitatea acumulării de praf pe radiator în timpul folosirii, temperatura ambiantă și ventilația. În multe cazuri se folosește răcirea prin aer condi-

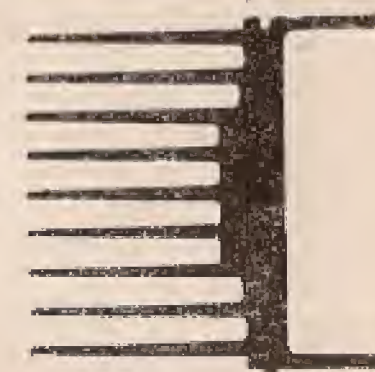


Fig. 51. Secțiune într-un radiator folosit pentru un redresor cu siliciu.

ționat. În fig. 51 se prezintă o secțiune transversală într-un radiator fabricat prin extrudare. În acest exemplu se evidențiază suprafața de radiație mare asigurată de aripioare.

Utilizări industriale ale dispozitivelor sensibile la lumină

O fotocelulă și un proiector — o lampă ce poate direcționa raza de lumină — sînt astfel aranjate încît obiectul ce urmează a fi detectat să treacă printre ele. Celula poate fi un fototranzistor sau alt dispozitiv fotoconductiv (spre exemplu celula cu sulfură de cadmiu) conectat la un amplificator cu tranzistoare separat. Indiferent de montaj, circuitul în mod obișnuit cuprinde un releu ce acționează echipamentul (vezi fig. 54). Montajul poate funcționa fie prin întreruperea razei de lumină fie prin aplicarea ei.

Acest dispozitiv simplu are o varietate foarte largă de utilizări în industrie. Aceasta include detecția, numărarea și observarea (monitorizarea) articolelor ce trec pe o linie de producție; numărarea vehiculelor sau oamenilor; deschiderea ușilor; acționarea sistemelor de alarmă și comandă a mașinilor. Fotocelulele pot fi folosite în scopuri de reglare; de exemplu la încercarea automobilelor.

Funcționarea celulei poate fi dependentă de schimbări gradate a intensității luminii astfel că este posibilă detecția fumului sau substanțelor vaporizate. O aplicație interesantă este monitorizarea turburelii și consistenței fluidelor. De asemenea, dispozitivul poate lua forma unui controlor automat al sistemelor de iluminat, care funcționează când lumina naturală scade la o anumită valoare.

Trebuie menționat că dispozitive specializate ocupă un important loc în industria oțelului. Oțelul fierbinte reprezintă o sursă de raze infraroșii și prin urmare aceste dispozitive pot fi incorporate în sistemele de comandă și securitate.

Există un interes crescând față de dispozitivele fotodectoare pentru detecția radiației în regiunea dintre infraroșu și microunde (lungimi de undă de aproximativ 100 μm și mai mari). Acest tip de dispozitiv este necesar în cercetări și radiocomunicații. Unele detectoare pentru infraroșul apropiat folosesc materiale nedopate cu impurități cum ar fi antimoniura de indiu, sulfura de plumb și telluriul. Un detector practic pentru cercetare folosește antimoniura de indiu de tip *n*.

Cît de mult se folosesc semiconductoarele în instrumente?

Tranzistoarele sînt larg folosite în oscilatoare, amplificatoare, circuite de comandă (în scheme de automatizare spre exemplu) în generatoare de semnal și au înlocuit în mare parte tuburile electronice într-o varietate de voltmetre, frecvențmetre și alte instrumente de măsură. Avantajele practice cuprind reducerea dimensiunilor instrumentelor, eliminarea virtuală a problemelor de ventilație și micșorarea surselor de alimentare. Mai trebuie

menționată folosirea cablajelor imprimate și în unele cazuri a microcircuitelor.

Pentru măsurări la frecvențe înalte tipurile speciale de tranzistoare folosite oferă avantaje față de tuburi: conductanța mutuală de valoare mai mare permite folosirea unor rezistențe de sarcină de valoare mai mică și de asemenea este posibilă o lărgime de bandă de funcționare mai mare. Pe de altă parte, amplificatoarele de c.a. tranzistorizate cu impedanțe de intrare mari sînt mai greu de conceput dar tipurile recente de tranzistoare au îmbunătățit această situație.

În circuitul voltmetrului tranzistorizat din fig. 52, primele două tranzistoare formează un amplificator de tensiune compensat. Acesta alimentează o pereche de tranzistoare care, în montaj repetor pe emitor, asigură o amplificare de curent suplimentară. În circuit se pot introduce rezistoare de valori ridicate pentru a asigura game mari

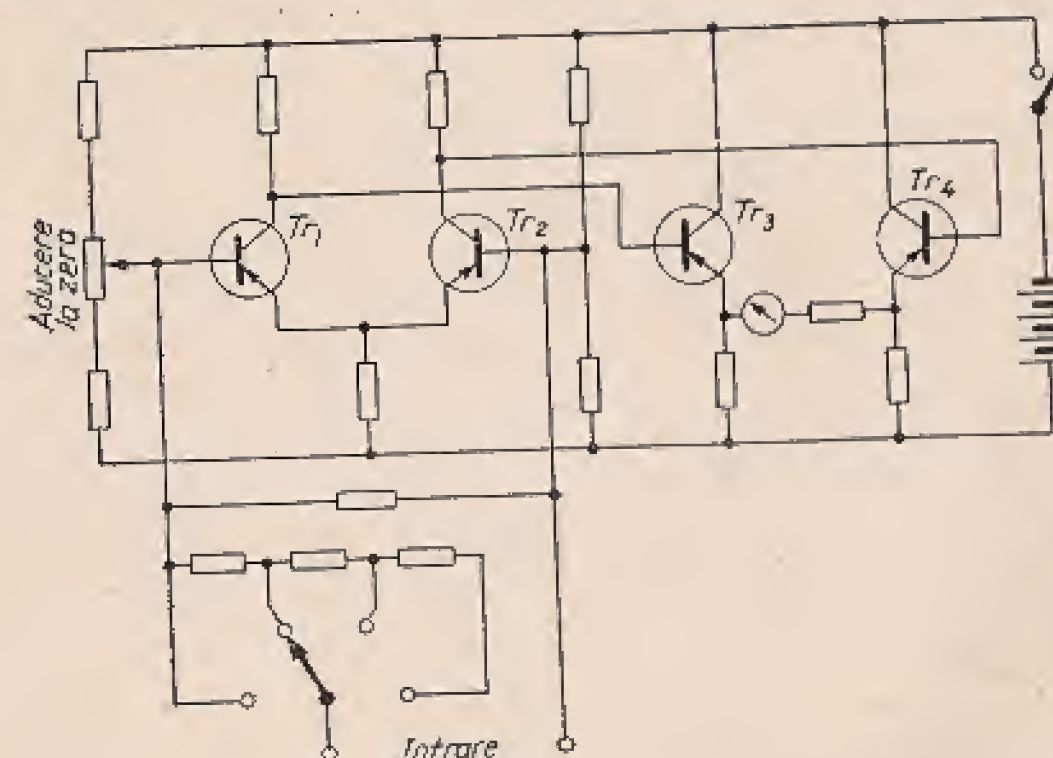


Fig. 52. Voltmetru cu tranzistoare.

de tensiune în cazul instrumentelor foarte sensibile. Pentru minimizarea efectelor temperaturii într-un astfel de instrument se folosesc perechi echilibrate de tranzistoare cu siliciu.

De asemenea în instrumente sînt importante genera-
toarele de impulsuri, numărătoare de impulsuri și am-
plificatoarele de curent continuu despre care s-a vorbit
deja. În general tranzistoarele înlocuiesc tuburile în in-
strumentele de măsură.

Poate cel mai neobișnuit și mai interesant fenomen ce
poate fi utilizat în instrumentele de măsură este efectul
Hall, care apare cînd o bucată de material semiconductor
este ținută într-un cîmp magnetic. Pe scurt, dacă printr-o
plachetă de material semiconductor trece un curent iar
cîmpul magnetic este perpendicular pe plachetă (trecînd
prin fețele sale) între capetele opuse ale plachetei apare
o tensiune electrică. Tensiunea este proporțională cu pro-
dusul dintre cîmpul magnetic și curentul ce trece prin
plachetă.

În practică un dispozitiv Hall este format dintr-o pla-
chetă montată într-o fereastră a unui miez de ferită peste
care este înfășurată o bobină. Aceste două elemente pot fi
reprezentate ca în fig. 53. Semnalul de intrare A ce trece
prin semiconductor interacționează cu cîmpul magnetic
produs de intrarea B . Ten-
siunea de ieșire de la cape-
tele plachetei este proporțio-
nală cu produsul celor două
semnale de intrare.

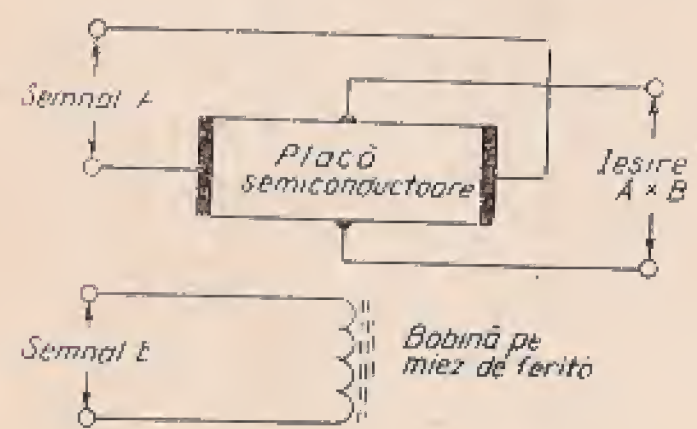


Fig. 53. Dispozitiv Hall.

Dispozitivul Hall poate fi
folosit pentru convertirea
măsurării unui flux magne-
tic în măsurarea unei ten-
siuni continue sau alternative. Deci el poate fi socotit ca
un transductor. În alte aplicații, dacă una din intrări este
alternativă iar cealaltă continuă, ieșirea este o tensiunea
alternativă cu amplitudinea proporțională cu intrarea con-

tinuă. Cu alte cuvinte apare o conversie continuă în al-
ternativ. Dispozitivele Hall pot fi folosite în calculatoare
și echipamente radio precum și în instrumente de măsură.

Cum crește un tranzistor sensibilitatea unui releu?

Releul însuși poate cu ajutorul unui curent mic să co-
mute circuite ce suportă curenți mult mai mari. Un releu
acționat de un curent, să zicem, 10 mA poate comanda
circuite ce suportă curenți de 10 A. Totuși, se poate ob-
ține o creștere considerabilă a sensibilității prin folosirea
unui tranzistor pentru amplificarea curentului, astfel în-
cît curentul de intrare în releu poate
fi de numai cîțiva microamperi.

Așa cum se arată în fig. 54 baza
tranzistorului este conectată la emitor
printr-un rezistor iar curentul de co-
lector este insuficient pentru a acționa
releul, R . Cu ajutorul unui curent de
intrare de valoare mică tranzistorul va
conduce și va acționa releul. Ar fi de
notat că tranzistorul folosește sursa de
alimentare folosită deja pentru releu.
Acest releu este larg folosit în echipa-
mentele industriale.

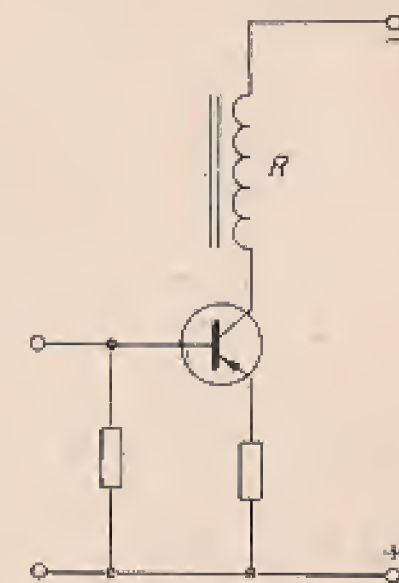
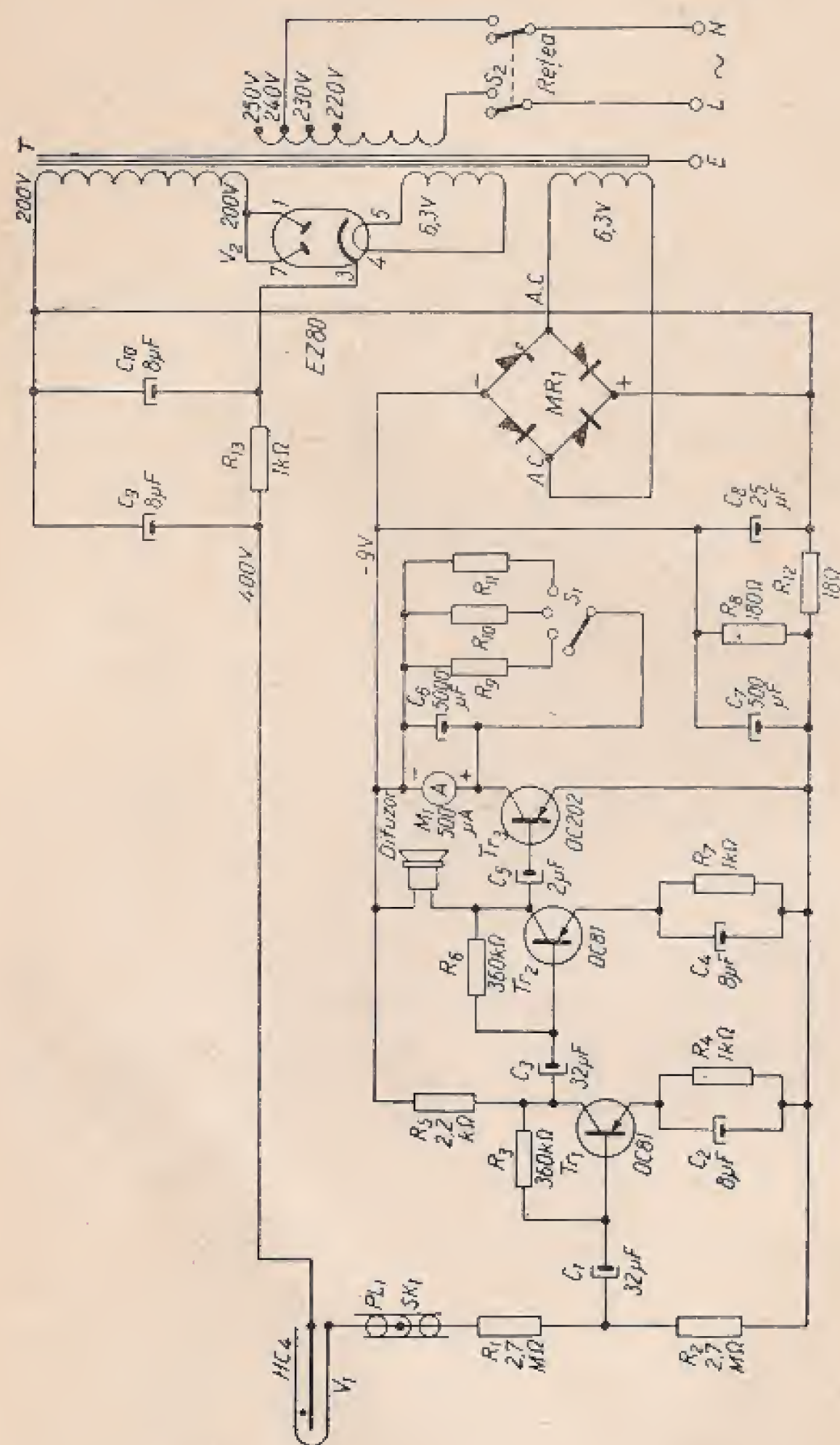


Fig. 54. Utilizarea
tranzistorului pen-
tru creșterea sen-
sibilității unui re-
leu.

Instrument pentru măsurarea radioactivității

Un contor cu tub Geiger-Müller pentru citirea inten-
sității radiației se pot realiza foarte simplu utilizînd tran-
zistoare. Pentru aceasta este necesar să se medieze nu-
mărările de impulsuri obținute de la un tub Geiger-Mül-
ler și a amplifica și converti acest semnal în unul ce se



poate citi pe un instrument. În fig. 55 se arată un astfel de circuit.

Circuitul cuprinde tubul HC4, un amplificator cu două etaje cu o ieșire adecvată, pentru un difuzor sau cască precum și pentru un instrument, un microampermetru obișnuit prevăzut cu mai multe scări, un integrator pentru a media viteza de numărare și un redresor metalic pentru alimentarea tranzistoarelor. Așa cum se observă din figură tubul HC4 este alimentat de la un redresor cu tub electronic dar se poate folosi și un redresor metalic.

Se poate produce electricitate pe scară largă cu ajutorul semiconductoarelor?

Perspectiva generării electricității fără intervenția mașinilor cum ar fi turbinele sau alternatoarele reprezintă o problemă atractivă iar diferitele metode încercate la scară experimentală a inclus folosirea semiconductoarelor. Anumite dispozitive, cum ar fi celulele solare, se află în stadiul experimental, iar cantitatea de electricitate obținută de la o baterie este mică.

O încercare care promite mai mult este conversia în electricitate a căldurii obținută dintr-un reactor nuclear. Oamenii de știință sovietici au obținut succese cu un reactor experimental, în care căldura generată este transportată către un convertor termic — electric semiconductor. Convertorul, conținând elemente din aliaj de germaniu-siliciu, este localizat la suprafața reactorului. Pe o parte a elementelor se primește căldura iar pe cealaltă sint răcite și astfel se generează un curent electric. Rămîne de văzut dacă generarea pe scară largă prin această metodă va fi economică și posibilă din punct de vedere tehnic.

Ce alte utilizări ale tranzistoarelor mai există?

Tranzistoarele au importante aplicații în motoarele autovehiculelor, în cercetări spațiale și medicină. Tendința de automatizare a proiecției cinematografice implică folosirea dispozitivelor semiconductoare. Transformările din telefonie electronică vor depinde tot mai mult de folosirea dispozitivelor semiconductoare de diferite feluri: cablurilor telefonice, cum sînt cele submarine și care trebuie să aibă o viață cît mai lung li se asociază amplificatoare repetoare.

**Cît de mult se pot folosi dispozitivele
semiconductoare în autovehicule?**

În afara aplicațiilor familiare și evidente din radiourile din automobil, dispozitivele semiconductoare au multe și posibile utilizări în automobilele însăși. Pînă acum, cel mai mult au beneficiat autovehiculele mai grele, dar este foarte probabil ca tranzistoarele și alte dispozitive vor avea o utilizare considerabilă și în automobile. Astfel de dezvoltări, în transportul rutier în întregime, sînt de o importanță tehnică și economică evidentă, ținînd seama de numărul extraordinar de mare al vehiculelor electrice ce se cer. Prin urmare este de o mare importanță să le revedem ceva mai detaliat.

Dispozitivele semiconductoare se folosesc în autovehicule în scopul îmbunătățirii performanțelor pentru soliditatea și siguranța sistemelor electrice ale acestora. În cele mai multe dintre vehiculele electrice, temperaturile întîlnite continuu sau ocazional sînt suficient de mari pentru a împiedica folosirea dispozitivelor cu germaniu. Prin urmare tranzistoarele cu siliciu, redresoarele cu siliciu precum și alte dispozitive ce pot lucra pînă la temperaturi de 200°C au o largă utilizare.

S-au obținut succese importante în ceea ce privește generatoarele electrice, sistemele de aprindere și control și există și diferite alte echipamente în care folosirea dispozitivelor semiconductoare va fi tot mai frecventă.

Generatoarele vehiculelor

Cu toate că generatoarele de curent alternativ sînt un articol important al autovehiculelor, generatoarele de curent continuu (dinamurile) sînt folosite de mult timp în automobile și multe vehicule grele. Ele folosesc perii care au nevoie de întrețineri și eventual înlocuire, și există un domeniu limitat al vitezelor motoarelor în care bateriile se pot încărca. Un dezavantaj cunoscut de proprietarii de automobile este faptul că bateria nu se reîncarcă cînd mașina nu merge — o problemă care devine tot mai obișnuită pe măsura creșterii densității traficului. În condițiile moderne evident că sistemele electrice mai vechi nu mai pot fi folosite în întregime.

O îmbunătățire importantă poate fi realizată prin utilizarea unui generator de curent alternativ (alternor) cu un redresor. Un alternor nu necesită întreținere în afara unui control cu totul ocazional; el poate fi mai mic, dispozitivele semiconductoare pot fi folosite în acest caz în

circuitele de ieșire (în locul redresoarelor metalice foarte grele care se foloseau înainte).

Cea mai recentă realizare o constituie alternorul trifazic la care se folosesc pentru redresare diode cu siliciu: de fapt diodele redresoare pot fi incorporate în însăși alternor. Un astfel de echipament a început să apară la automobile, aducând deci beneficiile unei greutate mici și a încărcării în timpul repausului motorului.

În dispozitivele de comandă asociate, părțile mobile pot fi eliminate, astfel încât siguranța în funcționare crește. În fig. 56 se arată un astfel de circuit. Acest circuit cuprinde două tranzistoare și o diodă zenner. Funcționarea sa este similară celui al regulatorului electromagnetic mult mai familiar la care curentul din bobina de excitație a alternatorului este variat pentru a menține curentul generat între anumite valori bine precizate, dar aici

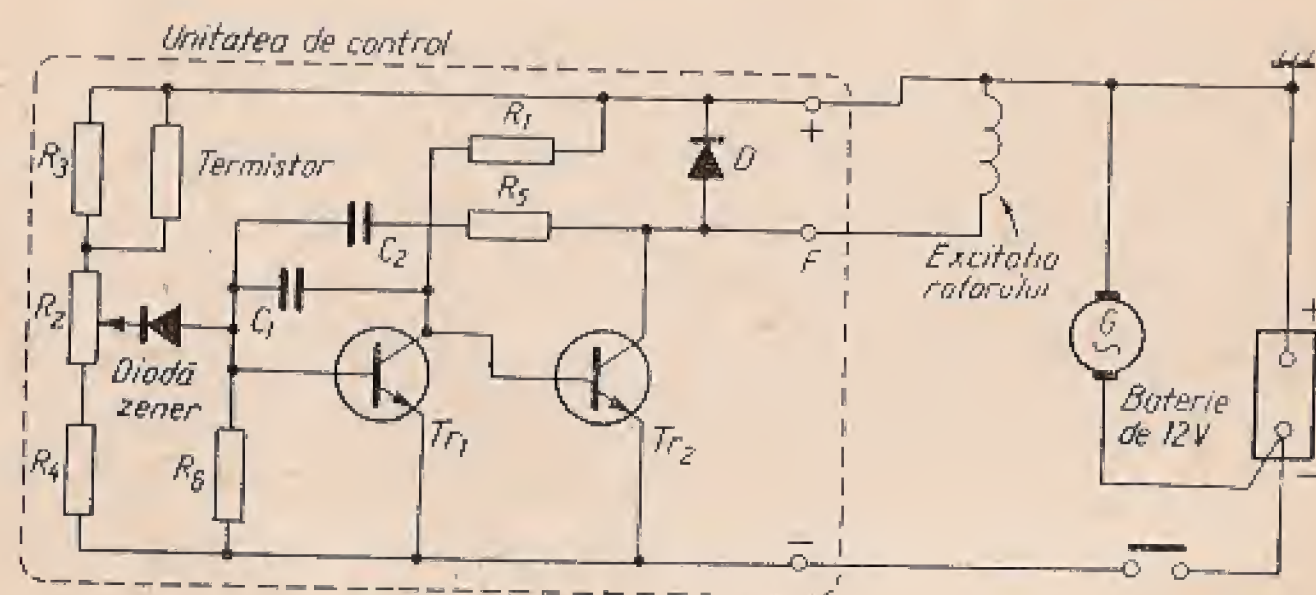


Fig. 56. Circuit de comandă folosind dispozitive semiconductoare.

comutația este asigurată de tranzistoare în locul contactelor vibratorii. O diodă zenner și un potențiomtru asigură tensiunea de referință, înlocuind astfel bobina și sistemul cu arc de tensionare.

Altă utilizare a diodei zenner

Dioda zenner poate fi utilizată într-un dispozitiv regulator simplu din sistemul electric alternativ de 12 V al unei motociclete. Dioda se conectează în paralel pe baterie și acționează ca o supapă de șuntare, permițând trecerea curentului redresat de la alternor conform stării de încărcare a bateriei. Pe măsură ce bateria se reîncarcă tensiunea sa crește, când ea atinge aproximativ 14 V, dioda, pînă acum în stare blocată (rezistență mare), devine parțial conductoare și reprezintă o cale de închidere pentru o parte din semnalul de ieșire al alternatorului.

Creșterile ulterioare ale tensiunii bateriei conduc la o creștere mai mare a conductivității diodei pînă cînd, la aproximativ 15 V (tensiunea de încărcare completă a bateriei), cea mai mare parte a ieșirii alternatorului este scurtată și tensiunea pentru sarcină deschisă se stabilizează.

Dacă se aprinde o lampă, tensiunea sistemului scade sub 15 V; prin diodă circulă mai puțin curent iar echilibrul se modifică pentru a alimenta sarcina.

Dacă o sarcină mai mare aduce tensiunea sub 14 V dioda zener revine la starea sa de blocare și întreg curentul de la ieșirea alternatorului se folosește pentru satisfacerea cerințelor bateriei și echipamentului.

Cum se folosește tranzistorul în sistemul de aprindere al automobilului?

Natura sistemului de aprindere convențional este binecunoscută: componentele importante sînt bobina de inducție și întreruptorul din distribuitor. Întreruptorul trebuie să întrerupă un curent destul de mare cu o viteză de pînă la cîteva sute de ori pe secundă. Părțile mecanice presu-

pun o reglare periodică — parte din verificarea generală a mașinii — dacă se urmărește menținerea performanțelor mașinii.

Într-un sistem de aprindere electronic, întreruptorul este încă folosit dar are o sarcină mai ușoară. Așa cum se

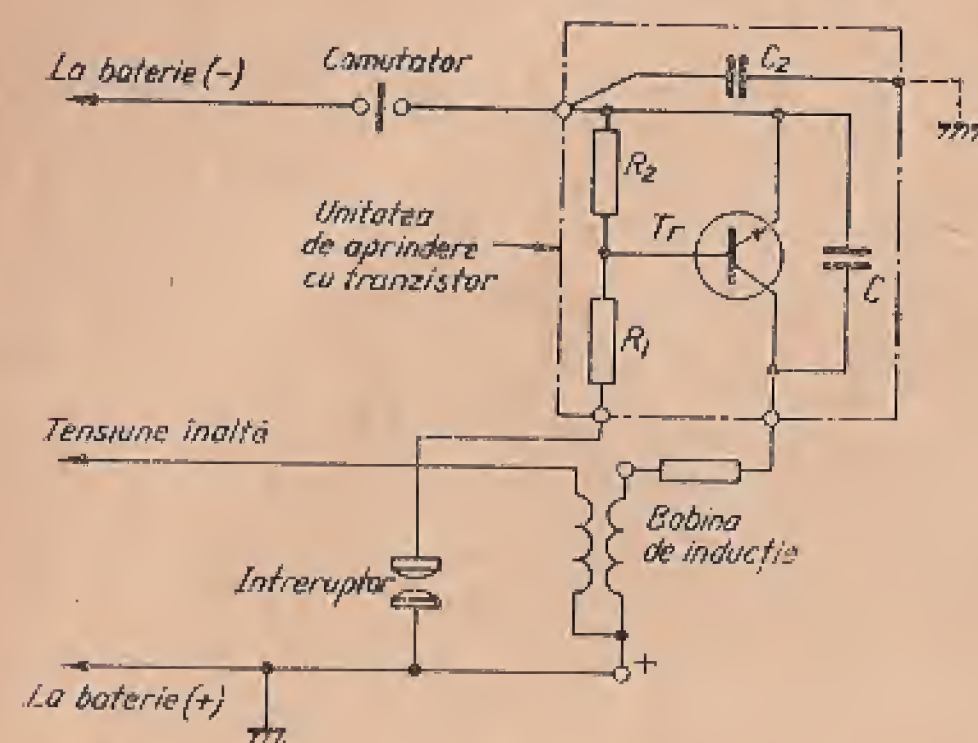


Fig. 57. Tranzistor cu baza la masă folosit pentru comutarea curentului din primarul bobinei de aprindere.

arată în fig. 57, întreruptorul este conectat în circuitul din baza tranzistorului iar circuitul primarului bobinei de inducție este completat cu circuitul emitor-colector. Cu contactele închise, în circuitul bazei circulă un curent neinductiv, care comută tranzistorul în starea de conducție și permite astfel curentului din primar să circule prin bobină. Când contactele sînt deschise curentul din bază se întrerupe iar tranzistorul se blochează. O tensiune de valoare ridicată va apare la bornele secundarului bobinei.

Se consideră că întreținerea și reglarea contactelor sînt mai reduse datorită curentului neinductiv, relativ mic. Întrucît se elimină arc electric, turația la mașinile mici este îmbunătățită. Și viteza se mărește.

Totuși, pentru automobile de performanțe ridicate s-a conceput un sistem de aprindere mult mai rafinat. Acesta este un montaj complet electronic din care au fost elimi-

nate întreruptorul și cele mai multe din părțile mobile. În acest sistem cu piesele polare ale volantului se asociază un transductor electromagnetic celelalte componente fiind un amplificator cu tranzistoare, un generator de scînteii și un distribuitor de înaltă tensiune.

Ce alte utilizări mai are tranzistorul în automobile?

El mai poate fi utilizat în transmisii automate, controlul sistemelor de aer condiționat și sistemele de injecție. Există multe posibilități de folosire a tranzistoarelor și diodelor în echipamente pentru garaje. Ceasul tranzistorizat reprezintă o altă aplicație. Ceasuri de acest tip, proiectate să funcționez timp de un an cu ajutorul unei baterii uscate mici, se folosesc de cîtva timp în locuințe.

Cum funcționează dispozitivele sensibile la lumină în automobile?

Un exemplu recent îl constituie oglida retrovizoare antiorbitoare folosită în timpul nopții. Asemenea oglinzilor reglate manual aceasta este de tip prismatic. La acest nou model o fotocelulă, care detectează strălucirea vehiculelor din spate, este conectată la un ansamblu ce cuprinde trei tranzistoare. Curentul amplificat acționează un solenoid care la rîndul său mișcă oglinda.

Un alt dispozitiv folosește fotocelula pentru a comanda aprinderea luminilor laterale sau de parcare conform cu condițiile de lumină naturală. O altă aplicație posibilă, destul de dificilă și neexploatăată încă, o constituie manevrarea automată a farurilor.

Cum se poate obține o tensiune înaltă de la bateria de automobile?

Sursa de înaltă tensiune se poate construi cu ușurință folosind un convertor tranzistorizat. În fig. 58 se reprezintă un astfel de convertor. El este proiectat să producă la ieșire o tensiune continuă de 300 V și un curent până

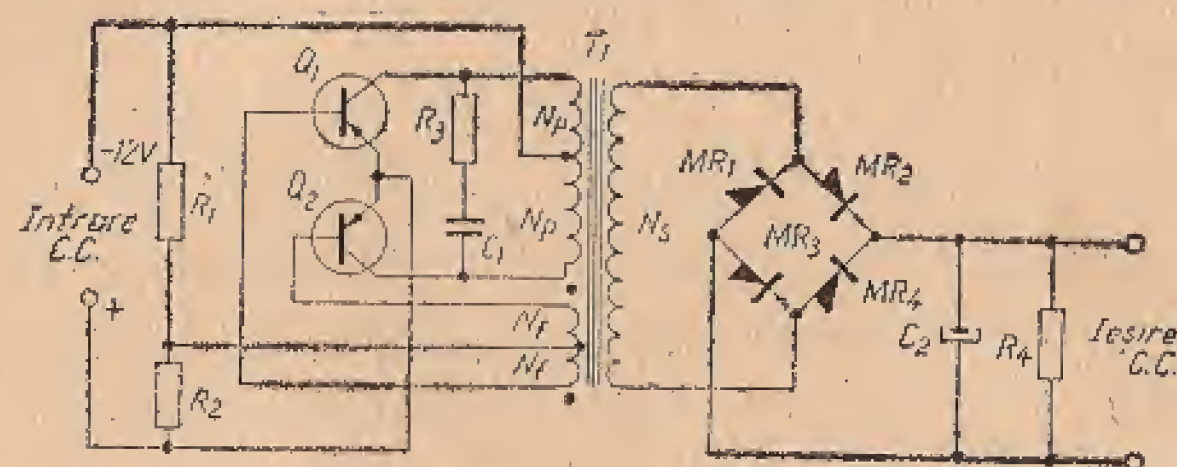


Fig. 58. Convertor c.c./c.c. de la 12 V la 300 V.
 Q_1 NKT 402 R_1 25 Ω toleranța rezistențelor 10%
 Q_2 NKT 402 R_2 1 Ω
 C_1 4 μ F R_3 7,5 Ω
 C_2 32 μ F (350 V) R_4 22 K Ω (2 W)

la 130 mA primind la intrare o tensiune continuă de 12 V. Ieșirea unui oscilator push-pull de undă patratică de 12 V se cuplează prin transformator pentru a obține o tensiune de formată patrată de 300 V. Aceasta este redresată și filtrată printr-un capacitor electrolitic C_2 .

Se pot folosi tranzistoarele în căile ferate?

Una din aplicații o constituie sistemul de control automat al trenului, în care semnalele trimise din diferite puncte ale liniei pot purta informații despre trecerea trenului. În acest echipament se folosește antimoniura de indiu. Această substanță prezintă efectul Hall: dacă în apropierea sa se aduce un câmp magnetic în timp ce trece un curent electric, apare o tensiune electrică. O altă apli-

cație o constituie semnalizarea; scopul acestei aplicații este înlocuirea metodelor electro-mecanice cu metode cu calculatoare.

Cît de mult se folosesc semiconductoarele în cercetarea spațială?

Unele din cele mai avansate dispozitive semiconductoare sînt folosite în sateliții artificiali. Cercetările spațiale, cum ar fi studiul ionosferei, implică o varietate largă de instrumente, iar metodele actuale sînt atît de avansate încît o sumă mare de instrumente pot fi cuprinse într-un container mic. Echipamentul folosește mult sute de tranzistoare, precum și celulele solare pentru încărcarea bateriilor. Un satelit de comunicații este foarte complex fiind proiectat să recepționeze, rețină, amplifice și retransmită semnalele.

Componentele și circuitele miniaturizate sînt folosite în spectrometre, numărătoare pentru măsurarea dimensiunilor particulelor, telemetre, magnetofone și multe alte aparate.

Calitatea componentelor și construcția lor trebuie să fie astfel încît certitudinea performanțelor să poată fi asigurată în condiții dificile, cum ar fi spre exemplu frecvențele de vibrație mari, variațiile mari de temperatură și accelerațiile ce nu se întîlnesc în alte aplicații. Circuitele microminiaturizate, menționate în alte lucrări, au o contribuție hotărîtoare.

Sateliții contribuie la prevederea vremii, și multe succese sînt posibile acolo unde se poate asigura o cooperare internațională pentru înregistrarea și interpretarea datelor. Metodele simple din prezent se spune că nu sînt adecvate. Succesele ar depinde de dezvoltările tehnicii calculatoarelor și tehnologiei compactizării.

O cale ar implica sateliți, care să culeagă imagini succesive și transmise stațiilor de la sol. O altă posibilitate o reprezintă dezvoltarea balizelor meteorologice automate ancorate în aceane; acestea ar transmite datele spre sateliți, care ar prezenta imagini ale configurației norilor. Toate datele astfel obținute ar fi utilizate de sateliți pentru cunoașterea vremii, care ar fi transmisă spre pământ în ajutorul tuturor țărilor.

În acest sistem fiecare satelit ar cuprinde un calculator foarte mic pentru analiza datelor și în consecință pentru previziuni. Se crede că ramurile noi ale tehnologiei ar putea produce în prezent tipurile speciale de circuite microminiaturizate și dispozitivele semiconductoare necesare. Ar fi necesară o sursă de energie îmbunătățită, posibil un generator nuclear.

Se folosesc tranzistoarele în medicină?

Posibilitățile de folosire a tranzistoarelor în medicină sînt de curînd explorate, dar există deja realizări notabile.

Există a varietate de instrumente atît pentru diagnosticare cît și pentru cercetare. Acesta în mod obișnuit ajută la studiul comportării sau stării organismului, spre exemplu obstetricienii folosesc instrumente miniaturizate pentru observarea bătăilor inimii fătului. Instrumentele electronice sînt folosite în sălile de operație pentru măsurarea presiunii sîngelui, respirației, temperaturii și alte măsurări fundamentale.

Dispozitivele fotoelectrice sînt importante, spre exemplu, în analizele biochimice. O metodă de măsurare a bătăilor inimii folosește un tranzistor și o sursă de lumină atasată pe un lob al urechii.

Contribuția principală a dispozitivelor semiconductoare se află în miniaturizarea echipamentelor. Instrumentul de măsură trebuie purtat de om și prin urmare dimensiunile mici și greutatea sînt esențiale. Probabil cel mai spectaculos exemplu îl constituie pilula radio care conține, într-o capsulă lungă de 2 cm și 1 cm diametru, un oscilator, antenă, tranzistor, bateria precum și alte componente. Această pilulă se înghite și transmite informații din interiorul organismului privitoare la temperatură, aciditate, presiune și alți factori. Frecvența radiației poate varia în acord cu schimbarea condițiilor din interiorul pacientului.

Un alt exemplu de miniaturizare îl constituie dispozitivul folosit pentru anumite afecțiuni cardiace. Un receptor tranzistorizat poate fi inserat în mușchii inimii unui pacient a cărui inimă bate neregulat. Acest simulator electronic este comandat de un emițător tranzistorizat, purtat în exterior. Se impune o înaltă siguranță de funcționare deoarece este necesar ca acest dispozitiv să fie lăsat în această poziție pentru mulți ani.

Amplificatoarele fiziologice proiectate pentru controlul electric al pacienților, sînt mai folositoare dacă sînt alimentate de la baterie și prin urmare sînt mai ușor de purtat. Tranzistoarele au permis dezvoltări substanțiale în proiectarea acestor instrumente. De asemenea, circuitul cu tensiune mică este mai sigur. Există totuși dificultatea că un astfel de amplificator are în mod obișnuit o impedanță de intrare mică, iar impedanța sursei (pacientul) în condiții normale de lucru este mare. Tranzistorul cu efect de cîmp va asigura condiția de intrare impusă, și prin urmare s-au creat echipamente ce folosesc o combinație hibridă de tranzistoare.

Bliț tranzistorizat

Tranzistoarele pot asigura energia unui bliț electronic de tip profesional. Circuitul din figura 59 este alimentat de la o baterie de 6 V și este proiectat pentru a realiza o energie de 40 J la o tensiune de 500 V.

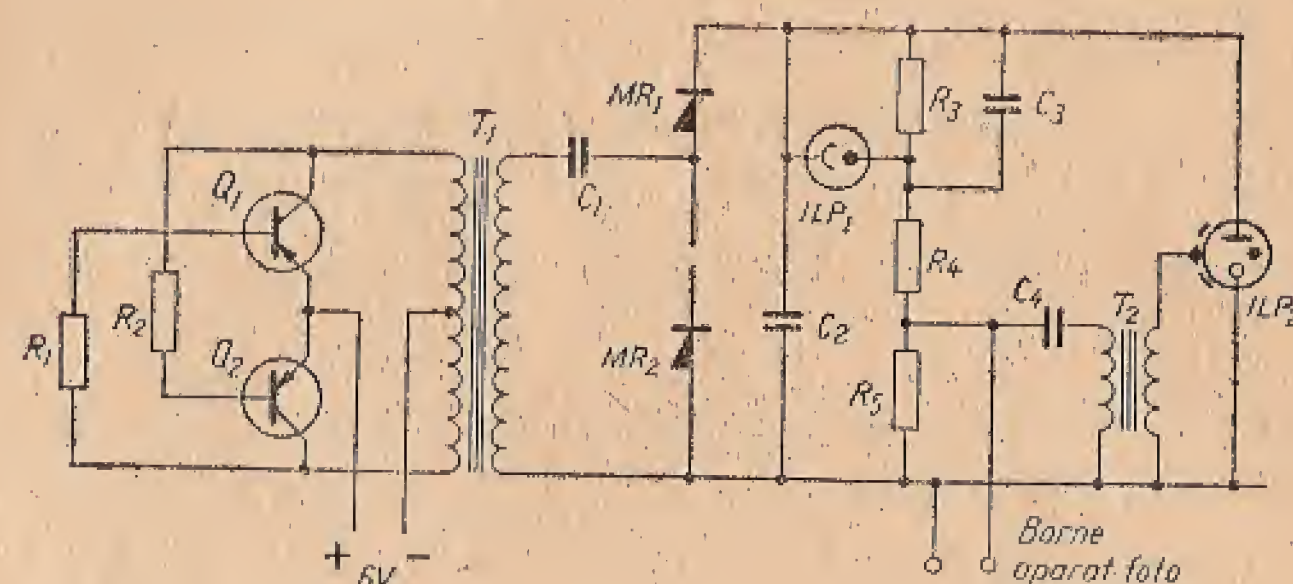


Fig. 59. Bliț de 40 J la 6 V:

Q_1 NKT 404	C_1 10 μ F(500 V)	R_1 22 Ω (1 W)
Q_2 NKT 404	C_2 500 μ F(500 V)	R_2 22 Ω (1 W)
MR_1 dublor de tensiune	C_3 0,05 μ F	R_3 1,5 M Ω
MR_2 500 V	C_4 0,25 μ F	R_4 3,3 M Ω
		R_5 3,3 M Ω

Tensiunea de 500 V este atinsă în aproximativ 40 s. Când blițul este încărcat se aprinde lamp cu neon. Sursa de alimentare este formată dintr-un convertor push-pull auto-oscilant care produce la ieșire 250 V și ridicată apoi la 500 V (printr-un circuit de dublare a tensiunii).

Acest circuit este adecvat pentru orice aparat de fotografiat prevăzut cu contacte potrivite. Când se închid contactele, capacitatea C_4 se descarcă prin transformatorul T_2 ; acesta induce o tensiune mare în secundar care aprinde lampa. Energia înmagazinată în C_2 se eliberează prin lampă realizând o iluminare intensă.

Ce fel de baterii se folosesc în echipamentele miniaturizate?

Adesea se impune o anumită proiectare a bateriilor, care trebuie să îndeplinească cerințe speciale, cum ar fi spre exemplu în echipamentele militare, care lucrează în condiții deosebite. Pentru tipurile mai familiare de produse tranzistorizate mici (spre exemplu aparate de auzit) o contribuție deosebită o au celulele cu oxid de argint.

Acest tip de celule au o impedanță mică și uniformă, caracteristică bună la temperaturi mici și o caracteristică de descărcare foarte liniară, adică, tensiunea este constantă în timp. Unele versiuni ale celulei pot cântări numai o mică fracțiune dintr-o uncie (28 gr). Această celulă este foarte bună pentru alimentarea tranzistoarelor cu siliciu.

De asemenea, tensiunea la bornele acestui tip de celulă este mai mare decât la celula cu mercur, un alt tip de baterie miniatură bine cunoscut. Tensiunea în gol este de 1,6 V; pentru un consum tipic de curent această tensiune scade la 1,5 V comparativ cu 1,3 V pentru o celulă cu mercur în condiții similare.

Celula cu oxid de argint este formată dintr-un catod de oxid de argint depolarizant, un anod de zinc cu suprafața mare și un electrolit alcalin puternic. La aparatele pentru auz celula are ca electrolit hidroxidul de potasiu, care asigură o densitate de putere maximă la curenți mici. La celulele extrem de mici folosite la ceasuri, pentru a asigura un termen lung de funcționare în condiții bune, se folosește hidroxidul de sodiu.

Pentru echipamentele miniatură se folosesc de asemenea celulele cu indiu-bismut. În sateliții spațiali se folosesc uneori baterii cu cadmiu-nichel care au capacitatea de reîncărcare de la bateriile solare. Acest tip de baterii, se construiesc adesea sub formă miniaturizată și pot asi-

gura curenți mari avînd reputația unor performanțe foarte bune la temperaturi foarte mici.

Receptoarele de televiziune necesită de asemenea baterii. Există baterii de 12 V care cu un circuit special de stabilizare pot produce un curent de 0,25 A pentru 40 ore în cazul în care se folosesc aproximativ 2 ore pe zi.

Tester pentru tranzistoare

Montajul din fig. 60 poate fi folosit pentru o bună verificare a amplificării tranzistoarelor.

Cu tranzistorul ce urmează a fi măsurat conectat și cu C_1 închis, instrumentul va indica curentul de colector

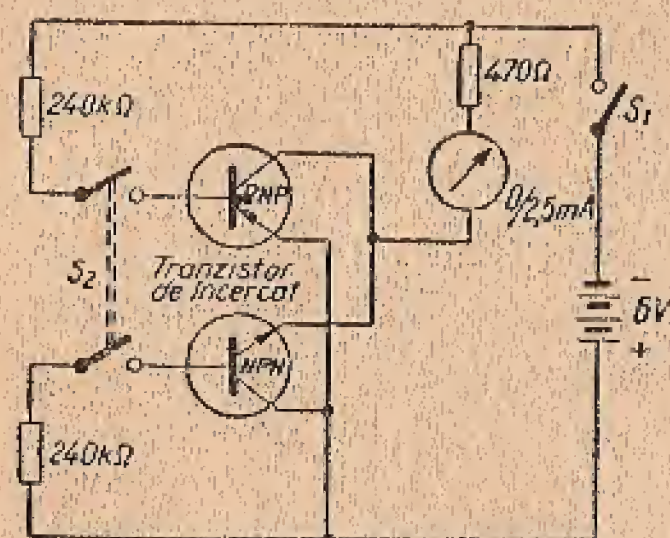


Fig. 60. Circuit pentru verificarea amplificării tranzistoarelor pnp și npn.

rezidual. Apăsînd pe comutatorul S_2 se aduce un curent de 0,25 μ A pe baza tranzistorului; prin calibrarea instrumentului astfel încît la capătul scării să avem o amplificarea de 100 atunci amplificarea tranzistorului poate fi citită direct.

8

r.tv. r.tv. r.tv. r.tv. r.tv.

Depanarea echipamentelor tranzistorizate

Care sînt cele mai frecvente defecte în echipamentele tranzistorizate?

Tranzistoarele sînt robuste și dacă lucrează în condiții corecte, ele însele sînt rare ori, cauza unor defecte în echipamentele tranzistorizate cu toate că și ele pot determina defecte prin întreruperea unor componente asociate. În echipamentele electronice mai frecvente decît defectele electronice sînt defectele mecanice cum ar fi contactele de comutație nesatisfăcătoare, contactelor cu arc „obosit” din jec, potențiometrele de volum zgomotoase, componentele desprinse din cablaj, întreruperile conductoarelor de antenă și antenele cu ferită fisurată. Cele mai răspîndite defecte electronice sînt din partea bateriei, scurgerilor capacitivelor. Întreruperea funcționării echipamentelor alimentate de la baterie poate fi determinată în primul rînd de baterie.

Există vreo metodă de verificare a bateriei?

O metodă utilă este mai întîi măsurarea tensiunii la bornele sale V_1 apoi introducerea între borne a unui rezistor de 100 Ω și se măsoară din nou tensiunea V_2 . Curentul I în mA absorbit de la baterie este $10 \times V_2$ iar rezistența internă a bateriei poate fi calculată cu formula următoare:

$$\frac{V_1 - V_2}{I} \times 1000 = \text{rezistență internă a bateriei } (\Omega).$$

O baterie bună va avea o rezistență internă de aproximativ $10\ \Omega$.

O baterie cu o rezistență internă pînă la $50\ \Omega$ poate fi bună pentru o rezistență internă de valoare mai mare ea trebuie înlocuită.

Cum se procedează după verificarea bateriei?

Se recomandă mai întîi o verificare atentă a defectelor mecanice sau contactelor reci. Dacă totul este în ordine, se izolează etajul defect printr-o încercare sistematică de la ieșire spre intrare, folosind un generator de semnal de testare nu prea puternic (preferabil cu un rezistor de $47\ k\Omega$ în serie pentru limitarea semnalului) și un voltmetru cu rezistență mare pentru verificarea tensiunilor bateriei, colectorului, emitorului etc. Curentul de emitor, și deci curentul de colector care este aproximativ același, poate fi aflat cu ajutorul legii lui Ohm împărțind tensiunea la bornele lui R_1 (fig. 61) prin rezistența R_1 . Să zicem că tensiunea este de $0,5\ V$ sau R_1 este de $100\ \Omega$, atunci curentul de emitor va fi $0,5/100\ A$ sau $5\ mA$.

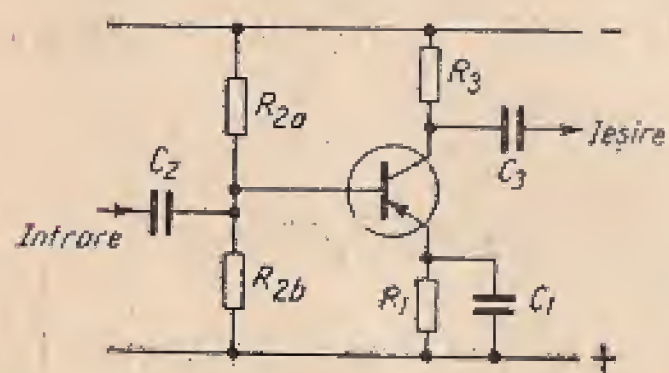


Fig. 61. Amplificator pentru depanare.

Dacă este zero, tensiunea emitorului va fi zero iar tensiunea colectorului va fi egală cu tensiunea de alimentare. Dacă tensiunea bazei este foarte mică sau zero, fie că R_{2a} este desfăcută fie R_{2b} este scurtcircuitată. Dacă

tensiunea bazei este corectă atunci R_1 poate fi desfăcută. Dacă R_3 este desfăcută tensiunile de emitor și colector vor fi mici.

Dacă curentul de colector este mic, tensiunea emitor-bază va fi de asemenea mică întrucît: (a) — tensiunea de bază este mică pentru că R_{2a} este mare sau R_{2b} este mică, (b) — tensiunea de emitor este mare deoarece R_1 este mare sau în circuit deschis.

Dacă curentul de colector este mare, tensiunea emitor — bază va fi mare întrucît: (a) — tensiunea bazei este mare deoarece R_{2a} este mică, R_{2b} mare sau C_2 are pierderi; (b) — tensiunea de emitor este mică deoarece R_1 este mică sau C_1 are pierderi.

Ce precauții trebuie luate la depanarea echipamentelor tranzistorizate?

Să nu se efectueze niciodată măsurători asupra rezistențelor sau încercarea continuității circuitelor cu un ohmmetru ce are la ieșire o tensiune mai mare de $1,5\ V$; ciocanul de lipit și toate aparatele de testare trebuie conectate la o masă comună bună; sursa de alimentare trebuie oprită sau deconectată înainte de înlocuirea oricărui componente. Înainte de înlocuirea unui tranzistor trebuie verificate componentele asociate acestuia.

Sursa de alimentare trebuie oprită sau deconectată înainte de a face lipituri și trebuie totdeauna folosit un radiator împreună cu ciocanul de lipit. Trebuie verificate conexiunile tranzistorului înainte de conectarea lui în circuit, și să nu se scurtcircuiteze terminalele tranzistorului; aceasta se poate întîmpla cînd se folosește șurubelnița sau capetele de măsură. Cel mai important este să se observe polaritatea sursei în momentul conec-

tării. Tranzistorul nu trebuie lipit sub 1,5 mm față de cablaj. Deoarece cele mai multe tranzistoare sînt sensibile la lumină, sînt protejate printr-un strat opac care nu trebuie deteriorat.

Un tranzistor defect poate fi foarte fierbinte și deci inutilizabil.

Nu folosiți numai tetraclorură de carbon sau triclor-etilenă pentru curățarea contactelor comutatoarelor sau potențioanelor deoarece acești agenți de curățire sînt corozivi.

Datorită metodei folosite — întrebări cu răspunsuri — lucrarea este foarte utilă pentru toți cei ce vor să se inițieze în domeniul dispozitivelor semiconductoare. Sunt tratate într-un mod concis trăsăturile caracteristice ale tranzistoarelor precum și ale altor dispozitive ce utilizează materiale semiconductoare. În continuare sunt evidențiate — adeseori prin exemple practice — o mare parte din aplicațiile acestor dispozitive atât în echipamente domestice cât și în cele industriale.

Lucrări de electronică în pregătire

Seria „Electronică aplicată”

Sofron, E.	Dispozitive optoelectronice cu cristale lichide
Târâcă, Șt.	Tranzistoare unijuncțiune
Constantin, P.	Aparate electronice pentru protecția muncii
Radu, O.	
Scărlătescu, M.	
Manea, A.	

Seria „Inițiere”

Săvescu, M.	Inițiere în radiocomunicații prin sateliți
-------------	--

Colecția „Radio și televiziune”

Brown, Cl.	Tranzistoare. Întrebări și răspunsuri
Hellyer, H. W.	Radio și televiziune. Întrebări și răspunsuri
Brown, Cl.	Audio. Întrebări și răspunsuri

